学位論文 博士(工学)

湿式化学合成プロセスによる チタン酸ナノ結晶の合成と 電子デバイスへの応用

2013 年度

慶應義塾大学大学院理工学研究科

竹澤 洋子

目礼	欠
----	---

第1章 緒言	1
1.1 背景	2
1.2 セラミックスの液相合成	3
1.2.1 液相合成法の位置付け	
1.2.2 液相合成法による結晶形成メカニズム	
1.2.3 液相合成法による結晶形態制御	
1.3 高分子ゲルを反応場とした結晶成長	9
1.3.1 高分子ゲルの性質と反応場としての可能性	
1.3.2 ゲルマトリクスを用いた結晶成長に関する研究	
1.4 二酸化チタン	14
1.4.1 二酸化チタンの構造と物性	
1.4.2 二酸化チタンの合成方法	
1.4.3 二酸化チタンの実用化に向けた応用	
1.4.4 二酸化チタンの形態制御	
1.5 チタン酸	20
1.5.1 チタン酸の構造とその特徴を活かした形態制御	
1.5.2 各種デバイスへの応用	
1.6 チタン酸バリウム	22
1.6.1 チタン酸バリウムの構造と物性	
1.6.2 チタン酸バリウムナノ結晶の合成方法	
1.6.3 MLCC 材料としてのチタン酸バリウム結晶	
1.7 チタン酸バリウム誘電体薄膜	26
1.7.1 誘電体薄膜の形成方法と現状	
1.7.2 ナノ粒子堆積法を用いた誘電体薄膜の形成	

1.8 本研究の概要と意義	32
1.9 本研究の構成	34
参考文献	36
第2章 寒天ゲルを用いた層状チタン酸の合成	40
2.1 はじめに	41
2.2 実験方法	42
2.2.1 原料 2.2.2 実験毛順	
2.2.2 吴硕子顺 2.2.3 評価	
2.3 実験結果と考察	44
2.3.1 寒天ゲル内に得られるマクロな形態への影響	
2.3.2 寒天ゲル内に得られるチタン酸のミクロな形態への影響	
2.3.3 新規デタン酸テノシートの構造 MM 2.3.4 チタン酸ナノシート 届間への 有機 色素の 道入	
2.3.5 熱処理によるチタン酸ナノシートの構造変化	
2.3.6 チタン酸ナノシートを使用したチタン酸バリウムへの転換	
2.4 結論	62
参考文献	63
第3章 溶解度制御による層状チタン酸の形態コントロール	64
3.1 はじめに	65
3.2 実験方法 3.2.1 原料	66

- 3.2.2 実験手順
- 3.2.3 評価

3.3 実	医験結果と考察	68
3.3.1	アンモニアを用いた場合	
3.3.2	水酸化ナトリウムを用いた場合	
3.3.3	ヘキサメチレンテトラミンを用いた場合	
3.3.4	尿素を用いた場合	
3.3.5	まとめ	
3.4 結	論	76

参考文献

77

79

第4章 ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成 78

- 4.1 はじめに
 - 4.1.1 高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ粒子の合成
 - 4.1.2 高濃度ゾルゲル法による チタン酸バリウムナノクリスタル形成メカニズムの解明
 - 4.1.3 高濃度ゾルゲル法で得られるチタン酸バリウムナノ粒子の特長
 - 4.1.4 メカニズムから予想される安価な合成法の可能性
- 4.2 実験方法
 4.2 実験方法
 4.2.1 原料
 4.2.2 実験手順
 4.2.3 評価
 4.3 実験結果と考察
 4.3.1 バリウム後添加による生成物への影響
 4.3.2 チタン源の変更による生成物への影響
 4.3.3 バリウム源の変更による生成物への影響

4.4 結論

第5章 Mn 添加チタン酸バリウムナノ結晶から	
作製した誘電体薄膜の微細構造および特性評価	98
5.1 はじめに	99
5.2 実験方法	102
5.2.1 原料	
5.2.2 実験手順	
5.2.3 計1回	
5.3 実験結果と考察	105
5.3.1 Mn 添加チタン酸バリウムナノクリスタルのキャラクタリゼーション	
5.3.2 Pt 電極上における Mn 添加チタン酸バリウム薄膜の構造と誘電特性	
5.3.3 Cu 電極上における Mn 添加チタン酸バリウム薄膜の構造と誘電特性	
5.4 結論	125
参考文献	126
第6章 チタン酸バリウムナノ結晶から作製した	
誘電体薄膜のホウ素添加による微細構造制御	
および特性評価	127
6.1 はじめに	128
6.1.1 スピンコート回転数・スラリー濃度に着目した Cu 変形の抑制検討	
6.1.2 焼結助剤の添加による粒成長の促進と Cu 変形の抑制	
6.2 実験方法	134
6.2.1 原料	
6.2.2 実験手順	
6.2.3 評価	

6.3 実験結果と考察	137
6.3.1 ホウ素同時添加チタン酸バリウムナノクリスタルの	
キャラクタリゼーションおよび薄膜形成	
6.3.2 ホウ素-Mn 添加チタン酸バリウム薄膜形成	
6.4 結論	152
参考文献	153
第7章 結言	154
7.1 本研究で得られた成果	155
7.2 今後の課題と展望	159
本研究に関連する論文	161
謝辞	162

第1章

緒言

第1章 緒言

1.1 背景

近年、「ナノテクノロジー」は現実のものとして我々の生活を豊かにしている。テレビや パソコンの薄型化、携帯電話の小型化・高機能化など、ナノテクノロジーが果たした功績は 計り知れない。材料合成分野においても同様に、サイズや形態が自在に制御されたナノ物 質を合成する技術が確立し、サイズ効果や表面積の効果による材料機能強化が図られてい る。しかしながら、目的のものさえ製造できれば良いという時代は終わり、ますます進む 環境破壊を抑制しつつ、さらに高機能化されたナノ材料を合成する技術が求められている。

ここで、自然界に存在する骨や歯、貝殻などの生物に着目する。これらは、温和な環境 下で自己組織化を基礎としたボトムアップアプローチにより無機物質を形成している。さ らに形態に目を向けると、ナノスケールからマクロスケールに渡って緻密に制御された階 層的構造を取っており、それぞれの形態特有の優れた機能を発現することが確認されてい る。こうした生物の形態形成プロセスを模倣して無機材料合成を行い、新たな機能性材料 を構築しようと、「バイオミメティック材料プロセス」が見出された。この方法は、常温・ 常圧という温和な条件下での反応を基礎とすることから、環境調和型プロセスとして、さ らには、3次元に渡る緻密な構造体形成プロセスとして注目されている。多数の科学者によ るこれまでの研究から、バイオミメティックプロセスを用いることにより炭酸塩やリン酸 塩などのバイオミネラル類似体を人工的に作製することに成功し、さらに、形態形成メカ ニズムが解明されつつある。こうして得られたメカニズムを基に、バイオミネラルを超え た各種機能性材料への応用、実用化が期待される段階にまで研究は達した。

本研究では、バイオミメティック材料合成法のひとつとして、溶液プロセスによる機能 性無機材料の合成に着目し、検討を進めている。溶液プロセスによる無機材料合成に関し ては古くから研究が行われているが、近年、ナノスケールにおける形態制御が可能な合成 法として発展が期待されている。実際に、反応場や溶解度を制御することで、金属酸化物 のナノ構造がコントロールされ、その構造特有の機能が発現されるなど、実用性の高さが 示されている。本研究では、研究対象の材料として、二酸化チタン・チタン酸・チタン酸 バリウムを掲げた。いずれも優れた無機材料であり、光触媒やコンデンサーなど、多方面 で実用化されている。これらの材料に関して、特に、合成における反応場や原料種類・原 料濃度などが与える形態への寄与を明らかにすることで、溶液プロセスによるこれら材料 の形態形成メカニズムの確立を試みた。また、得られた材料のデバイス評価を行うことで、 本研究の実用性の高さを示したいと考えている。

1.2 セラミックスの液相合成

1.2.1 液相合成法の位置付け

様々なセラミックスが、多様な合成方法を用いることにより得られている。セラミック ス粒子の合成法は、固相法、液相法、気相法に分類される。固相法は、安価に合成できる 手法として工業的にも利用されているが、微細化には限りがあり、現状では数十 nm オーダ ーが限界である。これに対し、粒子径の揃ったナノオーダーの粒子合成には、ボトムアッ ププロセスである気相法や液相法が有利である。気相法は、高純度かつ小粒径粒子が作製 できることから、広く使われている。しかしながら、生成粒子が凝集体であることや、化 学的に均一な多成分系材料の合成には原料の選択が難しいなどの問題点がある。一方、液 相法は、多成分系材料を合成する際の原料を溶液中で調整できるので、分子レベルで原料 の混合が可能であるばかりでなく、サイズや形態の制御が容易に行えるというメリットを 有する。液相法は、使用する溶媒や原料、合成段階における熱や圧の掛け方により、水溶 液からの結晶成長法やゾルゲル法、ソルボサーマル法、水熱法、超臨界水熱法など、多様 な方法に分類される(Table 1-1)。それぞれの合成法により、得られる粒子の特徴が異なる。 例えば、水溶液からの結晶成長法は、自然界に存在するバイオミネラルと同様に、高温で の熱処理を必要とせずに目的の粒子を得る方法であり、バイオミメティック合成法として 最も優れた合成法と言える。低温で結晶成長が行われるため、形態制御のための有機添加 剤などの分解を抑制することができ、合成段階における形態制御が容易に達成される。ま た、ゾルゲル法は、原料のコストとしては問題点を有するが、粒子形成のメカニズムが確 立されており、近年では高濃度ゾルゲル法という新たな手法が見出されるなど、いまだ魅 力的な合成法として研究が進められている。高濃度ゾルゲル法を用いることにより、熱処 理を必要とすることなく、シングルナノスケールの高結晶粒子が得られるなど、その結晶 成長メカニズムに学ぶことは多い。以上のように、液相法は、ナノメートルオーダーでの 粒子径・粒子形態制御が可能な材料合成法として、非常に期待される合成法である。

Synthesis methods	Title	References
Low temperature synthesis in aqueous solution	 Crystal phase control for metal oxide films grown in aqueous solution 	1.1
	 Biomimetic approach for exact control of TiO₂ periodic microstructures 	1.2
	•Growth of Submicrometer-Scale Rectangular Parallelepiped Rutile TiO ₂ Films in Aqueous TiCl ₃ Solutions under Hydrothermal Conditions	1.3
	 Crystal phase control for titanium dioxide films by direct deposition in aqueous solutions 	1.4
Sol-gel synthesis	 Synthesis of hexagonally packed mesoporous TiO₂ by a modified sol–gel method 	1.5
	 Sol–gel preparation and photocatalysis of titanium dioxide 	1.6
	•Microstructure of nanosized TiO ₂ obtained by sol- gel synthesis	1.7
	 Sol-gel synthesis of barium titanate powders using barium acetate and titanium(IV) isopropoxide 	1.8
Solvothermal synthesis	 Subcritical solvothermal synthesis of condensed inorganic materials 	1.9
	 Morphological control in solvothermal synthesis of titanium oxide 	1.10
	 Synthesis of nanocrystalline TiO₂ in toluene by a solvothermal route 	1.11
	 Solvothermal synthesis of perovskites and pyrochlores: crystallisation of functional oxides under mild conditions 	1.12
Hydrothermal synthesis	 The role of hydrothermal synthesis in preparative chemistry 	1.13
	·Hydrothermal synthesis of fine oxide powders	1.14
	 Hydrothermal synthesis of advanced ceramic powders 	1.15
	 Review of titania nanotubes synthesized via the hydrothermal treatment: fabrication, modification, and application 	1.16
Supercritical hydrothermal synthesis	 Hydrothermal synthesis of metal oxide nanoparticles in supercritical water 	1.17
	 Hydrothermal synthesis of metal oxide fine particles at supercritical conditions 	1.18
	 Hydrothermal synthesis of metal oxide nanoparticles at supercritical conditions 	1.19
	 Rapid and continuous hydrothermal crystallization of metal oxide particles in supercritical water 	1.20

 Table 1-1. Solution phase syntheses of several metal oxide.

1.2.2 液相合成法による結晶形成メカニズム

結晶が形成され成長するためには、駆動力が必要である。液相合成法における結晶形成の駆動力は、過飽和度 σ である。圧力一定の場合、物質の飽和濃度は温度とともに増加し、 Figure 1-1 に示すように各物質固有の溶解度曲線に従って溶解度が決まる。結晶を析出させるためには、溶解している溶液の温度を下げるなどして、溶解度曲線よりも濃度が高い状態にする必要がある。ただし、溶解度曲線のすぐ下側には準安定領域が存在し、この領域では結晶核は形成されず、過飽和曲線を超えて濃度を上げなければならない。ある温度における溶液の濃度をC、その溶液の溶解度をC*とすると、過飽和度 σ は $\sigma = (C - C^*)/C^*$ で表され、この値が大きいほど、結晶形成の駆動力が大きいということになる。



Figure 1-1. Saturation curve and supersaturation curve.

過飽和溶液中に溶質分子が形成されると、それらが凝縮と離脱を繰り返し、クラスター と呼ばれる会合体が得られる。さらに凝縮と離脱を繰り返し、ある半径r*(臨界半径)以上 に大きなクラスターが形成されて初めて核形成が起こったとみなせる。臨界半径以上の大 きさにまで到達した核があると、それは、自由エネルギーが減少する方向に成長し続ける。 このときの系の自由エネルギー変化は次式で表され、Figure 1-2 に示すような曲線で表され る。ここで、vはクラスター中の分子の体積、 $\Delta \mu$ は溶液と結晶の化学ポテンシャルの差、 γ は固液間における界面エネルギーを示している。

$$\Delta G(r) = -\frac{4\pi r^3}{3\nu} \Delta \mu + 4\pi r^2 \gamma$$

上式の第一項は核生成によるバルク自由エネルギーの利得、第二項は表面自由エネルギー の不利を表す。つまり、過飽和溶液中に生成したクラスターの自由エネルギー変化は、ク ラスターの体積に比例し、クラスターの表面積に反比例して安定化の方向に進む。二つの 項のせめぎ合いにより、ある半径で系の自由エネルギー変化量は最大値を取り、この半径 を臨界半径**r***と呼ぶ。臨界半径以下のクラスターは再溶解し、臨界半径以上のクラスター は粒成長へと進む。



Figure 1-2. Free energy change ΔG at nucleation.

上述した核形成理論は、異物の無い一様な環境相の中で核形成が起こる場合に限り成立 する。これを均一核形成と呼ぶ。これに対し、異物質の助けを借りた核形成を不均一核形 成と言う。不均一核形成は、あらかじめ異物質粒子が溶液内に存在する場合や、容器の壁 など平らな下地固体の上で核形成が起こる場合などに成り立つ。いずれも、均一核形成よ りも自由エネルギーは小さい。つまり、溶液内の異物粒子に分子が凝結すれば、自由エネ ルギー変化の山は初めから越えていることになり容易に核形成が起こる。また、器壁と核 の接触部分の分子の相互作用の結果、核の表面エネルギー不利の一部が現象し、自由エネ ルギーの山が均一核形成時よりも小さくなるため核形成が容易に起こる。

上述したように、均一核形成、不均一核形成いずれも、表面エネルギーの不利分を乗り 越えて臨界半径以上の大きさになった結晶核は、表面エネルギーの不利は感じずに成長を し続ける。この段階が結晶成長に当たる。結晶と溶液の間の界面で、原子・分子が結晶相に 取り込まれていく具体的な機構は、着目した界面の構造に依存する。また、界面の構造は 結晶表面の方位、温度、溶液の種類によって異なるので、成長機構には様々なパターンが ある。しかしながら、基本的には、いずれの種類の成長においても、結晶成長は、物質移 動過程、表面集積過程、伝熱過程の三つの速度過程で構成されている。溶質分子は、まず 溶液から結晶の表面に移動し(物質移動過程)、続いて結晶の表面で結晶格子に組み込まれ (表面集積)、最後にこの相変化に対応する結晶化熱が結晶表面から過飽和溶液に移動する (伝熱)。いずれも推進力は、溶液-結晶間の溶質の濃度差や温度差であり、核生成と同様に、 結晶成長過程においても制御するためには濃度・温度制御が重要であることが分かる。

最後に、結晶の形態がどのように決まるのか考える。結晶の形は、成長過程の差異により、平衡形と成長形の二つに大別される。平衡形は、球状結晶に見られ、表面積エネルギーを最小にすべく丸くなり形が定まる。ただし、結晶は異方性を持つため、球形になることは少なく実現しにくい。通常は、成長速度が結晶面によって異なることにより結晶の形態が決まる。つまり、成長の遅い結晶面は発達するが、成長の速い結晶面は小さくなるか 消滅してしまう。このような面成長速度の差で定まる形態を成長形という。さらに、成長形において、結晶面の大小関係が変化するだけの場合を晶癖変化(Crystal habit; Tracht)といい、 新たな面の出現や既存の面の消滅が見られる場合を晶相変化(Crystal habit; Habitus)という (Figure 1-3)。ただし、成長形を決める要因は面成長速度だけではなく、結晶構造にも大きく 依存する。



Figure 1-3. Crystal morphology formation.

さらに、過飽和度の高い溶液中での結晶成長の場合、結晶の界面は不安定な状態になり、 結晶の稜や角が優先的に伸び始め、多面体が維持できなくなって骸晶や針状結晶、樹枝状 結晶などが出現する。また、溶液中では、結晶表面は溶質分子の吸い込み口として働くの で、過飽和度は結晶から遠ざかるほど高い。したがって、多面体結晶の表面に沿って過飽 和度を見た場合、溶液側に一番深く突き出た部分である結晶の角の過飽和度が最も高く、 界面の中央の過飽和度が最も低くなる(Figure 1-4)。このような過飽和度の不均一によっても、 結晶形態の複雑化が進行する。



Figure 1-4. Heterogeneity of supersaturation ratio depended on crystal surface.

以上のように、液相合成法においては、溶液の過飽和度が非常に重要なパラメータとな り、核形成から結晶成長、形態決定にまで深く関わっている。つまり、過飽和度を如何に 制御するかが、結晶成長をコントロールするための支柱となることが、ここまでの結晶形 成メカニズムからわかる。

1.2.3 液相合成法による結晶形態制御

上述したように、液相合成法においては、溶液の過飽和度制御が重要なパラメータとな り、結晶形態が決まる。たとえば球状粒子の析出に関して言えば、温度や溶解度をどれく らいのスピードで下げるかにより、粒子径や粒度分布に大きな影響を与える。Figure 1-5 に 示すように、溶解度を緩やかに低下させることで過飽和度は緩やかに増加する。過飽和度 を超えた条件で結晶が核形成され、時間の経過とともに核形成と結晶成長が併発する。結 果的に、粒度分布が広く、平均粒子径が大きな粒子が得られることになる。それに対し、 溶解度を急速に低下させると、瞬時に極めて高い過飽和度が得られる。それにより、溶液 中に含まれる溶質の大半が結晶として多量に核形成される。したがって、溶質がほとんど 残らないため、結晶成長が進行せず、粒度分布が狭く、平均粒子径が小さな粒子が得られ る。以上のように過飽和度の制御により、得られる結晶の粒子径や粒度分布をコントロー ルすることが可能である。



Figure 1-5. Dependence of crystal size and distribution on down speed of temperature or slubility.

また、Oaki らは、結晶形態の制御方法として、高分子ゲルを拡散制御の場として使用す ることで、成長する結晶形態が多面体から分岐構造へ系統的に変化することを見出した^[1,21]。 ゲル化剤の密度を増加させることで拡散を抑制し、駆動力(過飽和度)を増加させたときと同 等の形態変化が実現可能となる。さらに、過飽和度制御だけでなく、外部因子(不純物)を使 用することによる形態制御も可能である。つまり、結晶の特異面にのみ吸着する分子を溶 液内に共存させることで、結晶の異方成長を促す。この方法を用いることで、結晶のナノ スケールでの形態制御ばかりでなく、集合状態のデザインも可能になるなど、実用性が増 す^[1,22,23]。

以上のように、様々な方法を用いることで、溶液の過飽和度制御・成長面制御が可能であ り、結晶形態のコントロールが実現する。本研究では、Oaki らの研究を基に、高分子ゲル を反応場として用いることでセラミックス粒子の形態制御を試みている。

1.3 高分子ゲルを反応場とした結晶成長

1.3.1 高分子ゲルの性質と反応場としての可能性

「ゲル」とは、高分子鎖同士が物理的・化学的に結合することでネットワーク構造を形成 し、溶媒を吸収して一定の堆積に膨潤したもののことを言う。一般的には、「あらゆる溶媒 に不溶で、三次元網目構造を有する高分子およびその膨潤体」と定義される。我々の身近 には、ゼリーやこんにゃく、寒天などの天然高分子に由来するゲルや、紙おむつや保冷剤、 芳香・消臭剤などに用いられている合成高分子に由来するゲルなどがあり、日常生活のあら ゆる場面で使用されている。

一方で、材料合成分野においては、高分子ゲルは複雑な構造を有するため、「反応場」と して用いられることがある。例として、イオン拡散現象を利用した材料合成技術が挙げら れる。ゲルの両端からカチオンとアニオンを浸透させ、両者が出会った場所でイオン性結 晶を得るという方法である(Figure 1-6)。さらに、ゲルを反応場として用いることで、ゲル内 の物質の拡散を制御できるだけでなく、ゲルを構成する分子との相互作用が関与すること で、粒子の形状までをも制御できるなどのメリットがある。本研究では、ゲルのこれらの 性質を利用して無機材料の合成を試みる。



Figure 1-6. Ionic diffusion phenomenon.

研究室レベルの実験では、天然高分子のゼラチンや寒天、合成高分子のポリアクリルア ミドやポリアクリル酸などが、反応場として多用される。その中で、本研究では、寒天を 反応場として用いた。その理由として、合成条件における寒天の耐性、反応への関与の乏 しさが挙げられる。合成高分子は、合成条件により多種多様な形・大きさを取り得るが、こ れを反応場として用いて無機材料の合成を行う場合、アミド基やカルボキシル基を官能基 として持つため、目的の結晶成長に大きく関与してしまう可能性がある。また、天然高分 子のゼラチンは、10 ℃以下の低温に保持しないとゲル状態を保持できない。それに対し、 寒天は、高温や低 pH には弱いが、本研究において使用する範囲内ではゲル状態を保持する ことが可能であり、反応場として適切に機能するため、最も適していると考えた。以下に、 寒天の構造と性質をまとめる。

寒天(agar agar)とは、紅藻類から抽出した親水性の凝固物質を乾燥したものである^[1-24, 25]。 寒天の成分はガラクトースを基本骨格とした多糖類からなり、アガロースと呼ばれる中性 多糖(Figure 1-7)とアガロペクチンと呼ばれるイオン性多糖に分類される。分子量は一般的に 数千~数万と考えられている。アガロースは水溶液中において、高温ではランダムコイル 状で存在しているが、低温ではダブルヘリックス構造の三次元ネットワークを形成し、ゾ ルからゲルへと転移する(Figure 1-8)。熱可逆性を有するが、一度ゲルになった状態から再度 水溶液にするためには、より高い温度まで上げる必要があるという特徴を有する。



Figure 1-7. Chemical structural formula of agarose.



Figure 1-8. Gelation mechanism of agar.

また寒天は pH による影響を受けやすく、酸により分解されて溶解してしまう。特に pH 3 以下ではゲル状態を持続できない (Figure 1-9)。逆に、アルカリ処理をすることでゲルの強 度は増す。上述したように、寒天はアガロースとアガロペクチンという 2 種の多糖によっ て成り立っている。このうちアガロペクチンはアガロースと同じ結合様式の骨格に硫酸エ ステル、ピルビン酸、メトキシルなどのイオン基を含む。そのためアガロペクチンはゲル 化能を持たない。しかし、アルカリ処理することにより硫酸基が抜けてイオン性が失われ ゲル化する (Figure 1-10)。これらのことより、高 pH では、寒天は安定なゲルとして存在す る。



Figure 1-9. Relationship of jelly strength ratio of agar to pH.



Figure 1-10. Desulfuration by alkali treatment.



Figure 1-11. Hydrogen bond formation by desulfuration.

1.3.3 ゲルマトリクスを用いた結晶成長に関する研究

高分子ゲルマトリクスを結晶成長の反応場として用いた研究例として代表的なものに、 リーゼガングバンドと呼ばれる周期沈殿構造形成に関するものが挙げられる^[1.26-28]。溶液を 過飽和にすると結晶化が起こり、沈殿が生じる。沈殿は通常多くの結晶粒子よりなる。リ ーゼガングバンド(Liesegang Band)とは、この結晶粒子の集合体が形成する周期的な沈殿構 造のことである。例えば、ニクロム酸カリウムを含有するゼラチンを平らなガラス板の表 面に塗り、その中央へ数滴の硝酸銀水溶液を滴下すると両試薬は反応して赤褐色のクロム 酸銀の沈殿を生じるが、その際滴下点を中心として同心円形の環紋となる。また、同様の ことを直立した試験管を用いて行うと、試験管内に上下に層状となって現れる。リーゼガ ングバンドの生成機構は古くから研究されており、過飽和理論や凝集理論などさまざまな 理論が打ち出されてきたが、それらはどれも未だ確立していない。以下では、その中でも オストワルドの過飽和理論に着目し、リーゼガングバンド生成のメカニズムについてまと める。

クロム酸銀(Ag₂CrO₄)の生成を例にリーゼガングバンド形成機構について考える。まず、 高濃度の銀イオン(Ag⁺)を含んだゼラチン溶液を上に、比較的低濃度のクロム酸イオン (CrO₄²⁻)を含んだゼラチン溶液を下に準備する。高濃度の銀イオンが下の溶液に拡散し、 「2Ag⁺ + CrO₄²⁻ → AgCrO₄」の反応によって周期沈殿(Ag₂CrO₄)を形成する。連続的な沈殿が 生じず不連続な沈殿構造となる原因は、Ag⁺と CrO₄²⁻の接触面での濃度積が関係する。Figure 1-12を基に考える。Ag⁺と CrO₄²⁻は二つの溶液の接触界面(X₀)でその濃度積 K が最大となっ て平衡積 K_cを大きく超える。したがって X₀で核生成・成長が始まり、沈殿が生じる。こ のとき CrO₄²⁻は低濃度のため、周囲の CrO₄²⁻を吸収し X₀での結晶成長に使用される。する と X₀のすぐ下方の CrO₄²⁻濃度が減少し、K<K_cとなるので、この部分では核生成が起こら ない。しかし、CrO₄²⁻に比べて高濃度の Ag⁺は X 方向に拡散することができ、ある距離を隔 てて CrO₄²⁻が充分に存在する X₁で K>K_cとなり、再び核生成・成長が始まる。このプロセ スが繰り返されることによって、不連続な場所でのみ沈殿が生じ、リーゼガングバンドの 形成に至る(Figure 1-13)。



Figure 1-12. Supersaturation theory of Ostwald.



Figure 1-13. Model figure of liesegang band formation.

以上のように、高分子ゲルを反応場として用いることで、反応物の拡散が制御され、マ クロ構造に特徴的な影響を与えることがわかっている。その他に、高分子ゲルのマトリク ス密度を制御することで、無機結晶のマクロ形態を多面体から骸晶を経て樹枝状へと形態 コントロールできること、対称性の低い結晶を高分子ゲル内で成長させることで、らせん 状形態を誘導できることなどが Oaki らにより解明されている^[1.29, 30]。また、生成物のマク ロ構造だけでなく、高分子ゲルの網目構造を使用することで、ミクロ構造にまで影響を与 えることが可能であるなど、高分子ゲルは、多大な可能性を持った反応場として機能し得 る。

1.4 二酸化チタン

1.4.1 二酸化チタンの構造と物性

本研究では、対象とする無機材料として、二酸化チタン、チタン酸、チタン酸バリウム を掲げる。以下、それぞれの物性や応用分野などをまとめる。

二酸化チタン(TiO₂)の結晶形には、アナターゼ(anatase)・ルチル(rutile)・ブルッカイト (brookite)の三種類が存在する。熱力学的にはルチルが全温度領域で安定相であり、酸化チ タンを高温下で熱処理すると、すべてルチル型の結晶になる。また、ブルッカイトはほか に比べて不安定であり、純粋な結晶を合成することは難しい。二酸化チタンの結晶構造は、 1 原子のチタンに 6 個の酸素原子が配位した八面体(TiO₆)を基本骨格として表される。アナ ターゼは基本単位の八面体の 8 つの稜(辺)のうち 4 稜を共有した構造を取っている。ブルッ カイトでは、この基本単位が 3 稜を共有している。ルチルは、基本単位の 2 稜を共有して c 軸方向に順次伸長して鎖状の結晶構造を取っている。

	D (il)	A	D I . I .
	Rutile	Anatase	Brookite
density (g/cm ³)	4.250	3.894	4.133
specific heat (J°C ⁻¹ ·mol ⁻¹)	55.06	55.52	
Mohs hardness	7.0 ~ 7.5	5.5 ~ 6.0	5.5 ~ 6.0
melting point (°C)	1870 (decomposition)	transition to rutile	transition to rutile
refractive index (nD) E//c	2.616	2.554	2.63
(589nm) E⊥c	2.903	2.493	2.63
relative permittivity	167 (//c)		
	86 (⊥c)	48	78 (//a)
bandgan (e\/)	3.06 (direct)	3.2	3.2
	3.01 (indirect)		
effective mass (hole)	20	1	
mobility (cm ² V ⁻¹ s ⁻¹)	1	4 ~ 20	
isoelectric point	5.6		

Table 1-2. Physical properties of titanium dioxide.



Figure 1-14. Crystal structure of titanium dioxide.

1.4.2 二酸化チタンの合成方法

二酸化チタンは、固相法や気相法、液相法など様々な手法を用いることで合成されている。いずれの方法においても、各種デバイスとしての期待値の高い二酸化チタンを、ナノレベルで形態・粒径制御し、高機能性材料として最適化することが求められている。固相法として代表的なものに金属窒化物の酸化がある。例えば、窒化チタン(TiN)を800℃程度

の温度で焼成することで二酸化チタンが得られる^[1,31]。熱処理に際し、添加物を加えること で結晶形の組成を制御することも可能となる。また、気相法としては、化学気相析出法 (CVD 法)^[1,32-35]や物理気相析出法 (PVD 法)^[1,36]が挙げられる。本研究では、液相法、特に「水 溶液からの結晶成長法」を採用することにより、二酸化チタン結晶の合成を行った。液相 法には、水溶液からの結晶成長法を始め、ゾルゲル法、マイクロエマルジョン法などの特 徴的かつ独創的な合成法が多数存在し、非常に盛んな研究分野である。以下、液相法とし て代表的なものをいくつか紹介する。

<ゾルゲル法^[1.39]>

微粒子二酸化チタンの合成法の代表的なものとして「ゾルゲル法」が挙げられる。金属 の有機化合物を出発原料として、溶液中の化合物の加水分解・重合反応によって、溶媒に金 属の酸化物あるいは水酸化物の微粒子が分散したゾルとし、さらに反応を進ませてゲル化 してできた非晶質である多孔質ゲルを加熱して結晶体を作る。二酸化チタン合成の際には、 チタンアルコキシドが金属化合物として用いられる。一般的に用いられているアルコキシ ドTi(OR)nには、Ti(OCH₃)4やTi(OC₂H₅)4、Ti(i-OC₃H₇)4、Ti(OC₄H₉)4などが挙げられるが、Rの 種類により、加水分解特性や重縮合特性、安定性が異なる。これらのチタンアルコキシド を加水分解反応・重縮合反応により水酸化物にし、熱処理を施して結晶性二酸化チタンを得 る。

<水熱反応法[1.40-42]>

加水分解反応を100 ℃以上で行う方法で、溶解度の低い結晶を高温、高圧下でいったん 溶解し、その溶液から改めて溶解度の低い結晶粒子を析出させる。水熱反応によって作製 された結晶粒子の特徴は、反応条件によって粒子の大きさや形が制御できること、特に大 きさや形のそろった微粒子が得られ、しかも結晶性がよく、格子ひずみが無いことなどが 挙げられる。

<逆ミセル法(マイクロエマルジョン法)[1.43-46]>

サイズ分布の狭い粒子を、凝集せずに孤立・分散した状態で大量に生成することが出来る 方法として逆ミセル法が挙げられる。親油性溶媒に少量の水と界面活性剤を添加すること で、ナノ粒子を自己形成し、また、逆相ミセルの大きさや数等も含水率、界面活性剤濃度、 有機溶媒濃度等により容易に調節できる。さらに、逆相ミセル内部に形成されるマイクロ メートルオーダーの水相(分散相)は各種の水溶性物質を溶解し、生成したナノ粒子を、 単純に逆相ミセルを破壊して回収しようとすると凝集する可能性が高い。凝集を抑制する にはポリマーや無機物質のマトリックスを添加して安定化または固定化する必要がある。 <金属アルコキシド法^[1.47-49]>

金属のアルコキシドを有機溶媒に溶解させ、これをオートクレーブ中で加熱することに よって金属酸化物を得ることができる。酸化チタンについては、HyCOM (Hydrothermal Crystallization in Organic Media)法^[1.47]、TD (Thermal Decomposition)法^[1.48]、THyCA (Transfer Hydrolytic Crystallization in Alcohols) 法^[1.49]の3種類がある。それぞれ反応原理が異なる。 HyCOM法では、トルエンなどの有機溶媒にチタンアルコキシドを溶解し、これをオートク レーブ内のガラス容器に入れ、ガラス容器とオートクレーブの隙間に水を入れる。内部を 窒素で置換してから、125~300 ℃に加熱する。加熱により、水は高圧の水蒸気となり、ト ルエン中に少量溶解し、アルコキシドを加水分解させる。周りを高温のトルエンによって 囲まれているため、水酸化物にはならず、脱水されて酸化チタンの微粒子となる。HyCOM 法では、水を入れないで加熱すると何も反応が起こらないが、アルコキシドとしてtert-ブト キシドを使うと、加熱により酸化チタンが生成する。この方法がTD (Thermal Decomposition) 法^[1.48]である。酸化チタンの生成は、アルコキシドの熱分解によるもので、HyCOM法と同 様に、高結晶性のアナターゼ微粒子が得られる。また、HyCOM法において、トルエンの代 わりに、2-ブタノールや2-プロパノールなどのアルコールを使い、水を使わないで加熱する 方法が、THyCA (Transfer Hydrolytic Crystallization in Alcohols)法^[1.49]である。この方法では、 アルコールをオートクレーブ中で加熱すると、脱水反応が起こってオレフィンが生成する。 この際に遊離する水を使ってアルコキシドを加水分解することで、酸化チタンが得られる。

<水溶液からの結晶成長法[1.4,50,51]>

最後に、本研究に最も関係が深い方法である、水溶液からの結晶成長法による二酸化チ タンの合成についてまとめる。水溶液からの結晶成長法は、前駆体溶液のpHや過飽和度を 調整することによって液相から固相への不均一核生成を引き起こし目的の金属酸化物を得 る方法である(Figure 1-15,16)。この合成方法は、常温・常圧下で行うことが可能であり、環 境に優しい合成法として期待される手法である。二酸化チタン合成の際の前駆体としては 硫酸チタニル(TiOSO₄)や四フッ化チタン(TiF₄)などが挙げられる。これらを原料として 二酸化チタン結晶を析出させる研究は、Imaiらにより確立された。pH_i(原料を入れる前の 水溶液のpH)とチタンの濃度を調整することで、析出する結晶をアナターゼ型、ルチル型 と作り分けることが出来る。Figure 1-15, Figure 1-16に、横軸にpH_i、縦軸にlog c_n(チタン濃 度の対数)を取ったときの各結晶形の生成条件を示した図を示す。



Figure 1-15. Titanium dioxide precipitation region in case of using TiOSO₄ as precursor^[1,4].



Figure 1-16. Titanium dioxide precipitation region in case of using TiF₄ as precursor^[1.50, 51].

1.4.3 二酸化チタンの実用化に向けた応用

二酸化チタンは、化学的・物理的に安定・無害な物質であり、身近では白色顔料や食品添加物、歯磨き粉の原料として使用されている。また、最近では光触媒としての作用が注目 されており、各種電子デバイスへの応用・実用化が期待される。以下に、二酸化チタンの作 用および実用例をいくつか挙げる。

<酸化分解作用>

光触媒作用のひとつとして酸化分解作用が挙げられる。光触媒である二酸化チタンにバンドギャップ(アナターゼ: 3.2eV, ルチル: 3.0eV)以上の光を照射することで電子と正孔を 生成する。正孔は強い酸化力を持ち、大気中にあるOH などから電子を奪う。このとき電子 を奪われたOHは非常に不安定な状態のOHラジカルになる。このOHラジカルは強力な酸化 力を持つために近くの有機物から電子を奪い、自分自身を安定化させる。このようにして 電子を奪われた有機物は結合が分解され、最終的には二酸化炭素や水になり、大気中に発 散していく。この作用を用いることにより、二酸化チタンは環境浄化材料として非常に注 目されている。

<超親水化作用>

二酸化チタンは、光酸化力のほかに超親水性という性質を併せ持つ。二酸化チタン表面 では、TiとTiを酸素が架橋して安定化している。この状態では、二酸化チタンの表面は疎水 性である。しかし、この表面に紫外線を照射すると、一部の架橋酸素が離脱して酸素欠陥 が生じる。この酸素欠陥に空気中の湿分が結合し、化学吸着水(表面水酸基)が生成し、 親水的になる。超親水性機能を応用した代表的な例は、自動車ガラス・光触媒タイルなどが 挙げられる。

< 色素增感太陽電池電極>

さらに、二酸化チタンの、色素増感太陽電池電極材料としての特性も大変注目されてい る。二酸化チタンは現在用いられている半導体金属酸化物の中で最も優れた特性を示す材 料として知られている。

1.4.4 二酸化チタンの形態制御

二酸化チタンの形態制御に関する研究は、これまでに数多く報告されている。特に、ナ ノスケールにおける低次元構造体についての研究が多い。これは、低次元化に伴う比表面 積の増加や粒子サイズの低下が、各種デバイスへの応用に有利に働くことが知られている からだと考えられる。これまでの研究より、二酸化チタンナノロッド^[1.52]やナノワイヤー^[1.53] などの各種形態が得られており、それぞれ独自の特性を発現している。低次元酸化チタン 構造体として、ナノシート、ナノチューブも挙げられる。その代表例として、1998年にKasuga らによって二酸化チタンナノチューブ発見の報告がなされた^[1.54]。しかしその後、得られた チューブ状の物質は二酸化チタンではなく、チタン酸という層状物質ではないかと考えら れるようになり、チタン酸への注目度が高まるようになる。また、一方でチタン酸ナノシ ートに関する研究が Sasaki らによってなされ、多層の層状構造を有するチタン酸を層間剥 離することにより、単層シートの合成に成功した^[1.55]。これらの形態は、いずれも材料とし て非常に期待される形態であり、二酸化チタンの結晶形態制御と同様にチタン酸への期待 も高まるようになっていった。

1.5 チタン酸

1.5.1 チタン酸の構造とその特徴を活かした形態制御

チタン酸化合物の中で代表的なものに、チタン酸アルカリ土類金属のペロブスカイト型 結晶構造があるが、ほかにも、チタン酸アルカリ金属に見られるTiO₆八面体やTiO₅三角両錘 体が稜線を共有しながら連結した層状構造やトンネル構造が存在する。特に、TiO₆八面体構 造を有する層状チタン酸は、基本的骨格がアナターゼ型二酸化チタンと同じであり、上述 したように、初期の研究では二酸化チタンと考えられていた。



Figure 1-17. Crystal structures of titanate.

チタン酸の形態制御に関する研究の第一人者として、物質・材料研究機構の佐々木らが挙 げられる^[1.56-61]。彼らは、層間にセシウムイオンを含む層状構造を有するチタン酸を出発原 料とし、塩酸で層間のセシウムイオンをプロトンとイオン交換してH_xTi_{2-x4}Q₄・H₂O(*x*= 0.7; □,vacancy)を作製し、これをアルキルアンモニウムイオン(例えば、TBA⁺)水溶液で処理 すると、特定の濃度領域で積層構造が単層にまで分離され、ナノシートのコロイド溶液が 得られることを発見した。さらに、得られたナノシートを、各種カチオン性物質と積層さ せることで、様々な形態の酸化チタンへとデザインし、実材料への応用を図っている。例 えば、高分子陽イオンを共役イオンに、LB膜法に類似する交互積層膜法を用いることで、 酸化チタンナノシートと酸化マンガンナノシートとの交互積層膜を作製することができる。 この積層膜は、積層数により光吸収スペクトルの吸収ピークに強度変化が見られ、光学材 料として期待される。また、チタン酸ナノシートが分散したゾル溶液を、150-400 ℃に保 持された乾燥炉内に噴霧することで、微細化された液滴の内部で急激に水分の気化が起こ り、これに伴って液滴が膨らみ、最終的には薄い殻を有した中空状の酸化チタンバルーン を作製することができる^[1.62]。粒子の大きさは、マイクロメートルオーダーから数百マイク ロメートルオーダーと、従来の酸化チタン微粉末より大きいが、殻の厚みはゾル溶液濃度 を変化させることで数十ナノメートルにまで薄くコントロールできる。さらに、このバル ーン状酸化チタンを粉砕することによって薄片状酸化チタンに加工することができ、実材 料への応用が期待される。

一方、上述したように、1998年にKasugaらによってチタン酸ナノチューブの合成に成功 したことが報告された^[1.54]。彼らは、二酸化チタン粉末を高濃度の水酸化ナトリウム水溶液 中に加え、水熱処理を施すことでチューブ状の構造体を得た。二酸化チタンは、実材料と して広く応用が利き非常に注目されている物質であり、ナノチューブが合成できたことで 更なる可能性に期待が高まった。その後、他の研究者による報告から、Kasugaらが作製し たナノチューブは、実はチタン酸で構成されているのではないかという疑問が生じた。実 際、同様の実験方法を用いることでナノチューブ合成を試みると、同様の形態は観察され たものの、結晶形は二酸化チタンではなく層状チタン酸であることが確認された。現在に おいても、チタン酸ナノチューブ合成方法としては春日らが用いたものと同様で、水酸化 ナトリウム水溶液に二酸化チタンを加えて水熱処理することで得るというものが一般的で ある。ナノチューブ形態は、ナノシートがスクロールすることで成り立っており、シート 層間には、合成環境に応じてナトリウムイオンとオキソニウムイオンとが存在する。シー ト層間の各種イオンとナノシート表面とが静電的相互作用を介して結合しているが、その 結合状態の安定性を取るためにスクロールしてチューブ形態になると考えられている^[1.62]。 現在においても、ナノシートからナノチューブへの形態変化に関する確固たる理論は得ら れておらず、今後の研究に期待が高まる。

1.5.2 各種デバイスへの応用

チタン酸は、二酸化チタンと同様に半導体としての性質を有する。これまでに、電子デ バイスや光学素子などへの応用がいくつか報告されており^[1.63-65]、非常に期待される物質で ある。さらに現在ではチタン酸ナノシートやナノチューブなどの層状構造をうまく活かし、 リチウムイオン二次電池への応用も試みられている^[1.66-68]。一般的なリチウムイオン二次電 池は、負極として層状グラファイトを、正極としてコバルト酸リチウムを用いている。層 状グラファイト同様にリチウムイオンの貯蔵能を有する層状チタン酸を負極として使用す ることにより、優れた特性を有する電池材料の作製が期待されている。一方、Osada らは、 チタン・ニオブ層状酸化物を合成し、室温での化学処理により、層状酸化物を層1枚にまで 剥離し、厚み1nm、横サイズ約5μmのペロブスカイトナノシートを得て、究極の誘電体薄 膜を作製することに成功した^[1.69]。この誘電体薄膜は、膜厚5-10nmで320という高い比 誘電率に加え、周波数特性、温度安定性、絶縁特性なども自在に制御できるなど、実用化 の近いナノシートとして期待されている。

1.6 チタン酸バリウム

1.6.1 チタン酸バリウムの構造と物性

チタン酸酸化物の中でも特に代表的なものとして、チタン酸バリウムが挙げられる。チ タン酸バリウムは上述したように、ペロブスカイト型結晶構造を有し、その特徴的な構造 から、誘電体材料として広く実用化されている。ペロブスカイト型結晶構造は、低温から 高温に向かい、菱面体晶・斜方晶・正方晶・立方晶と転移する。この、室温で安定な正方晶と、 120 ℃以上で安定な立方晶が実用上重要になる。正方晶では、横より縦が1%程度長くなっ ており、中心のチタンの周辺の酸素がわずかにずれた位置で安定することで強誘電体とな っている(Figure 1-18)。一方、温度を120 ℃以上に上げて立方晶にすると、位置のずれが解 消してしまい、常誘電体となる。強誘電体から常誘電体に変わる温度(キュリー点)で比誘電 率は20,000 以上の高い値を示す(Figure 1-19)^[1.70]。この高い比誘電率を活かし、積層セラミ ックコンデンサや PTC サーミスタなど、様々な電子部品の材料として使用されている。



Figure 1-18. Crystal structure of barium titanate.



Figure 1-19. Dielectric constants of barium titanate as a function of temperature^[1.70].

1.6.2 チタン酸バリウムナノ結晶の合成方法

電子部品の小型化に伴い、材料として使用されるチタン酸バリウム粒子に求められる粒 子径が年々小さくなっている。特に、積層セラミックコンデンサでは、数十 nm オーダーの 粒子が実用化されているなど、確実にナノサイズ化が進んでいる。チタン酸バリウムの合 成法としては、固相法が最も多用されていたが、近年では、こうしたナノサイズ化の動向 に従って、液相法で合成されたチタン酸バリウムナノ結晶が実用化されるなど、液相合成 法が研究レベルではなく、実用化レベルで使用されるようになっている。ただし、固相法 においても、原料粒子の微細化技術が進むことにより、結晶性の高い数十 nm の粒子を合成 することが可能である。以下には、今後ますます需要が進むであろう、液相合成法に着目 し、有望な合成法と得られるナノ粒子の特徴をいくつかまとめる。

<ゾルゲル法^[1.71-73]>

一般的に、ゾルゲル法では、金属アルコキシドを加水分解・縮重合させることでメタロキ サン結合が得られ、アモルファス状のゲル体が形成される。これを熱処理することで目的 の金属酸化物を得る。チタン酸バリウムでも同様で、テトライソプロポキシチタンやバリ ウムエトキシドなどのアルコキシドを原料に用い、アルコールを溶媒として、加水分解・縮 重合を経てアモルファスを合成したのち、熱処理することでチタン酸バリウム結晶を作製 する。アルコールを溶媒とするため、結晶内に水酸基を取り込みにくく、熱処理後のポア の形成が抑制され、結晶性の高い粉末が得られるが、原料として用いるアルコキシドが高 価であり、実用化には課題が残る。一方で、Kuwabara らは、上述した一般的なゾルゲル法 において、前駆体溶液の高濃度化とゲル形成後のエージング時間の確保により、ゲル乾燥・ 熱処理の工程を経ずに結晶性の小粒径チタン酸バリウムナノ粒子を合成することに成功し た^[4,1]。このナノ粒子は、有機溶媒中でほぼ単分散の状態を保持することが可能であり、高 い価値を有する分散液として、実用化が進められている。Kuwabara らの研究詳細について は、「第4章 ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成」にまとめる。

<水熱反応法[1.74-78]>

水熱合成法では、一般的に、水酸化バリウム八水和物をバリウム源に、二酸化チタン微 粒子をチタン源に用い、水を溶媒として、オートクレーブ内にて 100-200 ℃程度の熱を掛 けることで合成する。広く研究されている合成法であり、原料の微粒子化や添加するアル カリ濃度の調整、低温水熱や二段階水熱の採用により、小粒径・高結晶化が達成されている。 しかしながら、水を溶媒として用いるため、合成時に格子内に水酸基が欠陥として取り込 まれ、得られた粒子を熱処理することで水酸基が水として脱離し、粒子内にポアが形成さ れ、結晶性の低下の原因となることが確認されている。

<超臨界水熱反応法[1.79-84]>

水熱法での欠点を克服し、更なる小粒径化・高結晶化の達成が期待される合成法が超臨界 水熱法である。水の臨界点は 374 ℃、22.1 MPa であり、これ以上の温度・圧力領域に存在す る水を超臨界水と呼ぶ。超臨界点以上では、水の分子間ポテンシャルエネルギーに対して 運動エネルギーが大きくなり、圧縮しても液化せず、臨界圧力以上では水は高密度のガス 状態になる。この状態下で合成を行うことで、超臨界水ならではの物性が発現し、ナノ粒 子合成に有利となる。まず、超臨界水では、水密度が圧力によって大きく左右される。た とえば、400 ℃にて圧力を 10 MPa から 50 MPa に変化させた場合、水密度は気体に近い 0.04 g/cm3 から液体に近い 0.58 g/cm³まで変化する。水密度を自在に操作できるため、水熱法に おけるチタン酸バリウム合成に際しては、チタン酸バリウム粒子周囲の水の存在割合を変 更することができ、特に水熱粒子で問題点として挙げられているチタン酸バリウム結晶内 へのポア形成は、水酸基の導入が原因であるため、水密度の低い領域で合成を行うことで、 ポアの形成を抑制できるのではないかと考えられる。また、常温常圧下では78である水の 比誘電率は、374 ℃の超臨界水では10程度と、極性の小さな有機溶媒並みの値を示す。さ らに高温まで上げると、水は無極性有機溶媒に近くなる。その結果、超臨界水は有機物に よく溶けるが、無機物はほとんど溶けないという、通常の水とは逆の性質を示す。この性 質により、超臨界水による酸化物の合成の際には、合成反応はソルボサーマル反応に極め て近い挙動を示し、酸化物の溶解度を低い値にすることが可能であるため、小粒径粒子合 成が達成されうる。以上のような特性を有するため、均一粒度分布を有する小粒径チタン 酸バリウムを、結晶性の高い状態で得ることが可能であると考えられ、非常に期待される 合成法として研究が進められている。実際に、超臨界水熱法を用いることで、シングルナ ノオーダーのチタン酸バリウム粒子の合成が達成されている^[1.81]。

1.6.3 MLCC 材料としてのチタン酸バリウム結晶

高い比誘電率を有するチタン酸バリウムは、各種電子材料に用いられているが、特に積 層セラミックコンデンサの誘電体材料として重要である。積層セラミックコンデンサ (Multi-Layer Ceramic Capacitor; MLCC) は、誘電体と金属電極を多層化することで小型・大容 量化を図ったコンデンサである。近年の電子部品の小型・多機能化に伴い、MLCC 誘電体層 の薄層化・多積層化が進み、現在では誘電体層の厚みが 1µm 以下となっている。誘電体層を 薄層化するため、誘電体材料であるチタン酸バリウムの粒子径を小さくする必要があり、 合成技術や粉砕技術、分散技術など、様々な分野でチタン酸バリウムに関する研究が進め られた。MLCC 用途では、チタン酸バリウムは主に固相法で合成される。固相法は、量産 性・結晶性の高さなど多くの面でメリットを有する。しかしながら、MLCC の小型化に伴い、 固相法では合成が難しい小粒径チタン酸バリウムが求められるようになり、近年では液相 法での量産が実現してきている。しかしながら、上述したように、液相法で得られるチタ ン酸バリウムは、小粒径は容易に達成されるものの、固相法で得られるチタン酸バリウム 粒子に比べ、結晶性が低く、粒子内にポアが形成されてしまうなど、いまだ発展段階にあ る。

1.7 チタン酸バリウム誘電体薄膜

1.7.1 誘電体薄膜の形成方法と現状

MLCC の小型・多機能化が進む一方で、基板上に直接キャパシタやインダクタなどを積層 する集積型パッシブデバイス技術(IPD; Integrated passive device)が開発されている^[1.85]。電子 機器の小型化・高性能化がますます進む中で、こうした薄膜技術を使用することで、高密度 化による高信頼性・小型化が実現できるだけでなく、高周波化も達成されるなど、期待値は 大きい。誘電体薄膜の作製方法として代表的なものに物理気相成長法(PVD; Physical Vapor Deposition)^[1.86,87]や化学気相成長法(CVD; Chemical Vapor Deposition)^[1.88,89]、化学溶液堆積法 (CSD; Chemical Solution Deposition)^[1.90,91]が挙げられる。PVD 法や CVD 法により得られる誘 電体薄膜は、結晶性が高く、エピタキシャル成長や配向制御が可能であるため魅力的な方 法だが、コストが高いことや薄膜形成時の雰囲気制御が必要であることなどが実用化の障 壁になっている。これに対し、CSD 法は、電極基板上に、金属アルコキシド前駆体溶液を スピンコート法により塗布し、熱処理することで誘電体膜が形成されるため、PVD 法や CVD 法に比べて低コストで誘電体薄膜が作製できる。そのコスト安と簡便さから、これまで多 くの研究が成されてきた。しかしながら、金属アルコキシド前駆体溶液には有機分が多く 含有されており、基板上に塗布して熱処理した際に残渣として残り、高結晶な膜を形成す るのが困難と考えられている。また、現状ではいずれの誘電体薄膜も電極基板として Pt を 用いているが、低コスト化を図るため、Cu や Ni などの卑金属への変更が今後必須になると 考えられる。卑金属電極への変更にあたり、薄膜の熱処理は還元雰囲気で行う必要がある。 PVD法やCVD法で得られた誘電体薄膜は、成膜にあたり高温での熱処理を必要とするため、 耐熱性の低い Cu 電極上での形成は難しい。また、真空中での膜形成を必要とするため、誘 電体薄膜に欠陥が形成されやすく、リーク特性が悪化してしまう。さらに、CSD 法で得ら れた誘電体薄膜は、上述したように、熱処理後の有機残渣が問題となっているが、卑金属 電極上での薄膜形成のために還元雰囲気での熱処理を行うことにより、有機残渣がさらに 抜けにくくなってしまう。以上の理由から、薄膜形成による電極基板の低コスト化がなか なか進まない状況が続いた。

そこで、Kuwabara らは、CSD 法における有機残渣の問題点を克服し、また、卑金属電極 基板上での膜形成を容易にするため、高濃度ゾルゲル法により合成したチタン酸バリウム ナノ粒子を分散液中に分散させてコーティング溶液を作製し、これを塗布することによっ て誘電体薄膜を作製する方法を試みた^[1.92]。この方法は、あらかじめ結晶性の誘電体粒子を 合成し、これを電極基板上に敷き詰めるため、CSD 法で問題となっている有機残渣の影響 が無く、高い結晶性を有する誘電体薄膜が形成できると期待される。また、結晶性の粒子 は、熱処理時の雰囲気による影響を受けにくいため、PVD 法や CVD 法、CSD 法では達成 することが困難であった卑金属電極基板の使用を可能にし、薄膜形成の低コスト化が達成 される可能性が極めて高い。

以上のように、誘電体薄膜は、コストや結晶性・誘電率などに折り合いを付けるため、 様々な作製方法を模索しながら開発が進められている。現状では、MLCC で得られるよう な高誘電率を有するキャパシタの形成を薄膜技術で得ることは難しいが、ますます進む電 子部品の小型化が MLCC に限界をもたらすことは防ぎようのない事実である。そのような 中、さまざまな誘電体薄膜作製技術が開発され、現状ではコストや誘電率などの特性にお いて MLCC のそれには及ばない状況であるが、今後さらに研究が進み、低コスト・高品質な 誘電体薄膜が MLCC に代わるキャパシタとして実用化される日も近いと考えられる。

1.7.2 ナノ粒子堆積法を用いた誘電体薄膜の形成

本研究では、誘電体薄膜の形成法として、Kuwabara らの方法^[1,92]を参考に、ナノ粒子を電 極基板上に堆積し、熱処理することで焼結・緻密化を促すナノ粒子堆積法を採用している ^[1,93,94]。上述したように、この方法の最大のメリットは、あらかじめ結晶化した誘電体ナノ 粒子を合成し、これを基板上に堆積し熱処理することにある。CSD 法と異なり、有機分の 残留が少なく、高い結晶性を有する誘電体薄膜の形成が可能であり、結果的に高誘電率な 薄膜が得られる可能性を有する。現状では、PVD 法や CVD 法などで作製した誘電体薄膜で 得られる誘電率には及ばない特性であるが、上述したように、ナノ粒子堆積法は熱処理時 の雰囲気制御を必要としないため、今後開発のポイントとなる電極基板の低コスト化にも 対応し、また材料設計を進めることで、良好な特性を有するチタン酸バリウム誘電体薄膜 の作製が達成されるものと期待している。以下には、これまでの研究で得られた知見をま とめる。

ナノ粒子堆積法により誘電体薄膜を形成する際のポイントは、高結晶・高分散の誘電体ナ ノ結晶(ナノクリスタル)を用いることにある。高結晶・高分散のナノクリスタルを、電極基 板上に高密度で堆積させ、熱処理による基盤界面からの粒成長を促すことで、高い結晶性 と緻密性を有する誘電体薄膜が形成されると考えられる(Figure 1-20)。本研究では、高結晶・ 高分散のナノクリスタルの合成方法として、Kuwabara らが見出した高濃度ゾルゲル法を参 考にしている^[1,92]。Kuwabara らの方法を手本に、加水分解温度やエージング時間・温度など の最適化を行うことで、5 nm 程度のチタン酸バリウムナノクリスタルを単分散状態でスラ リー化することに成功した(Figure 1-21)^[1,93,94]。加水分解温度やエージング温度を変えること で、10 nm, 20 nm 程度のチタン酸バリウムナノクリスタルを作製することも可能であるが、 これらの粒子を用いてナノ粒子堆積法による薄膜形成を試みた場合には、熱処理による粒 子同士の焼結は起こりやすいが、基板界面からの粒成長を得ることが難しい。5 nm 程度の ナノクリスタルを用いることにより、電極基板の配向性の影響を受けて配向したチタン酸 バリウム結晶核が形成されることが重要である。また、アモルファス状の粒子を用いた場 合には、アモルファス粒子中に OH 基が取り込まれていることや Ba/Ti 比が 1 からずれてし まっている可能性が高いことなどから、熱処理による基板界面からの粒成長が進んだとし ても、欠陥や Ba/Ti≠1 のチタン酸バリウム形成が懸念されるため、結晶化した粒子を用い た場合のような高結晶性薄膜の形成には至らないと予想される。実際に、アモルファス粒 子の使用に近い誘電体薄膜形成方法が CSD(Chemical Solution Deposition)法であると言える。 CSD 法では、バリウム・チタンアルコキシドを有機溶剤中に溶解させて、これを前駆体溶液 として基板に塗布し、熱処理することで結晶化させる方法を取る。この方法の問題点とし て、有機分が残渣として残り、結果的に得られる薄膜の結晶性を低下させてしまうことが 挙げられている。これらのことから、結晶化したチタン酸バリウムナノクリスタルを用い ることが、高い結晶性を有する誘電体薄膜形成に重要であり、5 nm 程度の大きさのものを 使用することにより、容易に電極基板界面からの粒成長が促進され、基板の配向の影響を 受けた誘電体薄膜が形成されると考えられる。高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウム ナノクリスタルの合成についての詳細は、第4章にまとめる。



Figure 1-20. Illustration of nanocrystals sintering process.



Figure 1-21. (a), (b) TEM images and (c) particle size distribution of 5 nm barium titanate nanocrystal slurry.

単分散チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを、Pt 電極基板上にスピンコート法に より塗布し、500 ℃に加熱したホットプレート上で乾燥させた。これを 5 回繰り返したの ち、800 ℃で 10 分間熱処理を行った。以上の工程を 6 回繰り返すことで、合計 30 層のチ タン酸バリウム層を作製した。得られたチタン酸バリウム薄膜は、Figure 1-22 に示すように、 270 nm 程度の膜厚を持ち、5 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルは粒成長することで柱 状構造を有する緻密膜を形成していた。一次元 X 線回折逆格子マッピング測定により膜の 配向性を調べたところ、無配向結晶が多く存在するものの、(110)、(111) 配向に対応するピ ークが見られることから、一部分で配向していることがわかった(Figure 1-23)。



Figure 1-22. Cross-sectional SEM image of barium titanate thin film of 5 nm nanocrystals sintered at 800 $^{\circ}$ C.



Figure 1-23. Two-dimensional reciprocal space map of barium titanate thin film of 5 nm nanocrystals sintered at 800 °C.

ここで、配向した柱状構造を有する薄膜の形成機構を考察する^[1.95]。薄膜形成に用いたナ ノクリスタルは、5 nmと非常に小さく、高い比表面積を有する。熱処理により、ナノクリ スタルは表面エネルギーを最小にするために緻密化・粒成長を繰り返し、隣接粒子を取り込 みながらオストワルド成長するものと考えられる。電極基板が平坦であり、なおかつ薄膜 と電極基板との格子整合性が高く界面エネルギーが低い場合には、基板界面からの核形成・ 粒成長が優勢となり、柱状構造を有する膜が得られる(Figure 1-24)。しかしながら、ナノク リスタルが充填した薄膜内において粒成長がランダムに生じると粒状構造となり、粒内ポ アを取り込んだ異常粒成長やクラック形成が生じやすくなる。



Figure 1-24. Crystal growth behavior of filled nanocrystals at high temperature.

この現象を焼結理論と対応させて考察すると以下のようになる(Figure 1-25)。基板の結晶 方位と粒子の結晶方位が一致する場合、界面エネルギーは極小となり、粒子-粒子間と基 板-粒子間との接点での曲率の違いから、基板-粒子間で優先的に成長が進む。これが核 となり、オストワルド成長していくと考えられる。基板方位と粒子の結晶方位が一致する 確率は低いが、成長の初期段階ではナノクリスタルの弱いファンデルワールス力により、 粒子の回転による再配列が生じていると予想される。以上のように、基板界面から粒成長 が進行することで、薄膜に配向性が付与されるだけでなく、膜面内での収縮が抑制され、 膜厚方向の収縮が優先となるため、クラックや誘電率低下の一因となる面内引っ張り応力 を低減できる。



Figure 1-25. Nanocrystals sintering behavior at the substrate interface.

また、この薄膜上に上部電極を成膜し、測定プローブを当てて電機特性を評価した結果、 10kHzにおける比誘電率は 635、誘電損失は 0.7%であり、良好な特性を示した(Figure 1-26)。


Figure 1-26. Frequency dependence of permittivity and dielectric loss tangent.

以上のように、ナノ粒子堆積法を用いることにより、電極基板界面からの粒成長が促さ れて一部配向を有する高結晶薄膜が得られ、結果的に良好な電気特性を有することが確認 された。あらかじめ結晶化させた単分散ナノクリスタルスラリーを電極基板上に塗布した ため、熱処理による粒成長が容易に起こり、上述したような高結晶な薄膜が得られたもの と考えられる。今後、安価なナノクリスタルの合成法の確立、誘電体薄膜用途のための粒 子設計を行うことで、さらに実用性の高い優れた特性を有する薄膜が開発されることと期 待される。

1.8 本研究の概要と意義

本研究は、上述した背景を元に、実用性の高い材料として注目されているチタン酸結晶 の合成検討に関するものである。光触媒材料や色素増感太陽電池電極材料として有用なア ナターゼ型二酸化チタン、リチウムイオン二次電池の負極材料として期待の高まるチタン 酸ナノシート、MLCC 材料として括弧たる実績のあるチタン酸バリウムナノ結晶をターゲ ットとした。これらの物質を、水溶液からの結晶成長法やゾルゲル法を用いることで、ボ トムアップ的に結晶成長を進行させ、シングルナノメートルスケールで形態制御された各 種粒子を得ることに成功した。特に、水溶液の結晶成長法では、高分子ゲルを反応場とし て用いる、反応物の種類や濃度を調整することで、過飽和度の非常に高い状況下で結晶成 長が進み、ナノメートルオーダーで緻密に制御された形態が得られた。また、ゾルゲル法 では、これまで問題点とされていた原料のコスト高を解消すべく、ゾルゲル法による粒子 形成メカニズムを基に、原料の変更を試み、分散度の高いシングルナノメートルオーダー の粒子を得ることが可能になった。各種材料合成法がある中で、実用性に関して言及すれ ば湿式合成法は未だ開発段階にあると言えるが、本研究で得られたようなシングルナノス ケールで制御された形態を量産体制で得ることが可能になれば、付加価値の高い材料とし て必ずや実用化されることになると確信している。

また、本研究では、ナノ結晶の材料としての価値を定めるべく、得られたチタン酸バリ ウムナノ結晶の誘電体薄膜への応用を試みている。電子機器の小型化・高周波化が進む中で、 部品の小型化・大容量化・低ESL (Equivalent Series Inductance)化が求められ、高い誘電率を有 する誘電体薄膜への注目が高まっている。誘電体薄膜の作製法としてCVD (Chemical Vapor Deposition)法やPVD (Physical Vapor Deposition)法、CSD (Chemical Solution Deposition)法など が挙げられるが、設備や原料のコストが高いこと、結果的に得られる薄膜の結晶性が低く 低誘電率の薄膜になってしまうことなどが問題点となっている。また、これらの方法は、 成膜や結晶化の際に行う熱処理に雰囲気制御を必要とするため、酸化防止のために還元雰 囲気での熱処理を必要とするCu電極の使用は困難である。そこで、本研究では、上述した 湿式化学合成法を用いることで誘電体粒子を合成し、これを中間体として用いることで目 的の構造を有する誘電体薄膜を作製しようと、ナノ粒子堆積法に着目した。シングルナノ メートルスケールの結晶を中間体として用いることで、800℃という比較的低温での熱処理 により、電極基板の結晶配向の影響を受けた状態で周囲のナノ結晶を取り込みながら粒成 長し、結果的に高い結晶性・誘電率を有する誘電体薄膜が得られることが確認された。現状 では、PVD法やCVD法、CSD法により形成される誘電体薄膜で得られる特性には及ばない 状況であるが、あらかじめ結晶化させた誘電体粒子を用いているため、熱処理時の雰囲気 に制限がなく、Cu電極基板上での薄膜形成が可能である。さらに本研究を通して材料設計 を進めることにより、より高い特性を有する薄膜が形成されるものと考えられ、薄膜作製

技術のひとつとして確立されることになると期待している。

以上のように、湿式化学合成プロセスを用いることで各種材料の合成方法を模索し、ナ ノメートルスケールで形態制御された結晶の作製法を確立することで、様々な方向からデ バイス応用が可能な材料が得られると期待される。つまり、ナノ結晶を直接使用すること で究極的に小型化されたデバイスが作製できるだけでなく、現状で量産されているデバイ スを、より小型化・高性能化するための中間材料としても用いることが可能である。本研究 により、様々なデバイスが小型化・高性能化されることを望む。

1.9 本研究の構成

本論文は、全7章から構成されている。各章の内容を以下に示す。

第1章 緒言

第1章では、湿式合成法による結晶成長について、メカニズムとこれまでの研究動向を まとめる。また、チタン酸系材料、特に、二酸化チタン、チタン酸ナノシート、チタン酸 バリウムナノ結晶の特徴と合成方法、応用例を述べ、本研究の背景および目的を概説する。

第2章 寒天ゲルを用いた層状チタン酸の合成

第2章では、高分子ゲルマトリクスを反応場としたチタン酸ナノ結晶の作製と形態制御について論じる。高分子ゲルを原料の拡散律速場として用いることで、ナノからマイクロスケールまで高次に渡って構造が制御されたチタン酸ナノシートの合成に成功した。ナノシート層間には、原料由来のアンモニウムイオンの存在が示唆され、(NH₄)₂Ti_nO_{2n+1}で示される新規チタン酸ナノシートと言える。また、このナノシート層間には、アンモニウムイオンとのイオン交換によるカチオン性有機色素の導入が可能であった。さらに、350℃と比較的低温な熱処理で、ナノシート形態を保持した状態でチタン酸からアナターゼ型二酸化チタンへの結晶転移が可能であった。

第3章 溶解度制御による層状チタン酸の形態制御

第3章では、第2章で得られたチタン酸ナノシートの合成条件を基に、層状チタン酸と アナターゼ型二酸化チタンの選択的合成について論じる。本研究では、溶液のpHとカウン ターカチオンの種類を変えることで、層状チタン酸の結晶構造や形態に影響を与えること を見出した。カチオン種の濃度によって層状チタン酸とアナターゼ型に酸化チタンとの選 択的合成が可能になり、さらに、カチオン種の種類により層状チタン酸の形態が決定され ることが確認された。

第4章 ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成

第4章では、高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成について論じる。 高濃度ゾルゲル法は、高結晶・高分散・小粒径ナノ粒子の合成法として、非常に有効な合成 方法である。しかしながら原料の高コストが問題となり、実用性に乏しい。そこで、本章 では、高濃度ゾルゲル法におけるチタン酸バリウムナノ結晶合成についてこれまでの研究 をまとめ、そこから考えられる合成メカニズムの妥当性を実験により検証した。

第5章 Mn イオン添加チタン酸バリウムナノ結晶から作製した誘電体薄膜の 微細構造および特性評価

第5章では、高濃度ゾルゲル法で得られたチタン酸バリウムナノ結晶の誘電体薄膜への応用について論じる。これまでの研究より、得られたチタン酸バリウムナノ結晶を用いることで、部分的に配向した柱状構造を有する緻密な誘電体薄膜を作製することに成功している。この薄膜は、比誘電率635、誘電損失0.7%と、良好な特性を示すことが確認されている。そこで、本章では、更なる実用化を目指し、誘電体薄膜への耐還元性付与のため、Mn イオンを添加したチタン酸バリウムナノ結晶を合成し、薄膜形成を試みた。その結果、チタン酸バリウムナノ結晶は、熱処理により大きく粒成長し、Mn イオンはチタン酸バリウムオン

第6章 チタン酸バリウムナノ結晶から作製した誘電体薄膜のホウ素添加によ る微細構造制御および特性評価

第6章では、第5章で得られた誘電体薄膜の更なる材料設計について論じる。第5章で、 Mn イオンがアクセプターとして機能することが確認されたことにより、耐還元性の付与に 成功したため、使用する電極基板を、これまで使用していた Pt から Cu へと変更すること でコストダウンが可能である。しかしながら、Cu は熱処理耐性が弱く、容易に変形してし まう。そこで、ホウ素を焼結助剤としてチタン酸バリウムナノ結晶に添加し、これを用い て誘電体薄膜を形成した。その結果、ホウ素添加によりチタン酸バリウムナノ結晶の粒成 長温度を 50 ℃程度低温化することに成功した。さらに、粒成長が促進されたことで、基板 界面からの粒成長が促進され、面内配向を有する高結晶薄膜が得られ、高い特性を有する ことが確認された。

第7章 結言

第7章では、本研究で得られた知見を総括している。

参考文献

- [1.1] S. Yamabi, H. Imai, Transaction of the Materials Research Society of Japan 2003, 28, 329-332.
- [1.2] S. Yamabi, H. Imai, K. Awazu, Chem. Let. 2002, 714-715.
- [1.3] E. Hosono, S. Fujihara, K. Kakiuchi, H. Imai, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 7790-7791.
- [1.4] S. Yamabi, H. Imai, Chem. Mater. 2002, 14, 609-614.
- [1.5] D. M. Antonelli, J. Y. Ying, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 34, 2014-2017.
- [1.6] C. Su, B. Y. Hong, C. M. Tseng, Catal. Today 2004, 96, 119-126.
- [1.7] M. Gotic, M. Ivanda, A. Sekulic, S. Music, S. Popovic, A. Turkovic, K. Furic, *Mater. Lett.* **1996**, *28*, 225-229.
- [1.8] P. P. Phule, S. H. Risbud, Adv. Ceram. Mater. 1988, 32, 183-185.
- [1.9] R. I. Walton, Chem. Soc. Rev. 2002, 31, 230-238.
- [1.10] R. C. Xie, J. K. Shang, J. Mater. Sci. 2007, 42, 6583-6589.
- [1.11] C. S. Kim, B. K. Moon, J. H. Park, S. T. Chung, S. M. Son, J. Cryst. Growth 2003, 254, 405-410.
- [1.12] D. R. Modeshia, R. I. Walton, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 4303-4325.
- [1.13] A. Rabenau, Chem. Soc. Rev. 2010, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 24, 1026-1040.
- [1.14] S. Somiya, R. Roy, Bull. Mater. Sci. 2000, 23, 453-460.
- [1.15] W. L. Suchanek, R. E. Riman, Adv. Sci. Tech. 2006, 45, 184-193.
- [1.16] H. H. Ou, S. L. Lo, Separ. Purif. Tech. 2007, 58, 179-191.
- [1.17] H. Hayashi, Y. Hakuta, Materials 2010, 3, 3794-3817.
- [1.18] T. Adschiri, Y. Hakuta, K. Arai, Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, 4901-4907.
- [1.19] T. Adschiri, Y. Hakuta, K. Sue, K. Arai, Journal of Nanoparticle Research 2001, 3, 227-235.
- [1.20] T. Adschiri, K. Kanazawa, K. Arai, J. Am. Ceram. Soc. 1992, 75, 1019-1022.
- [1.21] Y. Oaki, H. Imai, Cryst. Growth Des, 2003, 3, 711-716.
- [1.22] Y. Oaki, H. Imai, Adv. Funct. Mater. 2005, 15, 1407-1414.
- [1.23] Y. Oaki, H. Imai, Chem. Commun. 2005, 48, 6011-6013.
- [1.24] Y Maibashi, K. Nishinari, Foods Food Ingredients Journal, 2003, 208, 791-800.
- [1.25] K. T. Nijenhuis, Advances in Polymer Science, 1997, 130, 194-202.
- [1.26] S. Kai, Nagare, 1984, 3, 215-228. (in Japanese)
- [1.27] S. Kai, *Ouyobutsuri*, **1985**, *54*, 19-27. (in Japanese)
- [1.28] S. Kai, Hyomen, 1997, 35, 109-116.
- [1.29] Y. Oaki, H. Imai, Cryst. Growth Des. 2003, 3, 711-716.
- [1.30] Y. Oaki, H. Imai, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 1363-1368.
- [1.31] S. M. Oh, J. G. Li, T. Ishigaki, J. Mater. Res. 2005, 20, 529-537.
- [1.32] K. Kamata, K. Maruyama, S. Amano, H. Fukazawa, J. Mater. Sci. Lett. 1990, 9, 316-319.

- [1.33] H. Y. Ha, S. W. Nam, T. H. Lim, I. H. Oh, S. A. Hong, J. Membr. Sci. 1996, 111, 81-92.
- [1.34] Z. Ding, X. J. Hu, G. Q. Lu, P. L. Yue, P. F. Greenfield, Langmuir 2000, 16,6216-6222.
- [1.35] A. Mills, N. Elliott, I. P. Parkin, S. A. O'Neill, R. J. Clark, *J. Photochem. Photobiol. A* 2002, *151*, 171-179.
- [1.36] S. I. Pyun, Y. G. Yoon, E. Lugscheider, R. Mathesius, *Surf. Coat. Technol.* **1993**, *61*, 233-237.
- [1.37] D. M. Antonelli, J. Y. Ying, Angew. Chem., Int. Ed. 1995, 34, 2014-2017.
- [1.38] H. Lin, H. Kozuka, T. Yoko, *Thin Solid Films* 1998, 315, 111-117.
- [1.39] T. Nishide, F. Mizukami, Thin Solid Films 1999, 353, 67-71.
- [1.40] T. R. N. Kutty, M. Avudaithai, Res. Bull. 1988, 23, 725-734.
- [1.41] M. M. Wu, G. Lin, D. H. Chen, G. G. Wang, D. He, S. H. Feng, R. R. Xu, Chem. Mater.

2002, *14*, 1974-1980.

- [1.42] O. H. Zhang, L. Gao, *Langmuir* 2003, 19, 967-971.
- [1.43] L. Feng, Y. Chu, J. L. Liu, W. D. Sun, L. Jiang, Chem. J. Chinese. U. 2002, 23, 1567-1569.
- [1.44] K. T. Lim. H. S. Hwang, W. Ryoo, Johnston, K.P. Langmuir, 2004, 20, 2466-2471.
- [1.45] E. Stathatos, P. Lianos, F. DelMonte, D. Levy, D. Tsiouvas, Langmuir, 1997, 13, 4295-4300.
- [1.46] M. Yoshida, M. Lal, N. D. Kumar, P. N. Prasad, J. Mater. Sci. 1997, 32, 4047-4051.
- [1.247] H. Kominami, Y. Takada, H. Yamagiwa, Y. Kera, M. Inoue, T. Inui, *J. Mater. Sci. Lett.* **1996**, *15*, 197-198.
- [1.48] H. Kominami, J. Kato, Y. Takada, Y. Doushi, B. Ohtani, *Catal. Lett.* **1997**, *46*, 235-240.
- [1.49] H. Kominami, J. Kato, S. Murakami, Y. Kera, M. Inoue, T. Inui, B. Ohtani, *J.Mol. Catal., A. Chem.* **1999**, *144*, 165-171.
- [1.50] K. Shimizu, H. Imai, H. Hirashima, K. Tsukuma, Thin Solid Films 1999, 351, 220-224.
- [1.51] J. Schmidt, W. Vogelsberger, J. Solution Chem. 2009, 38, 1267-1282.
- [1.52] X. Peng, A. Chen, J. Mater. Chem. 2004, 14, 2542-2548.
- [1.53] Y. Lei, L. D. Zhang, G. W. Meng, G. H. Li, X. Y. Zhang, C. H. Liang, W. Chen, S. X. Wang, *Appl. Phys. Lett.* **2001**, *78*, 1125-1127.
- [1.54] T. Kasuga, M. Hiramatsu, A. Hoson, T. Sekino, K. Niihara, Langmuir, 1998, 14, 3160-3163.
- [1.55] T. Sasaki, Y. Ebina, Y. Kitami, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 6116-6121.
- [1.56] T. Sasaki, M. Watanabe, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4682-4689.
- [1.57] T. Sasaki, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 1997, 101, 10159 -10161.
- [1.58] T. Sasaki, Y. Ebina, Y. Kitami, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 6116-6121.
- [1.59] T. Tanaka, K. Fukuda, Y. Ebina, K. Takada, T. Sasaki, Adv. Mater. 2004, 16, 872-875.
- [1.60] T. Sasaki, M. Watanabe, H. Hashizume, H. Yamada, H. Nakazawa, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 8329 -8335.

- [1.61] T. Sasaki, F. Kooli, M. Iida, Y. Michiue, S. Takenouchi, Y. Yajima, F. Izumi, B. C.
- Chakoumakos, M. Watanabe, Chem. Mater. 1998, 10, 4123-4128.
- [1.62] D. V. Bavykin, J. M. Friedrich, F. C. Walsh, Adv. Mater. 2006, 18, 2807-2824.
- [1.63] Y. Matsumoto, A. Funatsu, D. Matsuo, U. Unal, J. Phys. Chem. B 2001, 105, 10893-10899.
- [1.64] L. Wang, Y. Omomo, N. Sakai, K. Fukuda, I. Nakai, Y. Ebina, K. Takada, M.
- Watanabe, T. Sasaki, Chem. Mater. 2003, 15, 2873-2878.
- [1.65] H. Tokudome, M. Miyauchi, Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 1974-1977.
- [1.66] B. L. Wang, Q. Chen, J. Hu, H. Li, Y. F. Hu, L. M. Peng, *Chem. Phys. Lett.* **2005**, *406*, 95-100.
- [1.67] Y. Hao, Q. Lai, Z. Xu, X. Liu, X. Ji, Solid State Ionics 2005, 176, 1201–1206.
- [1.68] J. Li, Z. Tang, Z. Zhang, *Electrochem. Commun.* 2005, 7, 62-67.
- [1.69] M. Osada, G. Takanashi, B. Li, K. Akatsuka, Y. Ebina, K. Ono, H. Funakubo, K. Takada, T. Sasaki, *Adv. Funct. Mater.* 2011, 22, 3482-3487.
- [1.70] W. J. Metrz, Phys. Rev. 1949, 76, 1221-1225.
- [1.71] P. P. Phule, S. H. Risbud, Adv. Ceram. Mater. 1988, 3, 183-185.
- [1.72] G. Pfaff, J. Mater. Chem. 1992, 2, 591-594.
- [1.73] C. Lemoine, B. Gilbert, B. Michaux, J. P. Pirard, A. Lecloux, J. Non-Cryst. Solids 1994, 175, 1-13.
- [1.74] D. F. K. Hennings, S. Schremacher, J. Eur. Ceram. Soc., 1992, 9, 41-46.
- [1.75] S. W. Lu, B. I. Lee, Z. L. Wang, W. D. Samuels, J. Crystal Growth 2000, 219, 269-276.
- [1.76] H. J. Chen, Y. W. Chen, Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 473-483.
- [1.77] E. C. M. N. Rahaman, M. Shumsky, J. Mater. Sci. 2001, 36, 4875-4882.
- [1.78] I. J. Clark, T. Taleuchi, N. Ohtori, C. Sinclair, J. Mater. Chem. 1999, 9, 83-91.
- [1.79] Y. Hakuta, H. Ura, H. Hayashi, K. Arai, Mater. Lett. 2005, 59, 1387-1390.
- [1.80] M. Atashfaraz, M. S. Niassar, S. Ohara, K. Minami, M. Umetsu, T. Naka, T. Adschiri, *Fluid Phase Equil.* **2007**, *257*, 233-237.
- [1.81] Y. Hakuta, H. Ura, H. Hayashi, K. Arai, Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 840-846.
- [1.82] J. F. Bocquet, K. Chhor, C. Pommier, Mater. Chem. Phys. 1999, 57, 273-280.
- [1.83] H. Reveron, C. Aymonier, A. L. Serani, C. Elissalde, M. Maglione, F. Cansell,
- Nanotechnology 2005, 16, 1137-1143.
- [1.84] K. Matsui, T. Noguchi, N. M. Islam, Y. Hakuta, H. Hayashi, *J. Crystal Growth* **2008**, *310*, 2584-2589.
- [1.85] T. Suzuki, K. Morito, Y. Iwazaki, Integrated Ferroelectrics 2005, 76, 47-57.
- [1.86] D. J. McClure, J. R. Crowe, J. Vac. Sci. Tech. 1979, 16, 311-314.
- [1.87] I. H. Pratt, S. Firestone, J. Vac. Sci. Tech. 1971, 8, 256-260.
- [1.88] B. S. Kwak, K. Zhang, E. P. Boyd, A Erbil, B. J. Wilkens, J. Appl. Phys. 1991, 69, 767-772.

[1.89] L. A. Wills, B. W. Wessels, D. S. Richeson, T. J. Marks, Appl. Phys. Lett. 1992, 60. 41-43.

[1.90] F. F. Lange, Science 1996, 273, 903-909.

[1.91] W. S. Robert, Chem, Mater. 1997, 9, 2325-2340.

[1.92] M. Kuwabara, N. Kurata, M. Ogata, Y. Yamashita, M. Arimura, Ceramics 2001, 36, 415-416.

[1.93] F. Nakasone, K. Kobayashi, T. Suzuki, Y. Mizuno, H. Chazono, H. Imai, *J. J. Appl. Phys.* **2008**, *47*, 8518-8524.

[1.94] F. Nakasone, T. Suzuki, K. Kobayashi, K. Kawamura, Y. Mizuno, H. Kishi, H. Chazono, H. Imai, *Proceedings of Materials Science and Technology* 2008, 254-261.

[1.95] T. Suzuki, Y. Takezawa, F. Nakasone, Material Integration 2010, 23, 12.

第2章

寒天ゲルを用いた層状チタン酸の合成

第2章 寒天ゲルを用いた層状チタン酸の合成

2.1 はじめに

第2章、第3章では、高分子ゲルマトリクスを反応場としたチタン酸ナノ結晶の作製と 形態制御について論じる。二酸化チタンをはじめとするチタン酸化物やチタン酸塩の実用 性の高さは第1章で述べたとおりであるが、いずれの材料においても、ナノスケールでの 形態制御は必要不可欠であり、現在までに数多くの研究が成されている^[2,1-6]。Imai らはこれ まで、モデルケースとして、高分子ゲルを原料の拡散律速場として用いることで、ナノか らマイクロスケールまで高次に渡って構造が制御された各種結晶の合成に成功している。 高分子ゲルにより原料の拡散が抑制されて結晶の溶解度制御が容易になることや、高分子 の編み目構造による結晶成長の抑制によりナノスケールで形態制御された結晶が得られた ものと考えられる。この反応原理を用いることで、新たな材料合成技術の確立が達成され、 様々な材料のナノスケールにおける形態制御が容易かつ安価に実現できるものと考え、本 研究を進めている。

本章では、寒天ゲルを反応場として用いることで得られる高次階層構造を有するチタン 酸ナノシートの合成について詳細をまとめる。チタン酸ナノシートは、リチウムイオン二 次電池の負極材料や誘電体薄膜としての実用化が期待される物質であるが、これまでのチ タン酸ナノシートの合成法は、層状チタン酸の層間剥離が主だった^[2,7-11]。この方法はトッ プダウン的な合成法と言える。それに対し、本研究では、イオンから組み上げたボトムア ップアプローチによりチタン酸ナノシートの合成に成功した。ボトムアップアプローチを 用いることで、より緻密な形態制御が可能であり、各種デバイスへの応用の際に、目的に 応じた形態の合成が可能であるなど、本研究方法で得られたチタン酸ナノシートの価値は 大きい。また、得られたチタン酸ナノシートに、比較的低温での熱処理を施すことにより、 ナノシート形態を保持した状態でのアナターゼ型二酸化チタンへの構造転移を試みた。さ らに、チタン酸塩の代表としてチタン酸バリウムに着目し、チタン酸バリウムナノシート の合成の可能性について検討を行った。

2.2 実験方法

2.2.1 原料

Table 2-1.に本実験で用いた試薬を示す。

Material	Chemical formula	Purity	Manufacturer
Titanium(IV) fluoride	TiF ₄		Sigma-Aldrich corp.
Ammonia solution	NH₄OH	28 %	Junsei Chemical Co., Ltd.
Agar powder			Junsei Chemical Co., Ltd.
Barium chloride dihydrate	BaCl₂·2H₂O	> 98.5 %	Kanto Chemical
Ethanol (dehydrated)	C_2H_5OH	> 99.5 %	Kanto Chemical
Barium hydroxide octahydrate	Ba(OH)₂·8H₂O	> 98.0 %	Kanto Chemical
Toluidine Blue	$C_{15H_{16}N_3SCI}$		Waldeck GmbH & Co. KG. Division Chroma
Methylene Blue	$C_{16}H_{18}N_3CIS\cdot 3H_2O$		Yoneyama Yakuhin Kogyo Co., Ltd.

Table 2-1. List of reagents used in this chapter.

2.2.2 実験手順

ポリプロピレン製 50 cm³ 容器に純水 10 cm³、フッ化チタン 0.4 - 2.0 g (0.3 - 1.6 mol/dm³) を加えて 2 時間攪拌した。別容器に作製したゾル状寒天水溶液(寒天粉末 3.0 g/ 純水 100 cm³) 10 g にフッ化チタン水溶液を加え、1 分間攪拌し、4 ℃ で一晩静置した。得られたチ タン酸前駆体含有ゲルを、pH 調整したアンモニア水溶液 450 cm³ (ポリスチレン製 600 cm³ 容器) に浸漬し、25 ℃ で 1 週間静置した。ゲル内に得られた生成物を取り出すため、温水 中で寒天を再溶解させた。その後、ろ過し、60 ℃ で乾燥させることで生成物を得た。

2.2.3 評価

得られた粒子の評価を以下に示す方法により行った。

1) X 線回折

得られた粉末試料の生成相および結晶性の評価は、粉末 X 線回折装置 RAD-C(RAD-C, CN-2013, 株式会社リガク)により行った。測定条件は、線源 CuKα、電圧 50 kV、電流 150 mA、 発散スリット・散乱スリット 1/6 deg.、測定 2θ 範囲 5 – 70°とした。

2) 形態観察

粒子の形態観察は、走査型電子顕微鏡(FE-SEM, 日立 S-4700, FEI-SIRION, FEI)と透過型電 子顕微鏡(FE-TEM, TECNAI F20, FEI)を用いて評価した。SEM 観察を行う前処理として、真 空蒸着器(E-1010, 日立製作所)による Au-Pt 合金のイオンスパッタリング、あるいは、オス ミウムプラズマコーティング装置(HPC-1S, 真空デバイス)によるオスミウムコートを行っ た。また、TEM 観察を行う際には、乾燥させた試料をメノウ乳鉢で粉砕し、純水に少量加 えて充分に分散させ、これをコロジオン膜付銅メッシュに滴下し、常温で乾燥させること でサンプルとした。

3) 細孔径分布·比表面積測定

脱気装置(VacPrep061, Micromeritics)により、試料を 160°C で 2 時間脱気処理した後、窒素 吸着機(Tristar3000, Micromeritics)を用いて細孔径分布、比表面積を測定した。0.01 – 0.99 ま で相対圧を変化させることで吸着等温線を作成し、得られたデータをもとに BET 法を用いることで比表面積、BJH 法を用いることで細孔容積を求め、細孔径分布および積算細孔容 積曲線を作成した。

4) 赤外線透過率測定

粉末試料を KBr の粉末と混合、加圧してペレットを作製し、赤外分光光度計(FT-IR, FTS-60A/896, 日立製作所)を用いて、領域 400 – 4000 cm⁻¹の赤外線透過率を測定した。

5) 拡散反射スペクトル測定

粉末状の試料に対して、紫外可視スペクトルを得るため、紫外可視分光光度計(JASCO V-560,日本分光)を用いることでスペクトルを得た。

2.3 実験結果と考察

2.3.1 寒天ゲル内に得られるマクロな形態への影響

チタン前駆体を含有した寒天ゲルを、アンモニア水溶液中に約 1 週間浸漬すると、ゲル 内に白色物質が析出した。フッ化チタン濃度・アンモニア水溶液の pH の変化により、ゲル 内に得られる白色物質のマクロ構造は Figure 2-1 に示すような各種形態を取った。反応後の アンモニア水溶液の pH と生成物の関係を調べたところ、反応後に pH11.0 以上の高いアル カリ性を保持した場合は白色物質が得られることが確認された。一般的に、チタン含有水 溶液内での反応においては、pH と濃度を変化させることによって、Figure 2-2 の相図に示す ようにチタン酸化物系物質が析出する(化学溶液成長法)。寒天ゲル内においても、この相図 の TiO₂(s)の析出領域に達した領域で白色物質が得られており、反応場を寒天ゲルに変更し ても、化学溶液成長法と同様に沈殿物が形成されたと考えられる。



Figure 2-1. Several macro morphologies of products obtained in agar gel.



Figure 2-2. TiO₂ precipitation region in case of using TiF₄ as precursor.

さらに、寒天ゲル内の白色物質は、Figure 2-3 に見られるように、いくつかの特徴的なマクロ形態を取っていた。特に、アンモニア水溶液の初期 pH が 11.0 以上の試料では、多少の 差異があるものの、リーゼガングバンド^[2.12]と呼ばれる周期沈殿構造を有する白色層が観察 された。



Figure 2-3. Characteristic structures of; (a) Liesegang band obtained in case of $TiF_4 \ 1.0 \ mol/dm^3$ and $NH_4OH \ pH \ 12.0$, and (b) needle structure obtained in case of $TiF_4 \ 1.3 \ mol/dm^3$ and $NH_4OH \ pH \ 12.0$

以下に、これらの構造体の生成メカニズムを考察する。チタン含有寒天ゲル上部からア ンモニア水を浸透させると、ゲル内の pH が上昇し、Figure 2-2 に示した相図においてチタ ン酸化物の安定相に移行する。pH が充分に上昇したゲル最上部において結晶化が始まり、 そのすぐ下方に存在するチタン溶解種も結晶に取り込まれて結晶領域が成長する。ゲル最 上部で結晶成長が進んでいる間にも、アンモニア水はゲル下方に浸透し、ゲル下方の pH が 上昇する。しかし、1 層目の結晶成長に下方のチタン溶解種が取り込まれたため、チタン溶 解種の低濃度領域が形成され、pH が充分に上昇しても、部分的に結晶が析出しない。さら にゲル下方の、チタン溶解種が充分に存在する領域にアンモニア水が到達して pH が上昇し た場所でようやく次の結晶析出が始まる。つまり、ゲル最上部の第1層と第2層との間に 間隔が生じる(Figure 2-4)。これが、リーゼガングバンドの形成メカニズムと考えられる。



Figure 2-4. Mechanism for the formation of white precipitate.

チタン溶解種の濃度が低い試料や、アンモニア水の pH が低い試料では、第1層のみが生成した。第1層、第2層ともに形成されたのは、アンモニア水の初期 pH が pH12.0 以上の試料すべてと、pH11.0・フッ化チタン濃度 0.3 mol/dm³の試料だった。このことは、チタン溶解種濃度が高ければ第2層まで析出するのではなく、チタン溶解種濃度とアンモニア水 pH とのバランスが重要であることを示している。また、第2層が形成された後もゲル内の pH はさらに上昇し、第1層と第2層の間に少量残存したチタン溶解種が、針状や層状の白色物質を形成するものも存在した。

2.3.2 寒天ゲル内に得られるミクロな形態への影響

次に、寒天ゲル内で得られた白色物質を取り出し、FE-SEM によりミクロ形態を調べた。 その結果、フッ化チタン濃度、アンモニア水の初期 pH、ゲル内における沈殿物の生成箇所 によって異なる形態を有する、数百 nm スケールの様々構造体が形成されていることが確認 された(Figure 2-5 – 2-8)。

OH の拡散によりリーゼガングバンドが得られた、フッ化チタン濃度 0.6 – 1.0 mol/dm³、 アンモニア水の初期 pH12.0 の試料では、ゲル最上部に 300 – 500 nm の球状粒子が多数観察 された(Figure 2-5)。また、リーゼガングバンドの中央部では、500 – 600 nm の板状物質が (Figure 2-6)、ゲル最下部には不定形ながら微小な物質から構成されている形態が(Figure 2-7) 観察された。さらに、フッ化チタン濃度 1.0 – 1.3 mol/dm³、アンモニア水の初期 pH12.5 の試 料では、直径 1 – 5 µm、長さ数 mm の中空針状物質が得られた(Figure 2-8)。これらの構造体 は、いずれも 10 nm 程度の厚さを有するシート状の形態から構成されていた。以上のよう な様々な高次階層構造は、チタン種や OH の拡散が制限された寒天ゲルマトリクス内という 特殊な環境下で、自己組織化的に成長して得られたと考えられる。球状粒子や板状物質は、 比較的高い過飽和状態下にある寒天ゲル上部で得られており、10 nm 程度のシート状の物質 が各形態に放射状に成長することにより形成されたものと予想される。さらに、球や板の 大きさは、寒天ゲルネットワークのポアサイズに相当するため、各構造体表面に寒天の有 機分子が関与して成長が制限されたと考えられる。一方、中空針状物質は、テンプレート 物質が存在した状態で、10 nm 程度のシート状の物質が自己組織化により成長して針状形態 が得られ、テンプレート部分が再溶解したのではないかと推測される。今回得られた中空 針状物質に似た研究例が、中空シリカファイバーの形成で報告されている^[2.13]。しかしなが ら、中空針状物質が得られた原因解明については、更なる研究が必要である。

以上のように、フッ化チタン濃度とアンモニア水の初期 pH によって、寒天ゲル内で得ら れたマクロな構造のみならず、数百 nm 単位のミクロな形態まで、様々な構造体が得られる ことが確認された。いずれも、10 nm 程度の厚さのシート状の物質から構成されており、シ ート物質の更なる解析が期待される。そこで、「2.3.3 新規チタン酸ナノシートの構造解析」 では、フッ化チタン濃度 1.0 mol/dm³、アンモニア水初期 pH12.0 の条件で得られた球状粒子 を例に、シート物質の構造解析を行った結果を示す。



Figure 2-5. Photograph (a) and FESEM images (b, c) of higher-order morphologies of spherical particles.



Figure 2-6. Photograph (a) and FESEM images (b, c) of higher-order morphologies of plate particles.



Figure 2-7. Photograph (a) and FESEM images (b, c) of higher-order morphologies of infinite particles.



Figure 2-8. Photograph (a) and FESEM images (b, c) of higher-order morphologies of hollow fibers.

2.3.3 新規チタン酸ナノシートの構造解析

寒天ゲル内に得られた白色物質を取り出して寒天を溶かしたのち観察したミクロ構造は、 場所によって異なる形態を有していた(Figure 2-5 – 2-8)が、いずれも 5 – 10 nm 程度の厚さの シート状物質から構成されていた。フッ化チタン濃度 1.0 mol/dm³、アンモニア水初期 pH12.0 の条件で得られた 300 – 500 nm の球状粒子を例に、5 – 10 nm のナノシートの構造解析を行 った結果を示す。

TEM 観察より、このシートは約1nm の隙間を有する層状構造を取っていることが確認さ れた(Figure 2-9)。XRD パターンにおける低角側のピークからも、TEM 観察結果と同様に、 層状構造を取ることが示された(Figure 2-10)。また、高角側に得られたブロードなピークよ り、このシート状物質は、H₂Ti₃O₇で示されるチタン酸ナノチューブと同じパターンを有す る物質であると予想された^[2.14]。第1章で述べたように、ナノシート状のチタン酸としては、 佐々木らにより作製された単層剥離チタン酸ナノシートが知られているが^[2.7]、XRD 測定結 果から、佐々木らの剥離シートとは異なり、TiO₆ モノレイヤーの単層構造ではないことが 確認された。



Figure 2-9. FETEM images of layered titanate nanosheets; (a) overall image of 5 – 10 nm nanosheets; (b) cross-sectional image showing an interlayer spacing of about 1 nm.



Figure 2-10. XRD pattern of titanate nanosheets produced in agar gel.

得られた粉末の比表面積は、420 m²/g と非常に高く、Kasuga らの報告にあるチタン酸ナ ノチューブの比表面積 400 m²/g と同程度であり^[2,4]、この点からもチタン酸ナノチューブの 特徴と良く似ていた。高い比表面積が計測される理由として、Figure 2-9(b)にも見られるよ うに、窒素分子が入り込むのに充分な約 1 nm の隙間がナノシート層間に存在することが考 えられる。FTIR スペクトルの結果より、1400 cm⁻¹ に N-H 伸縮振動に由来する吸収ピークが 得られており、アンモニウムイオンの存在が示唆された(Figure 2-11)。エネルギー分散型 X 線分析(EDX)測定からも、チタニウムイオンと同程度のモル数の窒素分子が検出されており、 これらの結果から、負に帯電しているチタン酸ナノシートの層間に、カウンターカチオン としてアンモニウムイオンが存在すると考えられる。



Figure 2-11. FT-IR spectrum of titanate nanosheets in agar gel.



Figure 2-12. EDX spectrum of titanate nanosheets in agar gel.

得られたチタン酸ナノシート粉末の拡散反射スペクトル(DSR)において、吸収端は約350 nm に存在した(Figure 2-13)。この吸収端位置は、バルク状のカチオン性層状チタン酸(H_{0.7}Ti_{1.825□0.175}O₄·H₂O(□:空孔))で得られるものとほぼ同様だった。一方で、層間剥離されて得られた佐々木らのチタン酸単層ナノシートのコロイド懸濁液では、量子サイズ効果の影響で、300 nm 以下の波数に吸収端が観察される^[2.15]。これらのことから、本研究で作製したチタン酸ナノシートは、単層化がなされていないと考えられる。



Figure 2-13. DSR spectrum of titanate nanosheets in agar gel.

以上の構造解析結果より、本研究では、ピラーにより安定化された層状粘土物質^[2.16]のよ うな高い比表面積を有する多孔質構造体として、層間にアンモニウムイオンを有する新規 チタン酸ナノシートの合成が達成された。上述したように、二酸化チタンを水酸化ナトリ ウム中で水熱処理することで得られるチタン酸ナノチューブ(H,Ti₃O₇)と同じような XRD パ ターンを有する物質であったことから^[2.14]、本研究で作製されたチタン酸ナノシートは、 (NH4)2Ti₃O7や(H,NH4)2Ti₃O7で示され、チタン酸アンモニウムと命名することができるので はないかと考察される。このナノシートは、TiO₆ 八面体が連なることで構成される、アニ オニックな表面を有するチタン酸単層シートが、アンモニウムイオンをカウンターカチオ ンとして層間に挟みこみ、数層重なることで 10 nm 以下のナノシートとして安定した状態 で存在していると考えられる。剥離されたチタン酸単層シートの集合体により、251 m²/g 程度の比表面積を有する層状チタン酸の形成に関する研究結果が報告されている^[2.15]。しか しながら、この研究では、一度剥離したものを再び数層重ねることで、目的のチタン酸を 作製しており、トップダウンプロセスの使用により合成したと言える。今回の研究のよう に、ボトムアッププロセスを用いることでチタン酸単層シートが数層重なったナノシート を作製したことは極めて新規性の高い結果であり、高い比表面積を有する高次階層性形態 を持つ優れた構造体の合成が可能になった。

2.3.4 チタン酸ナノシート層間への有機色素の導入

新規チタン酸ナノシートの構造解析の一環として、シート層間への有機色素の導入を試 みた。チタン酸ナノシートは、アニオニックな表面を有する構造を取っており、カチオン 性有機色素とチタン酸ナノシートが静電的に作用することで、シート層間への有機色素の 導入が可能であると考えられる。

有機色素の導入に用いるチタン酸ナノシートには、300 – 500 nm の球状粒子部の粉末を用いた。粉末試料 0.2 g を 30 cm³ スチレン容器の底に敷き詰め、メチレンブルー、トルイジン ブルーの水溶液 30 cm³ を加えて 25 ℃の恒温槽内で 4 日間静置した。有機色素が導入された チタン酸ナノシートを取り出すため、上澄みの有機色素水溶液部分を取り除き、純水で洗 浄したのち 60 ℃で乾燥して粉末化した。

実験の結果、チタン酸ナノシート層間には、多量のカチオン性有機色素の導入が可能で あることが確認された。チタン酸ナノシート粉末1gに対して、メチレンブルーは75 mg、 トルイジンブルーは76 mgと、非常に多量の色素が導入された。約1 nm のチタン酸ナノシ ート層間にすべての色素分子が導入されたと仮定すると、チタン酸ナノシート層間を色素 分子が占める割合は、メチレンブルーで約14%、トルイジンブルーで約16%である。ほか にも、ゲンチアナバイオレットB、ローダミンBなどのカチオン性有機色素も導入できる ことが確認されたが、メチレンブルーやトルイジンブルーほどの量を導入することが出来 なかった。その原因として、各色素分子の構造によるものと考えられる。つまり、色素分 子の表面積と導入量は反比例の関係にあり、比較的小さな構造を有するメチレンブルーや トルイジンブルーは多量に導入されたが、大きな平面構造を有するゲンチアナバイオレッ トBや、芳香環部分が3次元的に回転できる構造を取るローダミンBでは、導入量が限定 されてしまったと考えられる(Figure 2-14)。



Figure 2-14. Molecular structure of several organic dyes.

多量の導入が可能だったメチレンブルー、トルイジンブルーの、チタン酸ナノシート層 間における存在状態を調べるため、各種構造解析を行った結果を以下に示す。一例として、 メチレンブルーについて記述する。

FTIR スペクトルを取得したところ、メチレンブルーの導入量を増やすことによって、800 – 1600 cm⁻¹の指紋領域に見られるメチレンブルー特有の吸収ピークがはっきりと確認でき るようになった(Figure 2-15; 点線部分)。それに対し、1400 cm⁻¹の N-H 伸縮振動に由来する 吸収ピークが相対的に小さくなった。また、チタン酸粉末の表面に物理吸着した色素を取 り除くため、純水およびエタノールにより色素導入後のチタン酸粉末を洗浄したが、色素 の脱離が起こらなかった。以上の結果より、カチオン性有機色素であるメチレンブルー分 子は、アニオニックな表面を有するチタン酸ナノシート層間に存在するアンモニウムイオ ンとイオン交換することで層間に導入されたと考えられる。



Figure 2-15. FT-IR spectra of before and after adsorption of methylene blue molecules into titanate nanosheets.

層状チタン酸へのカチオン性分子のインターカレーションについては過去に研究例が報告されている^[2.17]。その報告によると、一般的に、導入する分子の大きさによってチタン酸層間のスペースは拡張する。しかしながら、メチレンブルー導入前後での粉末の XRD パターンを測定したところ、作製されたチタン酸ナノシートに関しては、色素分子の導入を行っても、層間の間隔は変わらなかった(Figure 2-16)。これは、メチレンブルー色素分子に限らず、トルイジンブルー、ゲンチアナバイオレット B、ローダミン B でも同様の結果が得られた。



Figure 2-16. XRD patterns of titanate nanosheets in which interlayer methylene blue is intercalated with respective amounts (mg).

また、メチレンブルー分子を導入したチタン酸ナノシート粉末の拡散反射スペクトルを 測定したところ、メチレンブルーの導入量が増えるにつれ、モノマーとして存在していた メチレンブルー分子は、H 会合体という特殊な会合状態を取ることがわかった(Figure 2-17)^[2.17]。この会合状態は、指紋領域における FTIR スペクトルを見ることによっても確認 することが出来る(Figure 2-18)。メチレンブルー分子を限界量含有したチタン酸ナノシート 粉末の FTIR スペクトルでは、芳香環の炭素 C と窒素 N との結合の伸縮振動に由来する吸 収ピークが、本来メチレンブルー粉末を測定したときに現れるはずである 1341 cm⁻¹、1191 cm⁻¹に加えて、これらがブルーシフトした 1350 cm⁻¹、1220 cm⁻¹にも同様の振動に由来する であろう吸収ピークが見られた。このことは、メチレンブルー分子内でカチオン性を帯び ている窒素原子部分が、チタン酸ナノシートのマイナスと相互作用を起こしていることを 示唆している。以上の結果から、本研究により作製されたチタン酸ナノシートは、通常の 層状物質と異なり、層間が固定されているため、ガス分子や色素分子の吸収や導入が容易 に行えたのではないかと考えられる。つまり、シート層間が TiO₆ ユニットによって一部連 結しており、そのためシート間隔が変化することなく、多孔質構造を保持するものと予想 される。



Figure 2-17. UV-vis spectra of titanate nanosheets in which interlayer methylene blue is intercalated with respective amounts (mg).



Figure 2-18. FTIR spectrum of titanate nanosheet containing metylene blue 75 mg.

2.3.5 熱処理によるチタン酸ナノシートの構造変化

次に、チタン酸とアナターゼ型に酸化チタンとの構造の類似性に着目し、熱処理による チタン酸からアナターゼ型に酸化チタンへの転移を試みた。チタン酸はチタンに対して酸 素が六配位した八面体が二次元方向に連なることで層状構造を形成するのに対し、アナタ ーゼ型二酸化チタンでは、チタンに対して酸素が六配位した八面体が基本構造である点は チタン酸と同様で、この八面体が三次元方向に連なる構造を取る(Figure 2-19, 2-20)。



Figure 2-19. Crystal structure of titanate.



Figure 2-20. Crystal structure of anatase phase titanium dioxide.

チタン酸ナノシート粉末を、100-450 ℃まで各温度に設定した電気炉で2時間熱処理したところ、生成物は Figure 2-21 に示すように、チタン酸からアナターゼ型二酸化チタンへと構造転移した。この結果より、350 ℃と、比較的低温でチタン酸からアナターゼへの結晶形の転移が起こったことが確認された。この構造転移は、以下の2つの特徴を持って起こったと考えられる。

まず、一つ目の特徴として、熱処理なしから 300 ℃までのパターンの中で、チタン酸の 層間距離を示す 20=9°のピークが、熱処理温度の上昇とともに高角側にシフトしているこ とがわかる。これは、はじめ約 1.0 nm だった層間が、熱処理とともに狭まったことを示し ている。さらに、二つ目の特徴として、300 ℃におけるチタン酸の XRD パターンから、350 ℃ のアナターゼ型二酸化チタンの XRD パターンへの変化が急激であることが挙げられる。こ れは、二次元的な広がりを持ったチタン酸の層間が狭くなり、TiO₆ 八面体ユニット同士が 接近することで、一気に三次元的に大きなアナターゼ型二酸化チタンの結晶が生成したた めであると考えられる。



Figure 2-21. XRD patterns of titanate nanosheets calcined by several temperature.

以上の結果より、当初の予想どおり、チタン酸の層間隔が狭小化することにより、容易 にアナターゼ型二酸化チタンへの構造転移が達成されることが確認された。このことは、 FTIR 測定結果からもサポートできる。つまり、Figure 2-22 に示すように、300 ℃までのチ タン酸では、1400 cm⁻¹の N-H 伸縮振動に由来する吸収ピークがはっきりと確認できるのに 対し、350 ℃以上のアナターゼ型二酸化チタンに転移した後の試料では、吸収ピークがか なり縮小していることがわかる。これは、N-H 伸縮振動が、層間のアンモニウムイオンに 相当しており、チタン酸ナノシートの層間隔が狭まることでアナターゼ型二酸化チタンに 構造転移する際に層間から脱離したためであると考えられる。



Figure 2-22. FTIR spectra of titanate nanosheets calcined by several temperature.

また、熱処理後のミクロ形態は、温度の上昇とともに変化した。Figure 2-23 に示すように、 350 ℃まではシート構造が保持されているが、それ以上の熱処理では、シートが凝集した 構造が観察された。また、350 ℃熱処理後のシートに関しては、20 nm 以上にまで厚くなっ ているにも関わらず、比表面積は 150 m²/g 以上の高い値を示したことから、一部でチタン 酸ナノシートの層間の固定により隙間が保持され、多孔質状態が保たれたのではないかと 推測される。



Figure 2-23. SEM images of nanosheets powder calcined by several temperature; (a) 150 °C, (b) 250 °C, (c) 350 °C, and (d) 450 °C.

2.3.6 チタン酸ナノシートを使用したチタン酸バリウムへの転換

「1.5.3 ナノ粒子堆積法を用いた誘電体薄膜の作製」に述べたとおり、ナノ粒子堆積法を 用いることにより、高い性能を有するチタン酸バリウム誘電体薄膜が形成されることが確 認されている。これまでの研究では、ゾルゲル法を用いることで5nm程度の高結晶化ナノ 粒子のチタン酸バリウムを合成し、単分散スラリー化して電極基板上に塗布・熱処理を繰 り返すことで一定の膜厚を有する誘電体薄膜を形成した。得られた薄膜は、下部電極基板 に対して結晶学的に配向する方位を向いたものが隣接の粒子を取り囲みながら優先的に成 長し、部分的に配向した柱状構造を有する緻密膜として得られた。本研究では、さらに容 易かつ簡便に高い性能を有する誘電体薄膜の形成を志しており、その一端としてチタン酸 バリウムナノシートのシード層としての使用が極めて有効なのではないかと考えている。 つまり、チタン酸バリウムナノ粒子を用いて基板上で配向膜を形成するに当たり、同じ結 晶型を有するチタン酸バリウムナノシートを電極基板上に敷き詰めておくことにより、こ れが一方向に配向したシード層として機能し、チタン酸バリウムナノ粒子を塗布・熱処理 した際に、粒子の成長がスムーズに進み、より低温での配向緻密膜の形成が可能になるも のと予想している。また、これまで、ナノ粒子堆積法には5nm程度のチタン酸バリウムナ ノ粒子を用いていたが、シード層が加わることにより、基板上での配向成長が容易に起こ るため、10 nm 程度まで粒子径を上げても、これまでと同様の、高い配向性・特性を有する 誘電体薄膜の形成につながるのではないかと期待している。以上のことから、誘電体薄膜 のシード層としての使用を目的に、本研究では、寒天ゲル内で得られた新規チタン酸ナノ シートの、チタン酸バリウムナノシートへの変換を試みた。過去に、層状チタン酸を用い ることでチタン酸バリウムへの変換を試みた研究例がいくつか存在する^[2,18-21]。これらの研 究では、いずれも水熱法を用いており、バリウムイオンがイオン交換により層状チタン酸 の層間に入り込み、低温での水熱処理によってチタン酸バリウムに構造転移することが確 認されている。しかしながら、得られたチタン酸バリウムの形態は板状や粒子状であり、 ナノシート形態が得られたとの報告はなされていない。本研究においても、過去の研究例 ^[2,9-2,12]に倣い、チタン酸ナノシート層間のイオン交換、チタン酸ナノシートの水熱法・ソル ボサーマル法によりチタン酸バリウムナノシートの形成を試みた。

まず、チタン酸ナノシート層間のイオン交換によるチタン酸バリウムナノシートへの変換について述べる。チタン酸ナノシート層間にバリウムイオンを挿入し、熱処理によりシート形態を保持した状態でチタン酸バリウムに転移するか否か検討を行った。バリウム源には、塩化バリウムを用いた。チタン酸ナノシート粉末 0.49 g と塩化バリウム 3.66 g(0.3 mol/dm³)を純水 50 cm³に加えて攪拌し、室温で 12 時間静置した。得られた懸濁液を水洗浄して、60 ℃で乾燥し、300 ℃で 2 時間熱処理することで目的の粉末を得た。得られた粉末の形態を SEM により観察したところ、イオン交換直後、350 ℃での熱処理後ともにナノシート形態が保持されていた(Figure 2-24)。また、XRD パターンより、イオン交換直後には結晶型はチタン酸バリウムのピークが確認された(Figure 2-25)。チタン酸バリウムであるとの実験的証拠は現在のところ無いが、得られた粉末の 90 %以上がナノシート形態を取っていることから、Figure 2-24 で示したナノシートが得られたのではないかと考えられる。 イオン交換時に使用するバリウムナノシートが形成されるものと予想される。



Figure 2-24. SEM images of obtained powders; (a) after ion exchange, (b) after thermal treatment at 300 °C.



Figure 2-25. XRD patterns of obtained powders.

次に、チタン酸ナノシートをバリウム源とともに水熱処理することで、チタン酸バリウムに変換可能か否かの検討を行った。バリウム源には、水酸化バリウム八水和物を用いた。 チタン酸ナノシート粉末 0.49 g と水酸化バリウム八水和物 4.73 g(0.3 mol/dm³)を純水 50 cm³ に加えて攪拌し、テフロン製オートクレーブに移し変えて 200 ℃で 12 時間水熱処理した。 得られた懸濁液を水洗浄し、60 ℃で乾燥することで目的の粉末を得た。得られた粉末は、 イオン交換後と異なりナノシート形態が保持されておらず、200-300 nm の球状粒子で構成 されていた(Figure 2-26)。結晶型を確認したところ、完全にチタン酸バリウムに転移してお り、溶解再析出により反応が進行したものと考えられる(Figure 2-27)。



Figure 2-26. SEM image of obtained powder after hydrothermal treatment at 200 °C for 12 h.



Figure 2-27. XRD pattern of obtained powder after hydrothermal treatment at 200 °C for 12 h.

さらに、溶媒にエタノールを加えて、ソルボサーマル法により、チタン酸バリウムへの 転換を試みた。バリウム源には、水酸化バリウム八水和物を用いた。チタン酸ナノシート 粉末 0.49 g と水酸化バリウム八水和物 4.73 g(0.3 mol/dm³)を純水 25 cm³ とエタノール 10 cm³ の混合溶媒に加えて攪拌し、テフロン製オートクレーブに移し変えて 150 ℃で 9 時間熱処 理を行った。得られた懸濁液を水洗浄し、60 ℃で乾燥することで目的の粉末を得た。水溶 媒を用いた反応では、溶解再析出が起こってしまい、ナノシート形態を保持できなかった が、有機溶媒を用いても同様にナノシートは観察されなかった(Figure 2-28)。しかしながら、 エタノールを加えたことで、反応性が低下し、一次粒子径 20 – 30 nm の微粒子から構成さ れる数百 nm の球状粒子が得られた。また、XRD パターンより、これらの粒子はチタン酸 バリウムに転移していることが確認された。



Figure 2-28. SEM images of obtained powder after solvothermal treatment at 150 °C for 9 h.



Figure 2-29. XRD pattern of obtained powder after solvothermal treatment at 150 °C for 9 h.

以上の結果より、チタン酸バリウムへの転換は、水熱法やソルボサーマル法を用いるこ とで、容易に結晶型の転移自体は行えるものの、ナノシート形態を保持することが困難で あることが確認された。第4章で論じているように、液相法によるチタン酸バリウムの合 成に関しては、ゾルゲル法の原料を変換するに当たり、固相法のようにチタン骨格の内部 にバリウム源が侵入することで反応が進むことが確認された。ただし、このようなトポタ キシャル的反応が進むのは、限られた合成条件に限ると考えられ、原料の高濃度化・低温 でのエージング時間の確保などが重要と予想される。チタン酸バリウムナノシートの合成 に関しても同様に、バリウムの層間への進入と結晶構造の変換は、限られた条件でのみ成 立するものと考えられる。第4章での実験条件に倣い、さらに検証を進めることで、チタ ン酸バリウムナノシートの水熱法・ソルボサーマル法による合成が達成されるものと期待 される。一方で、イオン交換を用いることで、ナノシート形態を保持した状態で一部チタ ン酸バリウムに転移しており、こちらに関してもナノシート化が達成されると考えられる。

2.4 結論

寒天ゲルを反応場として用いることで、マクロからミクロに渡り多様な形態を有するチ タン酸の合成が可能になった。いずれも、5 – 10 nm のナノシートから構成されており、ナ ノシートの集合体が球状や板状、針状などの二次形態を有していた。各種構造解析の結果、 ナノシートは、TiO₆ 八面体が 2 次元方向に成長した単層シートが、数層重なることで形成 されており、シート層間には原料由来のアンモニウムイオンの存在が示唆され、新規チタ ン酸ナノシートの合成に成功したと言える。

得られたチタン酸ナノシート層間には、アンモニウムイオンとのイオン交換により各種 カチオン性有機色素の導入が可能だった。特に、メチレンブルーやトルイジンブルーなど の色素分子は、ナノシート層間でH会合体という特殊な会合状態を取ることが確認された。 多量の色素導入後にも、層間隔の変化が見られなかったことから、シート層間が TiO₆ ユニ ットによって一部連結しており、多孔質構造が保持されているものと考えられた。

350 ℃と比較的低温な熱処理で、ナノシート形態を保持したままチタン酸からアナター ゼ型二酸化チタンへの結晶転移が可能だった。どちらも、結晶の基本構造が TiO₆ 八面体ユ ニットの連結により構成されているため、チタン酸ナノシートの層間のアンモニウムイオ ンが熱により抜けることで層間隔が狭まり、結晶型が変わったものと考えられる。また、 層間のイオン交換により、ナノシート形態を保持した状態でのチタン酸バリウムへの構造 転移が可能であることが確認された。

参考文献

- [2.1] Y. V. Kolenko, K. A. Kovnir, A. I. Gavrilov, A. V. Garshev, J. Frantti, O. I. Lebedev, B. R. Churagulov, G. V. Tendeloo, M. Yoshimura, *J. Phys. Chem. B* **2006**, *110*, 4030-4038.
- [2.2] G. H. Du, Q. Chen, R. C. Che, Z. Y. Yuan, L. M. Peng, Appl. Phys. Lett. 2001, 79, 1423403.
- [2.3] P. Hoyer, *Langmuir* **1996**, *12*, 1411-1413.
- [2.4] T. Kasuga, M. Hiramatsu, A. Hoson, T. Sekino, K. Niihara, Langmuir, 1998, 14, 3160-3163.
- [2.5] T. Sasaki, Y. Ebina, Y. Kitami, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 6116-6121.
- [2.6] L. Wang, Y. Omomo, N. Sakai, K. Fukuda, I. Nakai, Y. Ebina, K. Takada, M.
- Watanabe, T. Sasaki, Chem. Mater. 2003, 15, 2873-2878.
- [2.7] T. Sasaki, M. Watanabe, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4682-4689.
- [2.8] T. Sasaki, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 1997, 101, 10159 -10161.
- [2.9] T. Sasaki, Y. Ebina, Y. Kitami, M. Watanabe, J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 6116-6121.
- [2.10] T. Tanaka, K. Fukuda, Y. Ebina, K. Takada, T. Sasaki, Adv. Mater. 2004, 16, 872-875.
- [2.11] T. Sasaki, M. Watanabe, H. Hashizume, H. Yamada, H. Nakazawa, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 8329 -8335.
- [2.12] R. E. Liesegang, Naturwiss. Wochenschr. 1896, 11, 353-362.
- [2.13] N. Kaneko, N. Lyi, K. Kurashima, T. Matsumoto, T. Fujita, K. Kitamura, *Chem. Mater.* 2004, *16*, 3417-3427.
- [2.14] Q. Chen, G. H. Du, S. Zhang, L.-M. Peng, Acta Crystallogr. B 2002, 58, 587-593.
- [2.15] N. Kaneko, N. Lyi, K. Kurashima, T. Matsumoto, K. Kitamura, *Chem. Lett.* 2004, *33*, 1486-1487.
- [2.16] J. Bujdak, N. Lyi, T. Fujita, Clay Miner. 2002, 37, 121-133.
- [2.17] T. Nakato, Y. Iwata, K. Kuroda, C. Kato, J. Inclusion Phenom. Mol. Recognit. Chem. 1992, 13, 249-256.
- [2.18] Q. Feng, M. Hirasawa, K. Kajiyoshi, K. Yanagisawa, J. Mater. Sci. 2007, 42, 640-645.
- [2.19] Q. Feng, M. Hirasawa, K. Kajiyoshi, K. Yanagisawa, J. Am. Ceram. Soc. 2005, 88, 1415-1420.
- [2.20] Q. Feng, M. Hirasawa, K. Kajiyoshi, K. Yanagisawa, J. Ceram. Soc. JPN. 2007, 115, 165-168.
- [2.21] Q. Feng, M. Hirasawa, K. Yanagisawa, Chem. Mater. 2001, 13, 290-296.

第3章

溶解度制御による層状チタン酸の形態コントロール

第3章 溶解度制御による層状チタン酸の形態コントロール

3.1 はじめに

第2章で論じたように、寒天ゲルマトリクスを反応場として用いることで、ボトムアッ プアプローチにより新規チタン酸ナノシートの合成が可能になった。このナノシートは、 TiO₆ 八面体構造を有するチタン酸単層シートが、カウンターカチオンとしてのアンモニウ ムイオンと静電的に相互作用しながら組みあがることで、5-10 nm の薄さで安定化してい た。一般的に、チタン酸ナノシートは、ナノチューブ^[3.1,2]やナノワーヤー^[3.3]、ナノベルト^[3.4,5] などの中間体として得られ、準安定状態にあると言われている^[3.6,7]。これらの構造体は、水 熱処理により合成でき、合成条件により形態コントロールが可能であるが、複雑な溶解再 析出機構を含むため、形態形成メカニズムの解明には至っていない。一方で、アナターゼ 型二酸化チタンは、水溶液からの結晶成長法にて酸性条件下での合成が確認されており、 水溶液の pH を制御することで、アナターゼ型とルチル型とを選択的に作製することが可能 である^[3.8,9]。また、前章で述べたように、層状チタン酸とアナターゼ型二酸化チタンの結晶 構造は、TiO₆八面体の連結により構成されている点で類似している^[3.10,11]。そこで、層状チ タン酸の合成条件範囲を、水溶液からの結晶成長法における二酸化チタンの合成制御のよ うに、反応系内の pH や濃度により制御することが可能であるか検証することを第3章の目 的とした。実験の結果、分子やイオンを前駆体としたボトムアップアプローチでの層状チ タン酸の合成を試みる中で、溶液の pH とカウンターカチオンの種類によって、層状チタン 酸の結晶構造や形態に影響を与えることを見出した。つまり、カチオン種の濃度によって 層状チタン酸とアナターゼ型二酸化チタンとの選択的合成が可能となったこと、カチオン 種の種類により層状チタン酸の形態が決定されることが確認された。本章では、これらの 選択的合成について詳細を述べる。

3.2 実験方法

3.2.1 原料

Table 3-1.に本実験で用いた試薬を示す。

Material	Chemical formula	Purity	Manufacturer
Titanium(IV) fluoride	TiF ₄		Sigma-Aldrich corp.
Ammonia solution	NH₄OH	28 %	Junsei Chemical Co., Ltd.
Sodium Hydroxide	NaOH	96.0 %	Junsei Chemical Co., Ltd.
Hexamethylenetetramine	$C_6H_{12}N_4$	99.0 %	Kanto Chemical
Urea	NH ₂ CONH ₂		Junsei Chemical Co., Ltd.
Agar powder			Junsei Chemical Co., Ltd.

Table 3-1. List of reagents used in this chapter.

3.2.2 実験手順

ポリプロピレン製 50 cm³ 容器に純水 10 cm³、フッ化チタン 0.4 - 2.0 g (0.3 - 1.6 mol/dm³) を加えて 2 時間攪拌した。別容器に作製したゾル状寒天水溶液(寒天粉末 3.0 g/ 純水 100 cm³) 10 g にフッ化チタン水溶液を加え、1 分間攪拌し、4 ℃ で一晩静置した。得られたチ タン酸前駆体含有ゲルを、pH 調整した各種アルカリ水溶液 450 cm³(ポリスチレン製 600 cm³ 容器)に浸漬し、25 ℃ で 1 週間静置した。ゲル内に得られた生成物を取り出すため、温水 中で寒天を再溶解させた。その後、ろ過し、60 ℃ で乾燥させることで生成物を得た。

3.2.3 評価

得られた粒子の評価を以下に示す方法により行った。

1) X 線回折

得られた粉末試料の生成相および結晶性の評価は、粉末 X 線回折装置 RAD-C(RAD-C, CN-2013, 株式会社リガク)により行った。測定条件は、線源 CuKα、電圧 50 kV、電流 150 mA、 発散スリット・散乱スリット 1/6 deg.、測定 2θ 範囲 5 – 70°とした。

2) 形態観察

粒子の形態観察は、走査型電子顕微鏡(FE-SEM,日立 S-4700, FEI-SIRION, FEI)と透過型電
子顕微鏡(FE-TEM, TECNAI F20, FEI)を用いて評価した。SEM 観察を行う前処理として、真 空蒸着器(E-1010, 日立製作所)による Au-Pt 合金のイオンスパッタリング、あるいは、オス ミウムプラズマコーティング装置(HPC-1S, 真空デバイス)によるオスミウムコートを行っ た。また、TEM 観察を行う際には、乾燥させた試料をメノウ乳鉢で粉砕し、純水に少量加 えて充分に分散させ、これをコロジオン膜付銅メッシュに滴下し、常温で乾燥させること でサンプルとした。また、組成分析を、FESEM 付属のエネルギー分散型 X 線分光法(EDX) にて行った。

3) 細孔径分布·比表面積測定

脱気装置(VacPrep061, Micromeritics)により、試料を 160 °C で 2 時間脱気処理した後、窒素 吸着機(Tristar3000, Micromeritics)を用いて細孔径分布、比表面積を測定した。0.01 – 0.99 ま で相対圧を変化させることで吸着等温線を作成し、得られたデータをもとに BET 法を用いることで比表面積、BJH 法を用いることで細孔容積を求め、細孔径分布および積算細孔容 積曲線を作成した。

4) 赤外線透過率測定

粉末試料を KBr の粉末と混合、加圧してペレットを作製し、赤外分光光度計(FT-IR, FTS-60A/896, 日立製作所)を用いて、領域 400 – 4000 cm⁻¹の赤外線透過率を測定した。

3.3 実験結果と考察

3.3.1 アンモニアを用いた場合

アルカリとしてアンモニアを用いた場合、第2章で述べたように、寒天ゲル内にはチタン酸ナノシートが得られた。このナノシートは、5-10 nm の薄さで安定しており、ナノシートの集合体として 300-500 nm の球状粒子形態を取っていた(Figure 3-1)。ナノシートの層間には、アルカリとして用いたアンモニア由来の NH4⁺の存在が示唆された。詳細な構造解析結果については、「2.3.3 新規チタン酸ナノシートの構造解析」を参照のこと。



Figure 3-1. Flaky forms of titanate prepared in TiF₄ 0.5 mol/dm³ and NH₄OH 3.6 mol/dm³; (a, b) FESEM images, and (c) FETEM image.

3.3.2 水酸化ナトリウムを用いた場合

アルカリとして水酸化ナトリウムを用いた場合、生成物のミクロ形態はアンモニアの場合と大きく異なり、20 nm 程度の直径を有する針状の構造体が放射状に伸びることで 250 – 300 nm の球状粒子を構成していた(Figure 3-2)。



Figure 3-2. Rolled forms of titanate prepared in $TiF_4 0.7 \text{ mol/dm}^3$ and NaOH 5.8 mol/dm³; (a, b) FE-SEM images, and (c) FE-TEM image.

得られた針状粒子の XRD パターンを測定したところ、Figure 3-3 に示すように、アルカ リとしてアンモニア水を用いた場合とほぼ同様に、レピドクロサイト型の層状チタン酸で あると同定された。しかしながら、チタン酸の層間を示す 20=10°付近の回折ピーク位置に 差異が見られた。つまり、アンモニアで得られたナノシートでは層間隔は 1.0 nm 程度だっ たのに対し、水酸化ナトリウムで得られた針状粒子では 0.9 nm 程度であり、層間隔が広か った。その理由として、層間に存在するカウンターカチオンの種類によるものと考えられ る。上述したように、アンモニアを用いた場合、ナノシート層間にはアンモニウムイオン の存在が示唆された。一方で、水酸化ナトリウムを用いた場合には、EDX 測定結果から、 ナトリウムを多量に含有することが確認された。測定に使用した試料は、寒天ゲル内から 取り出された後、純水にて充分に洗浄し、表面に物理付着したアルカリ成分やゲル成分は 除去している。そのため、EDX で検出されたナトリウムは、表面に付着したものであると は考えにくく、アニオニックな単層チタン酸のカウンターカチオンとして層間に存在する ものと予想される。



Figure 3-3. XRD patterns of (a)flaky forms of titanate (prepared on condition of $TiF_4 0.5 \text{ mol/dm}^3$ and $NH_4OH 3.6 \text{ mol/dm}^3$) and (b) rolled forms of titanate (prepared on condition of $TiF_4 0.5 \text{ mol/dm}^3$ and $NaOH 5.8 \text{ mol/dm}^3$).

以上の結果より、生成物の形態は、チタン酸層間に存在するカチオンの種類により決定 され、層間にアンモニウムイオンが存在する場合はナノシート形態を、ナトリウムイオン が存在する場合は針状形態を取ることがわかった。一般的に、チタン酸ナノチューブは、 高濃度の水酸化ナトリウム水溶液を用いた高アルカリ条件下にて水熱処理を行うことで合 成されている。ナノチューブ形態は、チタン酸表面層の水素が一部脱離することで表面圧 力が変化してナノシート状に剥がれたのち、チューブ状に丸まることで得られる^[3,6]。その 際、ナトリウムイオンが層間に存在することで、チューブ形態の安定性が増すと考えられ ている^[3-7]。我々の実験結果もこの考察をサポートしており、ナトリウムイオンの共存によ り、チタン酸ナノシートのスクロールが促進されるものと予想される。ゲル内に得られた 針状粒子は、250-300 nmの球状粒子の中心部からの成長により形成されており、球状粒子 の根元付近はシート状だった。したがって、ナノシートが放射状に成長しながら丸まるこ とで、Figure 3-3 のような構造体が得られたものと考えられる。また、球状粒子の大きさは、 アンモニアを用いた場合と同様に、寒天ゲルマトリクスの網目構造の大きさに大よそ一致 するため、250-300 nm のサイズに留まったと考えられる。比較実験として、反応場として 使用している寒天ゲルをゾル状に変更し合成を試みた。ゾル状の寒天にフッ化チタン水溶 液を加え、これを水酸化ナトリウム水溶液中に入れて室温で静置したところ、水酸化ナト リウム水溶液内に、白色の沈殿物が形成された。ミクロ形態を観察すると、ゲル状の寒天 を用いた場合と同様に、250 – 300 nm の球状粒子から構成されており、球状粒子は針状形態 の集合体だった(Figure 3-4(a))。一方で、XRD 測定により、生成物はチタン酸であることが 確認された。一方で、寒天を用いずに、フッ化チタン水溶液をそのまま水酸化ナトリウム 水溶液中に加えたところ、Figure 3-4(b)に示すように、針状粒子は形成されたものの、250-300 nm の球状形態は観察されず、針状粒子がバラバラに解れた状態で得られた。さらに、 XRD 測定より、寒天を用いない場合には生成物は結晶化しておらず、水酸化物が形成され たものと考えられる。以上のように、寒天は、その網目構造に起因した球状形態を得るた めに、また、チタン酸結晶を得るために必要不可欠であることがわかった。一般的に、ナ ノチューブ状のチタン酸を形成するためには、二酸化チタンを高濃度の水酸化ナトリウム 水溶液中で水熱処理する必要があり、分子レベルの原料を使用して室温付近でチタン酸結 晶を得ることは難しいと予想される。本研究において寒天ゲル内にフッ化チタンを含有さ せることで室温にてチタン酸ナノシートが形成された理由として、寒天ゲルを反応場とし て用いることにより、溶液では困難であったチタン酸形成のための準安定状態を保持する ことが可能になったためと考えられる。



Figure 3-4. FESEM images of rod forms titanate prepared in; (a) agar sol and (b) no agar.

次に、層状チタン酸ナノシートが得られる条件について考える。上述したように、アル カリの種類は、ナノシート形態を保持するか、ナノチューブ状に丸まるかに多大な影響を 与えることがわかった。さらに、本研究により、アルカリ濃度・カチオン濃度の影響を受け、 生成物が変わることを見出した。第2章では、アンモニア水溶液を用いた場合の層状チタ ン酸の合成について議論したが、その際はアルカリの濃度表記として、フッ化チタン含有 寒天ゲルを浸漬する前の pH を用いていた。アンモニアでは、pH11.0 以上の高濃度の水溶液 を用いることで、ゲル内に白色物質が得られた。それに対し、水酸化ナトリウム水溶液を アルカリとして用いた場合、pH11.0 に調製した水溶液ではゲル内に析出物は得られなかっ た。その原因として、各アルカリの電離度が異なるためと考えられる。アンモニアの電離 度は 0.0017 であるのに対し、水酸化ナトリウムは 0.84 と高い値を示す。アンモニアを用い てpH12.0に調整した場合と水酸化ナトリウムを用いてpH12.0に調整した場合とを比較する と、pHが同じでも水溶液内全体に存在するOH(電離しているOH+電離していないOH) の量は、明らかにアンモニアの方が多い。ここで、フッ化チタンを含有する寒天ゲルは強 酸性を帯びており、これを各アルカリ水溶液内に浸漬するとアルカリは完全に電離するも のと考えられる。したがって、ゲルを浸漬する前の pH による調整のみでは、各アルカリ溶 液間での比較が困難である。そこで、本研究では、フッ化チタン含有寒天ゲルに浸漬して1 週間経過した反応後のアルカリの pH を測定することで、完全に電離された OH の濃度測定 が可能であると考え、各アルカリで比較検討した。その結果、最終的なアルカリの pH が 8 以上の場合、白色の析出物が寒天ゲル内に得られることが確認された。このときの析出物 は、XRD 測定結果よりチタン酸であると同定された。しかしながら、生成物は、最終的な pHのみに依存するのではなく、カウンターカチオンの濃度も重要だった。層状チタン酸は、 アニオニックな TiO₆ 八面体とカウンターカチオンのスタッキングにより形成されている。 理論的には、層状構造内のチタンに対するカチオンのモル比として、ほぼ同量がチタン酸 の構成に必要である。一方、各濃度のアルカリ水溶液を用いて実験を行った結果、0.5 mol/dm³ 程度のチタン濃度に対し、3.6 mol/dm³以上の多量のカチオンを含んだアルカリ水溶液が必 要であることがわかった。このように、多量のアンモニウムイオンやナトリウムイオンを

系内に導入しておくことにより、寒天ゲルマトリクス中に充分な量のカチオン種が入るの を促進しているのではないかと考えられる。以上の結果より、寒天ゲル内に層状チタン酸 を形成するためには、アルカリの pH とカチオン濃度を一定以上に調製する必要があること が確認された。比較実験として、アルカリとしてアンモニアを用い、塩化アンモニウムを 加えることで 3.6 mol/dm³以上のアンモニウムイオン濃度にした場合、アナターゼ型二酸化 チタンが形成された。このとき、系内の液性は酸性だった。つまり、カウンターカチオン が多量に存在することだけが必要なのではなく、カチオン濃度とアルカリの pH が同時に一 定量を超えることで初めて層状チタン酸が得られるものと予想される。

3.3.3 ヘキサメチレンテトラミンを用いた場合

ヘキサメチレンテトラミン(C₆H₁₂N₄)は、酸性条件下においてホルムアルデヒドとアンモ ニアに分解し、水1リットルに 50g 溶けて pH 7.8-8.8のアルカリ性を示す。これまでのア ンモニアや水酸化ナトリウムをアルカリとして使用した場合の実験結果と照らし合わせる と、pH の値がチタン酸形成には不十分であると考えられる。ヘキサメチレンテトラミンを アルカリ溶液として使用した場合、フッ化チタン含有寒天ゲルを、ヘキサメチレンテトラ ミン水溶液 (2.6 mol / H₂O 450 dm³) に浸漬して 1 週間静置した。反応後のアルカリ溶液の pH は 7.0 程度であり、pH の上昇は、チタン酸が形成される pH 9 には及ばなかった。しか しながら、ゲル内には白色物質が得られた。XRD により生成物を同定したところ、生成物 は主にアナターゼ型二酸化チタンだった(Figure 3-5)。また、ミクロ形態は、30-50 nm の粒 子状だった(Figure 3-6)。

以上の結果より、ヘキサメチレンテトラミンをアルカリ性試薬として使用すると、アン モニアは発生するものの、最終的な pH がチタン酸形成に充分でなく、アナターゼ型二酸化 チタンの形成に留まった。アンモニアや水酸化ナトリウムの使用で予想された「反応後の pH9以上がチタン酸形成に必須」という条件が、ヘキサメチレンテトラミンの使用により サポートされた。



Figure 3-5. XRD patterns of titania nanoparticles prepared in hexamethylenetetramine.



Figure 3-6. FESEM image of titania nanoparticles prepared in hexamethylenetetramine.

3.3.4 尿素を用いた場合

尿素(NH₂CONH₂)は、加熱することによって以下のような反応を起こしてアンモニアを形成する。

$3NH_2CONH_2 \rightarrow (NCOH)_3 + 3NH_3$

TiF₄を含有したゲル状の寒天を、2.5 mol/dm³の尿素水溶液 450 cm³ に入れて 60 °C の恒温 槽で静置することで NH₃を発生させ、ゲル内の pH を上昇させた。得られた析出物は、ヘキ サメチレンテトラミンと同様にアナターゼ型二酸化チタンだった(Figure 3-7)。温度上昇によ りアンモニアは発生するものの、pH の上昇が充分でないためにチタン酸の析出に至らなか ったものと考えられる。また、生成物は、 $0.5 - 1.0 \mu m$ 程度の球状形態だった(Figure 3-8(a))。 さらに、球状粒子の中には直径約 10 nm の針状粒子が集まることで直径 50 – 80 nm の針状 形態を取り、これがひとつの単位として観察された(Figure 3-8(b, c))。XRD パターンの回折 ピークの半値幅を用いてシェラーの式から結晶サイズを導き出したところ、[001]方向には 32 nm であるのに対し、[200]方向には 10 nm であり、c 軸方向に成長していることが確認さ れた。



Figure 3-7. XRD patterns of anatase-type titanaia prepared on condition of $TiF_4 0.5 \text{ mol/dm}^3$ and urea 5.8 mol/dm³.



Figure 3-8. Nanospines of anatase-type titania prepared in TiF₄ 0.5 mol/dm³ and urea 5.8 mol/dm³; (a, b) FE-SEM images, and (c) FE-TEM image.

3.3.5 まとめ

4種類のアルカリ水溶液をゲル上部から拡散させてチタン酸の合成を試みた結果、アルカ リのpHとカウンターカチオンの濃度がチタン酸形成に重要であることがわかった。つまり、 反応後のアルカリ水溶液のpHは9以上が必要であり、かつ、3.6 mol/dm³以上のカウンタ ーカチオン濃度が必要だった。ただし、ヘキサメチレンテトラミンや尿素をアルカリとし て用いた場合、脱離前の水酸化物イオン濃度としてはアンモニアや水酸化ナトリウムと同 量であっても、反応過程の中で徐々にアルカリが形成され、チタン酸形成には至らなかっ た。また、フッ化チタンとアンモニアや水酸化ナトリウムを直接混ぜた場合も、アモルフ ァス状の物質が形成され、チタン酸は得られなかった。これらのことから、層状チタン酸 は、室温で1週間掛けてエージングすることで、ゲル内に適度な量のアルカリが浸漬して 反応が進み、チタン酸結晶が析出するものと考えられる。さらに、層状チタン酸の形態は、 カウンターカチオンの種類により決定されることがわかった。アンモニアを用いた場合に はシート状、水酸化ナトリウムを用いた場合にはチューブ状の形態を取った。解析の結果、 チタン酸の層間には、各アルカリに由来するカチオンがカウンターイオンとして存在する ことが確認され、カチオン種により、チタン酸シートの安定性が変化し、それぞれの形態 に落ち着いたものと考えられる。以上の結果を模式図として Figure 3-9 に示す。



Figure 3-9. Schematic representation of the relationship between the products and the final pH (pHf) or the concentration of alkaline agent.

3.4 結論

寒天ゲルを反応場としたチタン酸合成において、チタン前駆体含有寒天ゲル内に拡散さ せるアルカリ水溶液の種類を変えることにより、得られる結晶の種類・形態に大きな差異が 見られることが確認された。チタン酸を得るためには、反応後のpHが9以上のアルカリ水 溶液を、さらに、チタン酸層間にカウンターイオンとして組み込まれるカチオンを多量に 共存させる必要があった。

チタン酸が形成される条件においては、カウンターカチオンの種類により、層状チタン 酸の形態が異なった。アンモニア水溶液を用いた場合、チタン酸層間にはアンモニウムイ オンが存在し、5-10 nm のナノシート形態を取ることが確認された。また、水酸化ナトリ ウムを用いた場合、チタン酸層間にはナトリウムイオンが存在し、直径 20 nm 程度の針状 形態を取った。層間に存在するカウンターカチオンの種類により、シート状で安定するも の・丸まって針状になり安定化するものに分かれたものと考えられる。

チタン前駆体含有寒天ゲル内の pH の上昇が充分でない場合、ゲル内にはアナターゼ型二酸化チタンが形成された。しかし、寒天ゲルという、拡散の制限された反応場での生成により、特定の結晶面の成長が促され針状形態を有するなど、特異的な構造体が形成された。

参考文献

- [3.1] T. Kasuga, M. Hiramatsu, A. Hoson, T. Sekino, K. Niihara, Langmuir 1998, 14, 3160-3163.
- [3.2] T. Kasuga, M. Hiramatsu, A. Hoson, T. Sekino, K. Niihara, Adv. Mater. 1999, 11, 1307-1311.
- [3.3] Z. Y. Yuan, B. L. Su, Colloids Surf. A 2004, 241, 173-183.
- [3.4] R. Ma, K. Fukuda, T. Sasaki, M. Osada, Y. Bando, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 6210-6214.
- [3.5] R. Yoshida, Y. Suzuki, S. Yoshikawa, J. Solid State Chem. 2005, 178, 2179-2185.
- [3.6] S. Zhang, L. M. Peng, Q. Chen, G. H. Du, G. Dawson, W. Z. Zhou, *Phys. Rev. Lett.* 2003, *91*, 256103.
- [3.7] S. Zhang, Q. Chen, L. M. Peng, Phys. Rev. B 2005, 71, 014104.
- [3.8] S. Yamabi, H. Imai, Chem. Mater. 2002, 14, 609-614.
- [3.9] K. Shimizu, H. Imai, H. Hirashima, K. Tsukuma, Thin Solid Films 1999, 351, 220-224.
- [3.10] H. Zhu, X. Gao, Y. Lan, D. Song, Y. Xi, J. Zhao, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8380-8381.
- [3.11] Y. Mao, S. S. Wong, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 8217-8226.

第4章

ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成

第4章 ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の

合成

4.1 はじめに

第1章「1.5.3 ナノ粒子堆積法を用いた誘電体薄膜の形成」で述べたように、ゾルゲル 法にて合成した高結晶・高分散のチタン酸バリウムナノクリスタルを用いることにより、電 極基板上に高密度でこれを堆積させ、熱処理により基板界面からの粒成長を促すことで、 高い結晶性と緻密性を有する誘電体薄膜を作製できることが確認されている。ナノ粒子堆 積法による薄膜形成において重要なポイントは、高結晶性・高分散性のナノクリスタルスラ リーを使用することにあり、本研究では、ナノクリスタル合成法としてゾルゲル法を用い ている。一般的に、ゾルゲル法は、原料となる金属アルコキシドを加水分解・縮重合させた のちに熱処理を行うことで、目的の酸化物を得る方法である。桑原らは、従来のゾルゲル 法を改良し、高濃度ゾルゲル法という独自の手法を用いることで、数十 nm のチタン酸バリ ウムナノクリスタルが粒径制御性良く合成できることを見出した^[4.1]。本研究でチタン酸バ リウム誘電体薄膜形成に用いているナノクリスタルは、Kuwabara らの高濃度ゾルゲル法を 基本に合成されている。ただし、いずれにしても、ゾルゲル法の原料は金属アルコキシド であり、実用化を考えた際には原料費の高さが問題となる。そこで、ゾルゲル法に代わる 合成法の確立が求められるが、高結晶・高分散・小粒径ナノ粒子の合成法としてゾルゲル法 に勝る方法はなかなか見つからない。そこで、本章では、将来的に高濃度ゾルゲル法に代 わる安価なチタン酸バリウムナノクリスタルの合成法を見出すため、高濃度ゾルゲル法に おけるチタン酸バリウムナノクリスタル合成についてこれまでの研究をまとめ、また、そ こから考えられる合成メカニズムの妥当性を検証した。

4.1.1 高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ粒子の合成

ー般的なゾルゲル法では、下記の式に示すような金属アルコキシドの加水分解と縮重合 を経てメタロキサン結合が得られ、アモルファス状のゲル体が形成される。これを熱処理 することで目的の金属酸化物を得る。

<加水分解>

$$\begin{split} M(OR)_4 + H_2O &\rightarrow M(OR)_3(OH) + ROH \\ M(OR)_3(OH) + H_2O &\rightarrow M(OR)_2(OH)_2 + ROH \end{split}$$

<縮重合>

$$\begin{split} \mathsf{M}(\mathsf{OR})_3(\mathsf{OH}) + \mathsf{HO-M}(\mathsf{OR})_3 &\to (\mathsf{OR})_3\mathsf{M-O-M}(\mathsf{OR})_3 + \mathsf{H}_2\mathsf{O} \\ \mathsf{M}(\mathsf{OR})_3(\mathsf{OH}) + \mathsf{RO-M}(\mathsf{OR})_3 &\to (\mathsf{OR})_3\mathsf{M-O-M}(\mathsf{OR})_3 + \mathsf{ROH} \end{split}$$

Kuwabara らは、上述した一般的なゾルゲル法において、前駆体溶液の高濃度化とゲル形 成後のエージング時間の確保により、ゲル乾燥・熱処理の工程を経ずに結晶性の小粒径チタ ン酸バリウムナノ粒子を合成することに成功した^[4.1]。この高濃度ゾルゲル法によるチタン 酸バリウムナノ粒子の形成について、Kuwabara らが考察したメカニズムをまとめる。

まず、Kuwabara らは、Ba 源としてバリウムエトキシドを、Ti 源としてテトライソプロポ キシチタンを用い、これらをメタノール/2-メトキシエタノール混合溶媒に溶解し、前駆体 溶液を 0 ℃に保持した状態で加水分解を行った。 加水分解により前駆体溶液はゲル化した。 このゲルを 30 ℃でエージングして生成物を得た。この実験工程中の各ポイントで生成物を 取り出して、結晶性を調べたところ、加水分解直後・ゲル化直後の生成物は結晶化していな いことを確認した。得られたゲルをエージングすることで、離液収縮が起こり、有機成分 が除去され、初めて結晶性チタン酸バリウムが得られることが明らかになった^[4.2]。エージ ング過程中で起こる離液収縮は、ゲル骨格とゲル細孔内液体間の表面エネルギーを最小に するために起こるゲル骨格の自発的な液体排出である。排出の程度は、ゲル細孔内外での 圧力差により決まる。しかしながら、細孔が小さいと、固体・液体間で発生する摩擦が大き いため、摩擦力に打ち勝って液体を排出するためにはかなりの圧力勾配が必要となる。同 様に、希薄な前駆体溶液を加水分解して得られた低密度なゲルでは、多量の液体をゲル内 部に含有するため、液体の排出には高い圧力を必要とする。このため、希薄な前駆体溶液 を用いた場合には、エージング過程中での離液収縮を得ることが難しく、結果的にアモル ファス状の生成物が得られるに留まる。一方で、高濃度な前駆体溶液を用いることで、液 体の排出力が高く離液収縮が起こりやすいため、有機成分が除去されやすく、結晶化が容 易であると考えられている。Kuwabara らの実験では、チタン酸バリウムの合成には 1×10³ mol/m³ 程度の高濃度アルコキシドを用いたため、エージングによるチタン酸バリウムの結 晶化が可能になった。以上のメカニズムにより、前駆体溶液の高濃度化が、加水分解後の エージング過程における結晶化のしやすさに起因するものと考えられる。

4.1.2 高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノクリスタル形成メカニズ ムの解明

次に、Shimooka らは、X 線吸収微細構造(XAFS)解析によりゲルの結晶化が進むエージン グ過程における局所構造を調べ、チタン酸バリウム結晶の生成機構を検討した^[4.3,4]。上述し た Kuwabara らの実験方法により、バリウムエトキシドとテトライソプロポキシチタンの混 合前駆体溶液を加水分解し、30 ℃でのエージング時間を0h,1h,8h,120hと変化させて、 ゲルの結晶状態を調べた^[43,4]。まず、ゲル密度の上昇に伴う化学量論性と結晶化度の変化を 調べたところ、チタンは離液収縮で排出された溶液中にほとんど存在せず、チタンが非晶 質ゲルの骨格を形成する基本的構成元素であること、一方、バリウムは排出溶液中に若干 溶解することが示された。また、エージング時間 lh の非晶質湿潤ゲルを母溶媒で洗浄した ときの、洗浄回数に対するゲルの化学量論の値の変化を調べた結果、洗浄によりゲル中の バリウムは溶出するが、洗浄回数を重ねてもゲル中に残存するバリウムが多く、バリウム の大部分がかなり強くゲル骨格に結合または吸着していることが推測された。以上の実験 結果より、ゲル化直後の非晶質ゲルは、チタンを基本的構成元素として 3 次元骨格を形成 し、これに多くのバリウムが結合した構造を取っていることが示唆された。

次に、上記の実験結果を基に、非晶質ゲルにおけるバリウム、チタン周辺の局所構造を 調べるために XAFS 解析を行った。XAFS は、X 線照射により内殻電子の励起に起因して得 られる吸収スペクトルであり、着目元素ごとの情報を得ることが出来る。また、エネルギ 一範囲および励起過程の違いにより、XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) および EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure)に分けられる。XANES は、非占有軌道への 励起に起因し、着目元素の価数や配位構造などに依存したスペクトル構造であるのに対し、 EXAFS は、励起電子と近傍原子からの散乱電子の相互作用に起因して得られる振動構造で あり、フーリエ変換により得られる動径分布関数は、着目元素の局所構造(周囲の原子種、 配位原子の数、原子間距離)に関する情報を含んでいる。Shimooka らは、Technos 社の EXAC 800 を用いることにより測定を行った。

まず、チタン周辺の局所構造を調べるため、Ti K 端の XANES スペクトルを取得した。一 般的に、4970 eV 付近に現れるピークは、チタン周辺の酸素配位状態について示しており、 TiO₄やTiO₅では強い吸収が1本現れ、TiO₆人面体では弱い3本のピークが現れると言われ ている^[4.5-8]。得られたスペクトルより、エージング時間の増加とともに、このピークは減少 し、吸収端の形も BaTiO3のスペクトルに近づくことが確認された。ゲル化直後の非晶質ゲ ルで見られたピークも、Ba2TiO4などのTiO4四面体のみが存在する場合と比べるとはるかに 小さかった。これらのことから、得られたゲルのチタンは、大部分が周囲に酸素を 6 配位 させた構造を形成しており、一部に TiO4や TiO5、あるいは歪んだ TiO6 八面体を形成してい るものと考えられた。次に、バリウム周辺の局所構造を、EXAFS 解析により行った。エー ジング時間による乾燥ゲルの Ba L_m端(5.246 eV)の k²χ(k)の変化を調べたところ、エージング 時間が短いほど振幅が小さく、高波数になるにつれて急激に減衰することが確認された。 このことは、ゲル化直後の非晶質ゲルではデバイ-ワラー因子が大きく、バリウム原子配置 の乱れが大きいことを示している。デバイ-ワラー因子とは、EXAFS で吸収原子からある原 子までの距離を観測したときに、その原子がどれほど揺らいでいるかを表す物理量であり、 デバイ-ワラー因子が小さいほどその原子間距離にバラつきが無く、逆に大きければ実際の 原子間距離に様々な値が存在し、その平均値を観測していることになる。以上の結果より、 エージング時間の増加とともに、縮合反応が進行して TiO₆ 八面体の連結が進み、バリウム

原子のゲル骨格への固定が強固になり、バリウムへの TiO₆ 八面体の配位数が増加するもの と考えられる。また、このとき、バリウムと酸素との結合はイオン結合性が強いものと考 えられる。

以上、XAFS を用いたチタン、バリウム周辺の局所構造の解析により、エージング中に起こる結晶化について次のようなモデルが推測された。つまり、ゲル化直後の非晶質ゲル骨格は Ba-TiO₆ 八面体クラスターで構成されており、エージング時間の増加とともに縮合反応によりこれらが連結してバリウム周囲の酸素配位数が増加し、チタン酸バリウムナノ結晶が形成されるものと考えられる。

4.1.3 高濃度ゾルゲル法で得られるチタン酸バリウムナノ粒子の特長

上述したように、高濃度ゾルゲル法は、通常では結晶化に熱処理を必要とする一般的な ゾルゲル法とは結晶化メカニズムが異なり、低温でのエージングにより Ba-TiO6 八面体の連 結により結晶化が進むと考えられている。このメカニズムにより、20 nm 程度の小粒径のチ タン酸バリウムが、高い分散性を持って形成されることが Kuwabara らにより見出された。 一般的に、粒子表面には拡散電気二重層による静電反発力と、ファンデルワールス力によ る引力が働き、DLVO(Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek)理論に従いポテンシャルエネルギ ー曲線を描くことができ分散・凝集機構が決まる。この曲線におけるポテンシャル障壁のピ ーク値が大きいほど分散安定化に向かうが、微粒子になるほど、ポテンシャル障壁が小さ くなり、凝集しやすくなる。このため、高濃度ゾルゲル法により得られるナノメートルス ケールの粒子が高い分散性を有する状態で得られることは極めて特異的である。この分散 性の高さは、合成に際して溶媒として用いる 2-メトキシエタノールが影響するためと考え られる。バリウム・チタンアルコキシドを、メタノール・2-メトキシエタノール混合溶媒に加 えて反応を進めるが、その際、バリウム・チタンはそれぞれ 2-メトキシエタノールのメトキ シ基とキレートを形成することが確認されている^[4.5]。Figure 4-1 に示すようなヘテロ二金属 アルコキシドを形成し、安定化している。このヘテロ二金属アルコキシドの形成により、 高濃度の Ba、Ti アルコキシド溶液中では溶質に束縛されない第二配位圏の分子が少なく、 溶質間の平均距離が非常に近くなるため、希薄溶液では無視しうる溶質-溶質間の相互作用 による溶質の配列などの効果が期待できると考えられている[46]。また、エージングによる 結晶化後のチタン酸バリウムナノ結晶にも同様に配位し、各結晶粒子間の凝集が抑制され ているものと考えられる。



Figure 4-1. Structural model of a precursor in a high-concentraion of Ba and Ti alkoxide solution.

また、高い分散性を有するという特長のほかにも、小粒径であるにもかかわらず高い結 晶性の粒子が得られるという点も確認されている。一般的なゾルゲル法では、原料中に含 まれる未反応 OH 基の残留により、400-500 ℃の熱処理でボイドが形成される。また、原料 中に含まれる未反応 OR 基の残留により、オキシ炭酸塩が生成してコアシェル構造を形成す る。これらが原因となって結晶性は低い。しかし、前駆体濃度を高濃度にすることにより、 OH 基や OR 基が生成しにくくなり、不純物の混入を防ぐことができるため、高結晶性の粒 子の生成が可能となることが Kuwabara らにより確認されている。

以上の理由から、高濃度ゾルゲル法を用いることにより、数十 nm 程度の小粒径ナノ粒子 を高分散・高結晶な状態で得ることが可能である。

4.1.4 安価な合成法の可能性

高濃度ゾルゲル法を用いることにより、高結晶・高分散のナノ粒子が粒径制御性良く生成 することが、Kuwabara・Shimooka らの研究により示された^[4,1-4]。また、この方法により得ら れたナノ粒子を用いることで、良好な特性を有する誘電体薄膜を形成することも確認でき ている。しかしながら、ゾルゲル法の原料として用いる金属アルコキシドは一般的に高価 であり、誘電体薄膜用原料として量産には向かない。そこで、Kuwabara・Shimooka らが見出 した高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ粒子の形成メカニズムをヒントにし、 得られるチタン酸バリウムナノ粒子の特長をそのままで原料を安価なものに変更すること は可能か否かを実験により考察した。具体的には、原料の添加タイミング、溶媒種、チタ ン源、バリウム源の変更による生成物への影響を調査することで、チタン酸バリウムの形 成メカニズムの理解を行うとともに、安価な原料への変更を検討した。これらの実験を通 し、高濃度ゾルゲル法で得られる高結晶性のチタン酸バリウムナノ粒子を、安価な原料か つ容易な手法により合成できることが期待される。

4.2 実験方法

4.2.1 原料

Table 4-1 に本実験で用いた試薬を示す。

Material	Chemical formula	Purity	Manufacturer
Barium diethoxide	$Ba(OC_2H_5)_2$	> 99 %	Kojundo Chemical Lab.
Titanium tetra-iso-propoxide	Ti(O-i-C ₃ H ₇) ₄	99 %	Kojundo Chemical Lab.
Titanium dioxide	TiO ₂ (anatase)		Ishihara Sangyo
Barium acetate	Ba(CH ₃ COO) ₂	> 99.0 %	Kanto Chemical
Barium hydroxide octahydrate	Ba(OH)₂·8H₂O	> 98.0 %	Kanto Chemical
Ethanol (dehydrated)	C₂H₅OH	> 99.5 %	Kanto Chemical
2-Methoxyethanol	CH ₃ OCH ₂ CH ₂ OH	> 99 %	Kanto Chemical
2-Propanol	(CH ₃) ₂ CHOH	> 99.7 %	Kanto Chemical
Benzyl alcohol	C ₆ H₅CH₂OH	> 99.0 %	Kanto Chemical

Table 4-1. List of reagents used in this chapter.

4.2.2 実験手順

高濃度ゾルゲル法による基本的なチタン酸バリウムナノクリスタルの合成法を示す。バ リウムエトキシドとテトライソプロポキシチタンを等モル量で秤量し、エタノール 25 cm³ と 2-メトキシエタノール 6 cm³の混合溶液中に溶解させ、0.5 mol/dm³の濃度の前駆体溶液を 作製した。得られた前駆体溶液を室温下で 16 時間攪拌させることで各試薬を完全に溶解さ せた。ここまでの作業は、各アルコキシドの水分との反応を避けるため、N₂ 置換されたグ ローブボックス内にて行われた。得られた前駆体溶液に、-20 ℃に保持した状態でエタノー ルと水の混合溶液を滴下し、加水分解を行ったのち、50 ℃のオイルバス中でエージングを 1 日間行った。加水分解により、重合反応が進み前駆体溶液は完全にゲル化し、50 ℃での エージングにより、ゲル内から水分が吐き出されてゲルの収縮が起こり、結晶化が完了し た。

「4.3.3バリウム源の変更による生成物への影響」では、上述した上記方法で得られる10 nm程度のチタン酸バリウムナノクリスタルの合成法を基本としてバリウム源のみを変更し た。バリウム源として、酢酸バリウムと水酸化バリウム八水和物(関東化学製)を用いた。チ タン源にはテトライソプロポキシチタンを用いた。チタン源、バリウム源をBa/Ti=1の割合 で0.5 mol/dm³の濃度で用意した。このとき、バリウム源は溶解性を考慮して水溶液の状態で、 また、チタン源には各種有機溶剤を溶媒として用いた。Songhak Yoonらは、チタン源にテト ライソプロポキシチタンを、バリウム源に水酸化バリウム八水和物を、溶媒に2-プロパノー ルを用いて、80 ℃での合成を行うことで、シングルナノオーダーのチタン酸バリウムナノ 粒子が高結晶状態で得られることを見出している^[4,9]。バリウム・チタン原料は本検討と同様 であることから、ここでは溶媒の種類による影響も同時に調べるため、数種の組み合わせ で溶媒を変更した。また、チタンアルコキシドは、バリウム源に含まれる水により加水分 解が行われるものと考えられ、通常の高濃度ゾルゲル法の加水分解工程として加える水/エ タノール混合溶媒は省略した。チタン源とバリウム源を混合し、室温で6時間攪拌した。こ れを80℃でエージングすることで生成物を得た(Figure 4-1)。



Figure 4-1. Experimental scheme of BaTiO₃ synthesis procedure using several Ba precursor solution.

4.2.3 評価

得られた粒子、薄膜の評価を以下に示す方法により行った。

1) X 線回折

得られた粉末試料の生成相および結晶性の評価は、粉末 X 線回折装置(XRD, リガク RINT2500)により行った。測定条件は、線源 CuKα、電圧 50 kV、電流 100 mA、ステップ角 0.02°、測定 20 範囲 20 – 90°とした。

2) 形態観察

粒子および薄膜の形態観察は、走査型電子顕微鏡(FE-SEM, 日立 S-4500, ZEISS SUPRA35VP)と透過型電子顕微鏡(FE-TEM, 日本電子 3000F, 日本電子 2100F)を用いて評価 した。

3) 粒度分布測定

ナノクリスタルスラリーの粒度分布は、あらかじめ超音波で充分に分散させた後、ナノ トラック粒度分布測定装置(UPA,日機装 UPA-EX150)を用いることにより、動的光散乱法を 測定原理として測定した。

4.3 実験結果と考察

4.3.1 Ba 後添加による生成物への影響

上述したように、Kuwabara・Shimookaらの研究により、高濃度ゾルゲル法によるチタン酸 バリウム形成メカニズムとして、エージング過程中でのBa-TiO₆八面体の形成と、その連結 による結晶化が明らかとなった。彼らの実験結果からは、縮合反応によりTiO₆が強固に結合 しているのに対し、エージング初期段階ではバリウムは溶媒中に溶出しやすく、ゲル骨格 (TiO₆)とはイオン結合程度の弱い結合を形成していることが推測された。我々は、この結果 から、高濃度ゾルゲル法において、TiO₆八面体の縮合に伴う連結を先に行い、完全にゲル化 したのちにバリウム源をゲル内に拡散させることで、同様の構造体が形成されるのではな いかと考えた。そこで、第一の実験として、チタンアルコキシドの加水分解ののちに、バ リウムアルコキシドを添加し、生成物への影響を調べた。

実験方法としては、以下のとおりである(Figure 4-2)。通常の10 nmチタン酸バリウム合成 手順は、「4.2 実験方法」に示したとおり、あらかじめチタンアルコキシドとバリウムアル コキシドを同時に混合して前駆体溶液とし、-20 ℃での加水分解と50 ℃でのエージングを 経て10 nm程度のチタン酸バリウムナノクリスタルを合成する(Figure 4-2(a))。一方で、バリ ウム後添加での合成手順は、Figure 4-2(b)に示すように、チタンアルコキシドを加水分解さ せたのちに、バリウムアルコキシド溶液を滴下して加え、50 ℃でのエージングを行い、生 成物を得た。いずれの場合も、前駆体溶液の濃度は0.5 mol/dm³とし、バリウム源の添加タイ ミングを除いて、他の工程は基本的な合成法と同様に行った。



Figure 4-2. Experimental schemes; (a) basic 10 nm BaTiO₃ synthesis procedure and (b) case of adding Ba alkoxide after hydrolysis of Ti alkoxide.

通常の10 nmチタン酸バリウム合成時には、加水分解により重縮合反応が起こってゲル化 が進行し、エージング過程中に離液収縮によりチタン酸バリウムの収縮ゲルが得られる。 一方で、Figure 4-2(b)に示した方法で合成した場合、チタンアルコキシドの加水分解後はゲ ル化が起こらず白濁溶液が得られ、バリウム前駆体溶液を滴下した後も白濁状態は変わら ず、エージングののちに白濁物質が沈殿して生成物として得られた。通常の10 nmチタン酸 バリウム合成工程では、エージング時間の経過とともにチタン酸バリウムの結晶化が進む ことが確認されているが、バリウム源を後添加した場合は、バリウムがどのように作用し ているのか、各段階での生成物を取り出し、XRD測定を行った結果をFigure 4-3に示す。こ の結果より、バリウム源を後添加した場合も、エージング24時間後にはチタン酸バリウム が形成され、一方でエージング直後の白濁物質はアモルファスであることが確認された。 つまり、バリウム源の添加のタイミングによらず、バリウム添加後のエージング過程中に チタン酸バリウムの結晶化が起こることがわかった。また、各段階で得られた生成物の形 態はFigure 4-4に示すとおりであり、チタンアルコキシドの加水分解直後、バリウム前駆体 溶液添加直後はどちらも数μmの不定形物質が得られているのに対し、バリウム前駆体を添 加して50 ℃で24時間エージングしたのちには、比表面積81 m²/g、一次粒子径約10 nmの粒子 が形成されており、当初の予想通り、バリウム添加のタイミングによらず、チタン骨格が 先に形成され、骨格の中にバリウムがイオン的に導入されていくメカニズムが妥当である と考えられた。しかしながら、最終的に得られたチタン酸バリウム粒子のXRF測定結果より、 通常の高濃度ゾルゲル法ではほぼBa/Ti=1だったのに対し、バリウム後添加ではBa/Ti=0.93 と、バリウムが骨格内に完全に入った状態ではないことが確認された。



Figure 4-3. XRD patterns of products after adding Ba precursor.



Figure 4-4. TEM images of products at each process; (a) moments after hydrolysis of Ti alkoxide, (b) moments after adding Ba precursor, and (c) after aging for 24 h.

比較実験として、チタンアルコキシドの加水分解後に、バリウム前駆体溶液の添加をせ ずに50 ℃でのエージングを24時間行った際に得られる生成物の形態・結晶型を確認した。 その結果、Figure 4-5に示すように、チタンアルコキシドのみでは、エージング後でも加水 分解直後と同様に、数µmのアモルファス状の物質が得られるのみであり、バリウム添加時 のような10 nmの粒子は確認されなかった。以上の比較実験結果より、バリウム源を加える ことが駆動力となりチタン酸バリウムの結晶化が進むことは確かであり、粒子径もバリウ ムとの結合による結晶化の際に決まると考えられる。



Figure 4-5. (a) XRD pattern and (b) TEM image of product after hydrolysis and aging of Ti alkoxide only.

また、加水分解温度を-20 ℃,0 ℃,25 ℃と変化させた場合、生成物の粒子径が変化する との結果が出ている。加水分解温度-20 ℃では約10 nm、加水分解温度0 ℃では約8.5 nm、 加水分解温度25 ℃では約5 nmのチタン酸バリウム粒子が得られている。この差異の理由と して考えられることは、加水分解時のチタン骨格の形成度によると推測される。加水分解 を行った後の状態は、温度により異なる。つまり、-20 ℃での加水分解時には液体状態が保 持されているが、25 ℃での加水分解時には加水分解中からゲル化が始まっている。これは、 25 ℃ではチタン骨格がほぼ100%形成されており、その骨格内にはある単位でのクラスター が寄り集まっているのに対し、-20 ℃ではチタン骨格の形成が不十分であり、エージング時 にゲル化(クラスターの形成)と結晶化が同時に起こる。そのため、粒成長が進みやすく、約 10nmに成長した粒子が得られたのではないかと考えられる。

以上の結果も踏まえると、バリウムとの結合の際のチタン骨格の形成度と、バリウムの 拡散により、チタン酸バリウムの結晶化が進むものと考えられ、このメカニズムは、固相 法などで見られる二酸化チタンへのバリウムイオンのトポタキシャル的な拡散による結晶 化メカニズムと類似している^[4.10,11]。つまり、高濃度ゾルゲル法は、加水分解により得られ るチタン骨格の大きさや均一性が小粒径粒子を形成するために適しているのであって、同 じような状態を作り出すことが出来れば、他の原料で代用することは充分可能であると予 想される。

4.3.2 チタン源の変更による生成物への影響

上述したように、高濃度ゾルゲル法においても、チタン骨格形成ののちにバリウムイオンの拡散によりチタン酸バリウムが結晶化するというメカニズムが推測された。そこで、チタン源を、アルコキシドの加水分解による TiO₆ 八面体クラスターの形成により供給するのではなく、微粒子二酸化チタンを用いた場合に生成物にどのような影響が現れるのかを調べた。実験方法は以下のとおりである。

チタン源として、石原産業製の比表面積 350 m²/g、粒子径 5-7nm のアナターゼ型二酸化 チタン LU234 を用いた(Figure 4-6)。バリウム源にはバリウムエトキシドを用いた。チタン 源、バリウム源を Ba/Ti=1 の割合で 0.5 mol/dm³の濃度で用意し、エタノール/2-メトキシエ タノール混合溶媒に加え、室温で 16 時間攪拌した。これを-20 ℃で加水分解、50 ℃でエー ジングすることで生成物を得た(Figure 4-7)。



Figure 4-6. TEM image of anatase phase TiO₂ used as Ti precursor.



Figure 4-7. Experimental scheme of BaTiO₃ synthesis procedure using anatase TiO₂ as Ti precursor.

50 ℃でのエージング時間を1,4,7日間と変化させた場合の生成物の結晶形をXRDにより 測定した(Figure 4-8)。その結果、1,4日間のエージングではアモルファス状のハローの中に も立方晶チタン酸バリウムのパターンがブロードながら得られ、7日間のエージングを行う ことで、結晶化の進んだチタン酸バリウムが得られたことが確認された。ただし、炭酸バ リウムが二次相として形成されていた。各生成物の粒子状態をSEM観察により確認したと ころ、Figure 4-9に示すように、凝集状態はエージング1,4日間と7日間で異なっているもの の、凝集体の中の1次粒子は、いずれもナノ粒子から構成されていることがわかった。7日 間エージングを行うことで得られた粒子をTEM観察したところ、アルコキシドをチタン源 とした場合より分散性は低いものの、粒子径は10 nm程度で均一であり、高分解TEM像から は格子像も各粒子に観察されるなど結晶性の高いチタン酸バリウムが得られていることが 確認された(Figure 4-10)。



Figure 4-8. XRD patterns of Experimental schemes of BaTiO₃ synthesis procedure using anatase TiO₂ as Ti precursor.



Figure 4-9. SEM images of BaTiO₃ particles prepared by several aging times; (a) 1 day, (b) 4 days, and (c) 7 days.



Figure 4-10. (a) and (b) TEM images of BaTiO₃ particles prepared by 7 days aging, and (c) electron diffraction pattern of prepared particles.

以上の結果より、当初の予想通り、チタン骨格形成ののちにバリウムイオンの侵入によ りチタン酸バリウムが結晶化するというメカニズムの確からしさが示され、チタン源とし ては、アルコキシドの加水分解によるTiO₆八面体クラスターの形成による供給でなく、微粒 子二酸化チタンを用いた場合でも同様に、チタン源の大きさとほぼ同様の粒子径を有する チタン酸バリウムナノ粒子が形成されることが確認された。ただし、粉末のチタン源を使 用することで、原料の高分散性が確保されず、生成したチタン酸バリウム粒子の分散性も 低い状態で得られた。比較実験として、粒子径がほぼ同程度で、凝集状態が異なる二酸化 チタン粉末(石原産業製; LU234, LU211)をチタン原料として、Figure 4-7の工程と同様のスキ ームにて合成を試みた。分散性の高い二酸化チタン(LU211)を用いた場合には、10 nm程度の 1次粒子が単分散状態で得られている箇所が多数観察され、原料の分散状態が、生成する チタン酸バリウムの分散度に影響を与えることが確認された。

4.3.3 バリウム源の変更による生成物への影響

次の検討として、本研究では、バリウム源に着目した。ここまでの検討では、いずれも バリウム源としてバリウムエトキシドを用いている。Kuwabara・Shimookaらも同様にバリウ ムエトキシドをバリウム源として高濃度ゾルゲル法のメカニズム解明を試みており、XAFS 解析などから、バリウムはチタン骨格内にイオン的に導入され、結晶化すると推測した。 ここで、バリウム源として用いるアルコキシドは意味を持つのか、他のバリウム源を用い ることで同様の反応を試み、得られる生成物への影響を調べた。

まず、バリウム源として酢酸バリウムを用いた場合の結果を示す。このとき、チタンア ルコキシドの溶媒にはエタノール/2-メトキシエタノール混合溶媒を用いた。エージング後 の反応容器内には白色の沈殿が生成していた。結晶型の同定をXRD測定により行ったとこ ろ、チタン酸バリウムは検出されず、帰属の難しい複数のピークが見られた。この結果よ り、どんなバリウム源でもイオンとしてチタン骨格中に導入されるわけではないことが確 認され、チタン酸バリウムを合成するためには、ある一定の環境が必要であると推測され る。

次に、バリウム源として水酸化バリウム八水和物を用いた。上述したように、S. Yoonら は、KOHによりpH11~14に調製した水酸化バリウム八水和物溶液中に、テトライソプロポキ シチタンを滴下し、80 ℃で一時間反応させることで、約7.5nmの高い正方晶性を有するチ タン酸バリウムナノ粒子を合成することに成功している^[4,11]。このとき、溶媒には2-プロパ ノールを用いている。彼らの報告によると、必要以上の水を反応系に用いずに水酸化バリ ウム八水和物由来の水和水のみを用い、さらに、反応系のpHを制御することにより、チタ ン源のTiO₂化を防いで、Ti(OH)₆²を直接形成し、バリウムイオンとの反応による結晶化を低 温で実現させることが可能となり、高結晶性シングルナノ粒子が得られたと考えられてい る。一般的に、チタン酸バリウムは、水溶液系での合成において、溶解度曲線に従って、 熱力学的に安定な相として得られる^[4,12]。つまり、高いpHの溶液中ほどチタン酸バリウムの 形成が容易に進む。自らが高pHを示す水酸化バリウム八水和物をバリウム源として用いる

ことにより、速い速度で反応が起こり、より小粒径のチタン酸バリウム結晶を得ることが できる。また、水酸化バリウムは溶解度が高く、イオンとして安定に存在できることも利 点として挙げられる。今回使用している溶媒は水ではなくエタノールや2-プロパノールであ るが、どちらも高い極性を有する溶媒であり(溶解度パラメータδ; δ_{エタノール}=10.2, δ_{2プロパノール} =11.2)、水溶媒と同様に前駆体物質がイオンに解離しやすく、高いOH濃度中での反応が可 能である。また、チタン酸バリウムの水熱合成においては、水由来のOH基による粒内ポア の形成がしばしば問題となっているが、有機溶媒を用いることによりポアの形成を最小限 にとどめることが可能である。実際に、エタノール、2プロパノールを溶媒として用い、水 酸化バリウム八水和物をバリウム源に、上述した合成スキーム(Figure 4-1)によりチタン酸バ リウムの合成を試みた。このとき、それぞれの溶媒に、2-メトキシエタノールを25:6の割合 で加えて混合溶媒とした。2-メトキシエタノールはアルコキシドの溶解に適しているために 用いた。その結果、Figure 4-11に示すように、どちらを溶媒として用いた場合にもチタン酸 バリウムが単相で形成されていることが確認された。(111)ピークの比較により、エタノー ルを溶媒として用いたほうがピークがブロードであり、より小粒径のチタン酸バリウムが 得られたことが推測される。TEMによる形状観察の結果(Figure 4-12)、エタノールを溶媒に 用いた場合には7-10 nmの粒子が、2プロパノールを溶媒に用いた場合には10-15 nmの粒子が 観察されており、XRD測定結果と同様の傾向が得られた。いずれにしても、水酸化バリウ ム八水和物をバリウム源とした場合にも、10 nm程度のチタン酸バリウム粒子が形成可能で あることが示された。ただし、動的光散乱による粒度分布測定を、得られたチタン酸バリ ウムスラリーに対して行ったところ、Figure 4-13に示すように、ゾルゲル法で得られた5 nm のチタン酸バリウムスラリーの単分散状態を模倣することは出来ず、凝集が形成されてし まうことが問題点として残った。なお、粒度分布測定は、合成直後に得られた生成物を溶 媒とともに取り出して測定を行ったため、溶媒やスラリーのpH、希釈率などを一定に定め られていない。これらの条件を最適化することで、スラリーの分散状態を良好にすること も可能であると考えられる。



Figure 4-11. XRD patterns of BaTiO₃ powders synthesized by using barium hydroxide octahydrate as Ba precursor and several solvents.



Figure 4-12. TEM images of BaTiO₃ powders synthesized by using barium hydroxide octahydrate as Ba precursor and, (a) ethanol solvent and (b) 2propanol solvent.



Figure 4-13. Particle size distribution of obtained BaTiO₃ slurries.

以上のように、溶解度パラメータの高い有機溶媒を用いることにより、前駆体として使 用した水酸化バリウム八水和物のバリウムイオンへの解離が容易に起こり、シングルナノ レベルの小粒径チタン酸バリウムが形成されることが確認された。ただし、バリウム源の 選択も合わせて重要であり、溶媒中でのバリウムイオンへの解離が容易に起こりやすい物 質(水酸化バリウム八水和物)を使用することにより、バリウムアルコキシドを用いた場合の ような小粒径のチタン酸バリウムが形成されると考えられる。

4.4 結論

Kuwabara らの研究結果と同様に、高濃度ゾルゲル法におけるチタン酸バリウム合成時に は、あらかじめ形成された TiO₆ 八面体構造中にバリウムが拡散することにより結晶化する ことが確認された。実際に、チタンアルコキシドを加水分解させた後に系内にバリウム源を 加えてもチタン酸バリウムが形成されること、チタン源として、石原産業製の比表面積 350 m²/g、粒子径 5-7nm のアナターゼ型二酸化チタン LU234 を用いても、チタン酸バリウムが 形成されることなどからも、妥当なメカニズムと考えられる。また、バリウム源の変更を試 みたところ、水酸化バリウム八水和物を用いることで、バリウムアルコキシドを用いた場合 と同様に 10 nm 程度の小粒径粒子が得られることが確認された。ただし、溶媒内での解離 が難しい酢酸バリウムを用いた場合にはチタン酸バリウムが得られなかったことから、バリ ウム源の選択も重要であることが示唆された。以上のように、チタン源、バリウム源として アルコキシド以外の安価な物質を用いた場合でも、種類の選択により、シングルナノレベル の小粒径チタン酸バリウムが形成されることが確認された。しかしながら、いずれの場合に も、分散性が課題として残っており、アルコキシドを用いた高濃度ゾルゲル法で得られるチ タン酸バリウムスラリーと同程度のものを得るには至らなかった。今後の研究方針として、 二つのアプローチが考えられる。ひとつは、チタン源の更なる改良により、TiO₆ 八面体の 構造の最適化を行い、バリウム源の入りやすい(反応が起こりやすい)状態を作り、得られる チタン酸バリウムの分散性への寄与を調べることである。もうひとつは、現在までの実験結 果で得られた分散性が充分でない小粒径チタン酸バリウムを、少量の分散剤を用いることで 高分散化させることである。これらの実験により、高濃度ゾルゲル法に匹敵する、高結晶・ 高分散・小粒径のチタン酸バリウムナノ粒子の合成法が確立するものと期待される。

参考文献

[4.1] 桑原誠, 倉田奈津子, 緒方道子, 山下洋子, 有村雅司, セラミックス, 2001, 36, 412-416.

- [4.2] 高橋誠治, 大村英毅, 三木健嗣, 下岡弘和, 桑原誠, J. Ceram. Soc. Jpn. 1994, 102, 1182-1184.
- [4.3] 下岡弘和, 桑原誠, J. Ceram. Soc. Jpn. 1997, 9, 811-814.
- [4.4] H. Shimooka and M. Kuwabara, J. Am. Ceram. Soc. 1995, 78, 2849-2852.
- [4.5] K. G. Caulton, M. H. Chisholm, S. R. Drake, J. C. Huffman, *Chem. Commun.* 1990, 21, 1498-1499.

[4.6] H. Shimooka, S. Kohiki, M. Kuwabara, J. Ceram. Soc. Jpn. 2001, 109, 60-65.

[4.5] R. B. Greegor, F. W. Lytle, D. R. Sandstrom, J. Wong, and P. Schultz, *J. Non-Cryst. Solids* **1983**, *55*, 27-43.

[4.6] Z. Liu and R. J. Davis, J. Phys. Chem. 1994, 98, 1253-1261.

[4.7] F. Babonneau, S. Doeuff, A. Leaustic, C. Sanchez, C. Cartier, and M. Verdaguer, *Inorg. Chem.* **1988**, *27*, 3166-3172.

[4.8] J. A. Tossell, D. J. Vaughan, and K. H. Johnson, Am. Mineral. 1974, 59, 319-334.

[4.9] Y Songhak and B Sunggi, J. Am. Ceram. Soc. 2006, 89, 1816-1821.

[4.10] K. Kobayashi, T. Suzuki, and Y. Mizuno, *Appl. Phys. Express* **2008**, *1*, 041602.

[4.11] T. T.Lee, C. Y. Huang, C. Y. Chang, S. P. Lin, C. Y. Su, C. T. Lee, and M. Fujimoto, *Jpn. J. Appl. Phys.* **2011**, *50*, 091502.

[4.12] M. M. Kncka and R. E. Riman, Chem. Mater. 1993, 5, 61-70.

第5章

Mn 添加チタン酸バリウムナノ結晶から作製した

誘電体薄膜の微細構造および特性評価

第5章 Mn 添加チタン酸バリウムナノ結晶から作製した

誘電体薄膜の微細構造および特性評価

5.1 はじめに

第4章まででは、チタン酸ナノ結晶の合成に着目した。今後のデバイス応用への期待が 高まるナノシート構造体の形成を達成するため、寒天ゲルマトリクスを反応場として用い ることで、新規かつ低コストな合成方法を見出した。また、デバイス応用に理想的な小粒 径・高結晶・高分散性のチタン酸塩合成法としてゾルゲル法に着目し、ナノ粒子の形成メカ ニズムを解明した。

本章と第6章では、チタン酸ナノシートのデバイス応用を視野に、適用先として最も可 能性が高いと考えられる誘電体薄膜に着目し、検討を進めた。「1.5.3 ナノ粒子堆積法を用 いた誘電体薄膜の形成」に述べたとおり、本研究では、誘電体薄膜の形成法としてナノ粒 子堆積法を高く評価しており、ナノシートに代表される各種ナノ結晶の薄膜化が容易かつ 高品質で達成されるものと確信している。

これまでの研究より、ゾルゲル法を用いることで 5nm 程度の高結晶化ナノ粒子(ナノクリ スタル)のチタン酸バリウムを形成し、単分散スラリー化して電極基板上で塗布・熱処理を繰 り返すことで一定の膜厚を有する誘電体薄膜が形成された^[5.1,2]。得られた薄膜は、下部電極 基板に対して結晶学的に配向する方位を向いたものが隣接の粒子を取り囲みながら優先的 に成長し、部分的に配向した柱状構造を有する緻密膜となっていた。また、この薄膜上に 上部電極を成膜し、測定プローブを当てて電機特性を評価した結果、10 kHz における比誘 電率は 635、誘電損失は 0.7%であり、良好な特性を示した。

以上の結果を受け、ナノ粒子堆積法による誘電体薄膜の形成と実用化を目指し、検討を 進めてきたが、現在、一般的に薄膜キャパシタの電極として用いられている Pt は高価であ り、実用化への障害になる(Figure 5-1)。一方で、Ni や Cu は MLCC の電極材料として用い られている実績があり、地殻内存在量が多く価格も低い金属である。また、これらの金属 は低い抵抗率を有し、高周波応用への期待が持たれる薄膜キャパシタの電極材料として代 替されることが期待される。しかしながら、Ni や Cu は酸化しやすく、酸素分圧の低い雰囲 気下での熱処理が必要となる^[5.3]。低酸素分圧下での熱処理は、誘電体層として用いるチタ ン酸バリウムの還元を容易にし、結果的に高いリーク電流密度やショートの原因となりう る。そこで、誘電体層に耐還元性を付与する目的で、アクセプターを添加する必要が生じ る^[54-7]。本章では、耐還元性付与のための添加剤として Mn イオンを添加したチタン酸バリ ウムナノクリスタルの作製と、誘電体薄膜形成ののちの構造、誘電特性評価を行った結果 を示す。その際、電極として Pt、Cu を用い、それぞれについて得られた薄膜の特徴を述べる。



Figure 5-1. Abundance and unit price of rare metal.

ここで、Mn イオンの添加効果について考察する。Mn イオンは、2 価、3 価、4 価の価数 を取りうる物質であり、チタン酸バリウムのペロブスカイト格子内に添加することで、Ti サイトに優先的に導入されることが知られている^[5.4-7]。Ti サイトに2 価の Mn イオンを置換 することで、以下のように酸素空孔 V^{••}o が形成される。酸素空孔 V^{••}o を導入しておくこと で、酸素が還元されにくくなり、コンデンサーにとってリーク源のひとつである電子 e⁻の生 成を抑制することが出来る。Mn イオン 1 at%添加薄膜でリーク特性が向上した理由は、以 上の効果から説明できる。

 $MnO \rightarrow Mn^{"}Ti + O_{O} + V^{\bullet \bullet}O$

 $O_0 \xrightarrow{} 1/2O_2 \uparrow +V^{\bullet \bullet}o + 2e^-$

このような Mn イオンの添加効果について、過去に報告された研究論文を紹介する。

< Effects of Mn dopant on the leakage current properties in SrTiO3 thin films. ^[5.5]>

Morito らは、RFスパッタリングにより 100 – 200 nm の Sr(Ti_{1-x}Mn_x)O_y (x = 0, 0.002, 0.01, and 0.05) 多結晶薄膜を形成し、Mn イオンの添加効果について考察している。Mn イオンは Ti サイトに低い価数で置換しており、高濃度で添加するほど高電界領域におけるリーク電流 特性の向上が見られることが明らかになった。さらに、Mn イオンの添加により、電子伝導 メカニズムが二つのモデルに分類されることがわかった。Mn イオンの濃度がx = 0.01以下 の低濃度領域では、表層において熱電子放出によるショットキー効果が有効になり、Mn イ

オンの濃度が x = 0.05 と高濃度の場合に限り、空間電荷制限電流モードが有効であることが 確認された。これらのメカニズムの変化は、Sr(Ti_{1-x}Mn_x)O_y 薄膜の絶縁特性の向上によるも のであり、Mn イオンをアクセプターとしてドープすることにより形成された酸素空孔の補 償によるのではないかと考えられる。

<Large dielectric tunability and microwave properties of Mn-doped (Ba,Sr)TiO₃ thin films. ^[5.6]>

Yuan らは、(001)配向 MgO 基板上にパルスレーザーデポジションによって Mn イオンを 2 %添加した Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO₃薄膜を形成し、Mn イオンの添加効果を考察している。得られた 薄膜は c 軸方向にエピタキシャル成長しており、急峻な界面を形成することが XRD, TEM 測定により確認された。周波数 1 MHz における室温の誘電特性を評価した結果、40 KV/cm において 80 %と非常に高いチューナビリティを示し、比誘電率 3800、誘電損失 0.001 と優 れた特性を有することが確認された。10-30 GHz の高周波数における測定でも、比誘電率 の高さと誘電損失の低さが示された。

以上のように、Mn イオンを添加することで、チタン酸バリウムの還元性を抑制すること が可能であるため、Cu 電極使用時など還元雰囲気での熱処理が必要な際に、チタン酸バリ ウムの組成設計に使用される。その他にも、ペロブスカイト型チタン酸バリウムの耐還元 性付与に用いられる添加物として、Table 5-1 のような元素が用いられ、アクセプターとし て機能することが知られている。その中でも、Mn イオンは上述したように 2 価、3 価、4 価を取りうる物質であり、自己制御的機能を有するため、ペロブスカイト格子内に安定し た状態で入りやすいと考えられている。

	acceptor dopants
Ti site	Al (Al ³⁺), Mg (Mg ²⁺), transition metals (Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Co ³⁺ , etc.)
Ba site	alkali metals (Na⁺, K⁺, etc.)

Table 5-1. acceptor dopants available for BaTiO₃ perovskite.

5.2 実験方法

5.2.1 原料

Table 5-2 に本実験で用いた試薬を示す。

Material	Chemical formula	Purity	Manufacturer
Barium diethoxide	$Ba(OC_2H_5)_2$	> 99 %	Kojundo Chemical Lab.
Titanium tetra-iso-propoxide	Ti(O-i-C ₃ H ₇) ₄	99 %	Kojundo Chemical Lab.
Manganese di-iso-propoxide	e Mn(O-i-C ₃ H ₇) ₂	99 %	Kojundo Chemical Lab.
Ethanol (dehydrated)	C_2H_5OH	> 99.5 %	Kanto Chemical
2-Mathoxyethanol	CH ₃ OCH ₂ CH ₂ OH	> 99 %	Kanto Chemical

Table 5-2. List of reagents used in this chapter.

5.2.2 実験手順

まず、ナノ粒子堆積法に用いるチタン酸バリウムナノクリスタルの合成手順を示す。5 nm 程度の結晶性粒子を有機溶媒中に単分散状態で存在させることが可能なゾルゲル法により、 Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルを合成した。バリウムエトキシドとテトラ イソプロポキシチタンを等モル量で秤量し、エタノール 25 cm³と2メトキシエタノール 6 cm³の混合溶液中に溶解させ、0.5 mol/dm³の濃度の前駆体溶液を作製した。これに、チタン 源に対して所定の濃度でマンガンジイソプロポキシドを混合し、室温下で16 時間攪拌させ ることで3 種類の試薬を完全に溶解させた。ここまでの作業は、各アルコキシドの水分と の反応を避けるため、N₂ 置換されたグローブボックス内にて行った。得られた前駆体溶液 に、25 ℃に保持した状態でエタノールと水の混合溶液を滴下し、加水分解を行ったのち、 50 ℃のオイルバス中でエージングを1日間行った。加水分解により、重合反応が進み前駆 体溶液は完全にゲル化し、50 ℃でのエージングにより、ゲル内から水分が吐き出されてゲ ルの収縮が起こり、結晶化が完了する(Figure 5-2)。以上の工程により、Mn イオン添加チタ ン酸バリウムナノクリスタルを合成した。


Figure 5-2. States of precursor solution; (a) before hydrolysis, (b) after hydrolysis and (c) after aging at 50 $^{\circ}$ C.

得られたゲルを溶媒から取り出し、3 wt%の濃度で2 メトキシエタノール中に加え、90 分 間超音波照射を行うことで、ゲルを解してナノクリスタルが分散した透明溶液を得た。こ れをナノ粒子堆積法による薄膜形成に用いるチタン酸バリウムナノクリスタルスラリーと した。

次に、チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを用いた薄膜形成手順を示す。

基板には、(0001)一軸配向性のサファイア基板を用いた。また、下部電極に使用する金属 として Pt と Cu を選定した。Pt を下部電極として用いる場合は、あらかじめサファイア基 板上に TiO₂ アモルファス相を 2 nm 程度でスパッタリングにより成膜してバリア層とした。 この上に、アルゴン雰囲気中において 250 nm の厚みで Pt をスパッタリングにより成膜し、 Pt/TiO₂/Al₂O₃ 下部電極を作製した。また、Cu を下部電極として用いる場合は、サファイア 基板上にスパッタリング法により 250 nm の厚みで直接 Cu を成膜し、Cu/Al₂O₃ 下部電極基 板とした。

得られた下部電極基板上にチタン酸バリウムナノクリスタルスラリーをスピンコーティングにより塗布した。スピンコーティングは 1000 rpm で 30 秒間行った。その後 500 ℃に加熱したホットプレート上に基板を乗せて溶剤の乾燥を行い、スピンコート・乾燥を5 回繰り返した。Pt 下部電極基板を用いた場合は、スピンコート・乾燥工程は大気雰囲気下で行ったが、Cu 下部電極基板を用いた場合は、Cu の酸化を抑制するために 500 ℃での乾燥処理は N₂ 置換されたグローブボックス内にて行った。スピンコート・乾燥工程を 5 回繰り返したのち、熱処理を行った。Pt 下部電極基板を用いた場合は、大気雰囲気下で 800 ℃10 分間、Cu 下部電極基板を用いた場合は、1.5 %H₂/N₂ガス雰囲気下で 850 ℃2 時間の処理を行った。以上の工程を 5~6 回繰り返し、合計 25~30 層の Mn イオン添加チタン酸バリウム誘電体膜上に上部電極として Pt を 200 nm の厚さでスパッタリング法により成膜した。

5.2.3 評価

得られた粒子、薄膜の評価を以下に示す方法により行った。

1) X 線回折

得られた粉末試料の生成相および結晶性の評価は、粉末 X 線回折装置(XRD, リガク RINT2500)により行った。測定条件は、線源 CuKa、電圧 50 kV、電流 100 mA、ステップ角 0.02°、測定 20 範囲 20 – 90°とした。また、作製した誘電体薄膜の結晶相および結晶配向の 評価は、薄膜 X 線回折装置(MRD, PANalytical X'pert)により行った。測定条件は、線源 CuKa、 電圧 45 kV、電流 40 mA、ステップ角 0.001°、測定 20- ω 範囲 20 – 90°とした。誘電体薄膜の 結晶配向評価は、X 線極点測定により行った。ある結晶の 20- ω ピークに対して、psi と phi をスキャンすることでポールフィギュアを取得した。

2) 形態観察

粒子および薄膜の形態観察は、走査型電子顕微鏡(FE-SEM, 日立 S-4500, ZEISS SUPRA35VP)と透過型電子顕微鏡(FE-TEM, 日本電子 3000F, 日本電子 2100F)を用いて評価 した。観察を伴う組成分析にはエネルギー分散型 X 線分析装置(EDS)を用いた。

3) 粒度分布測定

ナノクリスタルスラリーの粒度分布は、あらかじめ超音波で充分に分散させた後、ナノ トラック粒度分布測定装置(UPA,日機装 UPA-EX150)を用いることにより、動的光散乱法を 測定原理として測定した。

4) 定性·定量分析

ゲルやスラリー内に含まれる成分の定性・定量分析には、ICP 発光分光分析装置(Thermo Fisher Scientific K. K., iCAP6500)を用いた。前処理として、ホットプレート上にて試料を蒸発乾固させ、塩酸、硝酸を加えて加熱溶解させたのち測定を行った。

5) 電気特性評価

0.5 mm φ の Pt を誘電体薄膜上にスパッタリングにより成膜し、上部電極とした。リーク 電流特性は、40 °Cに基板を温め、R6246pA(Advantest)により各電圧に印加したのち 1 秒後 の値を読み取った。誘電率評価は、HP4284A LCR(Agilent Technologies)により周波数 10 kHz、 振幅 100 mV、印加電圧 0 V として AC シグナルを読み取った。

5.3 実験結果と考察

5.3.1 Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルのキャラクタリゼーション

ゾルゲル法により Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルを合成した。第4章で 述べたように、加水分解温度を調整することにより、5 nm と 10 nm のチタン酸バリウムを 作り分けることが可能であることまで確認できている。本章では、ナノ粒子堆積法による 誘電体薄膜形成のための誘電体材料として 5 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルのみを 用いるが、Mn イオンを添加した際のゾルゲル反応の挙動の Mn イオン無添加時との差異を 調べるため、5 nm と 10 nm の合成条件それぞれで Mn イオン添加チタン酸バリウムを合成 した(5 nm 合成条件; 加水分解温度 25 ℃、10 nm 合成条件; 加水分解温度-20 ℃)。なお、 Mn イオンは Ti 源に対して 1 at%の濃度で加えた。その結果、Figure 5-3 に示すように、Mn イオン無添加時と同様に、それぞれの合成条件で 5 nm, 10 nm 粒子の作り分けが可能である ことが確認された。また、得られたナノクリスタルスラリーは Mn イオン無添加時と同程度 の高い分散性を有することが示された(Figure 5-4)。



Figure 5-3. TEM images of Mn-doped BaTiO₃; (a) 10 nm crystals and (b) 5 nm crystals.



Figure 5-4. (a) 5 nm crystal slurry after ultrasonication and (b) particle size distribution of 5 nm crystal slurry measured by UPA.

それぞれの合成条件により作製したゲルを乾燥させて粉末状にし、粉末 X 線回折にて結 晶型の同定を行ったところ、Figure 5-5 に示すように、いずれも立方晶チタン酸バリウムで あることが確認された。チタン酸バリウム(110)ピーク位置を比較すると、Mn イオンの有無 によらずほぼ同様であり、Mn イオンの添加による格子の膨張・収縮などが起こらなかった ことを示している。また、若干のピーク強度の差異は見られたものの、明らかな結晶性の 低下も見られなかった。



Figure 5-5. XRD patterns of 5 nm and 10 nm Mn-doped BaTiO₃ powders.

以上のように、ゾルゲル法を用いることで、Mn イオン添加の有無によらず、5 nm, 10 nm のチタン酸バリウムが作り分けられることが確認されたが、Mn イオンの存在箇所が明確に なっていない。そこで、ゾルゲル反応後(50℃でのエージング後)の生成物をゲルと溶媒とに 分け、それぞれの成分を ICP 分析により測定した。その結果、Mn イオン成分のうち 99.1 % がゲル内に存在することが確認され、上述した 5 nm, 10 nm で得られたチタン酸バリウム粒 子が何らかの形で Mn イオン成分を含有することが推定された。また、乾燥ゲルを 800℃で 1 時間熱処理したのちもチタン酸バリウム単相で存在しており、Mn イオン成分が単独で異 相を形成することが無かったことから(Figure 5-6)、Mn イオンはチタン酸バリウム格子内に 固溶しているものと考えられる。



Figure 5-6. XRD patterns 5 nm BaTiO₃ gel after annealed by 800 °C.

次に、Mn イオンの添加量による生成物への影響を調べた。Mn イオンを、Ti 源に対して 1.0, 2.0, 10.0 at%の割合で加え、ゾルゲル反応によりゲルを得た。生成したゲルは、Mn イオ ンの添加量が増すにつれて濃い灰色になり、また反応後の溶媒はいずれのサンプルにおい ても無色透明であったことから、Mn イオンがゲル内に存在するものと考えられる。ICP 分 析結果からも、溶媒内には Mn イオン成分がほとんど残存していないことが確認されている。 乾燥ゲルを粉末化して XRD 測定を行ったところ、いずれも立方晶チタン酸バリウムパター ンが得られ、添加量によらずチタン酸バリウムが単相で生成することがわかった。また、 乾燥ゲルを粉砕し、比表面積を BET 法により測定したところ、いずれの試料も 120 – 130 m²/g であり、Mn イオン無添加の 5 nm 粒子と同程度であった。湿潤ゲルを 2 メトキシエタノー ルに分散させたそれぞれのスラリーを、TEM 観察用グリッドに乗せて乾燥させ、TEM 観察 を行ったところ、5 – 6 nm 程度の一次粒子が分散した状態が観察された(Figure 5-7)。800 ℃ での熱処理ののちもチタン酸バリウム単相を保持しており、1 at%添加時と同様に、Mn イオ ン添加量を 10 at%まで上昇させても、生成するチタン酸バリウム内に Mn イオンは固溶する ものと考えられる。



Figure 5-7. TEM images and particle size distribution; (a) Mn 1at%, (b) Mn 2 at%, and (c) Mn 10 at%.

5.3.2 Pt 電極上における Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜の構造と誘電特性

5.3.1 に示したように、ゾルゲル法によりチタン酸バリウムナノクリスタルを合成する際 に Mn イオンを添加した場合も、無添加の場合と同様に、5 nm, 10 nm の高い結晶性を有す るチタン酸バリウムが単分散状態で得られることが確認された。また、Mn イオンは、確認 した限りでは最大で 10 at%までチタン酸バリウム格子内に固溶しているであろうことが推 測された。そこで、Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを用いて、実 際に誘電体薄膜を形成し、薄膜のミクロ・マクロな構造への影響を調べた。Mn イオン添加 の意義として安価な Cu や Ni 電極への応用を掲げているが、第一段階の検討として、これ まで下部電極として用いていた Pt 上での構造・特性を見極めるため、Pt/TiO₂/Al₂O₃ 基板上に 薄膜を形成した。

まず、5.3.1 で合成した Mn イオン添加量 1.0, 2.0, 10.0 at%のチタン酸バリウムナノクリス タルスラリーを、実験手順で示した方法により、Pt/TiO₂/Al₂O₃ 基板上に塗布・乾燥・熱処理を 行うことにより合計 25 層のチタン酸バリウム薄膜を形成した。その結果、いずれの 5 nm 粒子も熱処理により粒成長こそするものの、Figure 5-8 に示すように、Mn イオン無添加時 のような粒成長挙動を示さず、Mn イオン添加量を増やすほど成長が抑制され、Mn イオン 10 at%添加薄膜では、いびつな細長い形状を取っていた。偏光解析法により膜厚および充填 率を測定したところ、SEM 観察結果と同様に、Mn イオン添加量の増大とともに粒成長が抑 制され、膜厚変化率が減少する傾向にあった。しかし、Mn イオン 10 at%添加薄膜では、粒 成長の仕方が他と異なるためか、膜厚・充填率ともに Mn イオン無添加薄膜程度の値を示し た(Table 5-3)。



Figure 5-8. SEM images of BaTiO₃ thin films surface; (a) non-doped,(b) Mn 1 at% doped, (c) Mn 2 at% doped, (d) Mn 10 at% doped.

	concentration of Mn additive (at%)				
	0	1.0	2.0	10.0	
thickness (nm)	270	219	181	262	
filling rate (%)	96	66	23	96	

Table 5-3. thickness and filling rate of BaTiO₃ thin films.

上述したように、ICP 分析結果や熱処理後の粉末 XRD 測定結果より、本研究で作製した Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルは、Mn イオンをペロブスカイト格子内に 含有することが示唆された。そこで、次に、このナノクリスタルを用いて薄膜を形成した のち、Mn はペロブスカイト格子内で何価のイオンとして存在しているのかを調べるため、 X 線光電子分光法(XPS; ULVAC-PHI Quantera SXM)により、得られた薄膜の価数評価を行っ た。XPS スペクトルでは、イオンの存在状態(価数)によりピーク位置が異なるため、価数評 価を行うことが可能である。Mn は、2 価で 640.7 eV、3 価で 641.6 eV、4 価で 642.6 eV にピ ークを有する。測定の結果、Figure 5-9 に示すように Mn²⁺に由来するピークが検出され、い ずれの添加量の場合も、Mnは主に2価で存在することが示唆された。したがって、当初の 狙い通り、チタン酸バリウム薄膜内において、Mn²⁺はアクセプターとして耐還元性付与に 寄与すると考えられる。



Figure 5-9. XPS spectra corresponding to the Mn $2p_{3/2}$ and $2p_{1/2}$ binding energies of Mn-doped and nondoped BaTiO₃ thin films.

得られた Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜上に、0.5 mmφの Pt を 200 nm 程度の厚み でスパッタリングにより成膜して上部電極とし、上部電極と誘電体層の密着性を上げるた めに 450 ℃で 30 分間熱処理したのちに電気特性評価を行った。その結果、23 %と充填率が 非常に低かった Mn イオン 2 at%添加薄膜ではすべて短絡してしまっており、特性評価が出 来なかった。また、第1章で述べたとおり、Mn イオン無添加薄膜は耐電圧が低く、5V 程 度の印加で短絡してしまった。このときの比誘電率は 300 程度だった(なお、第1章では同 じ組成の薄膜が比誘電率 635 を示すと述べたが、膜厚が今回よりも厚く設定されている)。 これに対し、Mn イオン 1 at%添加薄膜では、印加電圧 12 V 付近が耐電圧であり、比誘電率 は 600 程度だった。これらの薄膜の結果より、Mn イオンの添加により、確かにリーク特性 が改善されたことがわかる。しかしながら、Mn イオン 10 at%添加薄膜では、耐電圧が 5V 程度にまで低下しており、10 at%程度まで過剰に添加すると、逆にリーク特性が低下するこ とが確認された。これは、添加した Mn イオンの余剰分が、チタン酸バリウム粒界に存在し、 リークパスとして作用したためと考えられる。

以上のように、Mn イオン添加量 1.0 at%でリーク特性が向上することが確認されたが、 Figure 5-8 で示したように、Mn イオンの添加によってチタン酸バリウムナノクリスタルの 粒成長は抑制され、高結晶化とそれに伴う高誘電率化が阻害されることがわかった。そこ で、さらに添加量の最適化を進めたところ、Ti に対して Mn イオン添加量を 0.5 at%とする ことで、リーク特性の向上と結晶成長抑制の最小限化が同時に叶い、高い誘電率を有する 薄膜が得られることを見出した。以下、Mn イオン添加量 0.5 at%で作製したチタン酸バリウ ム誘電体薄膜の微細構造・特性評価結果を示す。

Figure5-10 (b)に薄膜形成ののちの表面 SEM 像を示す。Mn イオン無添加時の薄膜表面と

比較すると、5 nm 程度だったナノクリスタルが、どちらの薄膜においても平均 150 nm にま で粒成長し、緻密な粒界を形成していることが確認され、Mn イオン 0.5 at%の添加であれば、 粒成長阻害には大きな支障を来たさないことが示された。また、得られた薄膜の断面を TEM 観察したところ、表面 SEM 像に見られたのと同様に、緻密な膜を形成しており、Mn イオ ン無添加時のような柱状構造を形成して緻密化していることが確認された(Figure 5-11(a))。 さらに詳細な断面構造を高分解 TEM 像にて確認したところ、Figure 5-11(b)に示すように、 下地として用いた Pt 電極の配向の影響を受け、柱状のチタン酸バリウムは[111]方向に優先 的に配向していることがわかった。しかしながら、XRD 逆格子マッピング像より、チタン 酸バリウムの配向状態を評価したところ、(111)配向が優勢であることには変わりなかった が、(100)や(110)配向も存在しており、すべての柱状粒子が同一方向に配向しているわけで はなかった(Figure5-12)。いずれにしても、(111)への優先配向の傾向も Mn イオン無添加薄 膜と同様であり、Mn イオン添加量 0.5 at%であれば、5 nm ナノクリスタルの粒成長・微細構 造への影響は現れないことが確認された。



Figure 5-10. SEM images of surface structure of BaTiO₃ thin films; (a) nondoped and (b) Mn 0.5 at% doped.



Figure 5-11. Cross-sectional TEM images of the Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film; (a) bright-field and (b) high-resolution images of the interface between the BaTiO₃ and Pt layers.



Figure 5-12. Two-dimensional X-ray reciprocal space map of the Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film.

次に、薄膜内における Mn イオンの存在箇所を同定するため、断面 STEM 像を用いて EDS マッピングを行った(Figure5-13)。その結果、Mn イオンの添加量は 0.5 at%と非常に少ない ため、測定に使用した EDS の分解能の問題で、ノイズ程度にしか検出できなかったものの、 Mn イオンは薄膜全体に渡って均一に検出され、偏析箇所は見受けられなかった。したがっ て、5 nm ナノクリスタルの状態で予想された結果と同様に、薄膜形成ののちも Mn イオン はチタン酸バリウム格子内に分布しているであろうことが示唆された。なお、Figure 5-13 の Mn K の EDS マッピング像において、電極である Pt 膜部分にも Mn が分布しているよう に表現されているが、EDS スペクトル上の Mn と Pt のピーク位置が一部重なる部分がある ためにこのような像が得られたのであり、実際には Pt 電極への Mn の拡散などは起こって いないことを TEM 構造解析から確認している。



Figure 5-13. EDS elemental distribution maps of the cross section of Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film using Mn K, Pt K, Ba K, and Ti K lines, and the corresponding STEM image.

以上のような微細構造・配向特性を有する Mn イオン 0.5 at%添加チタン酸バリウム薄膜の 誘電特性評価を行った。Figure 5-14 に比誘電率の周波数依存性、Figure 5-15 に 10 kHz にお ける C-V 特性を示す。10 kHz における比誘電率・誘電損失は、Mn イオン無添加薄膜で ϵ 635、 tanð 0.7%だったのに対し、Mn イオン 0.5 at%薄膜で ϵ 728、tanð 1.3%を有し、比誘電率が向 上したことが確認された。また、C-V 特性、Figure5-16 に示した I-V 特性より、Mn イオン を 0.5 at%添加することで大幅にリーク特性が向上し、Mn イオン無添加で耐電圧が±3 V 程 度だったのに対し、Mn イオンを添加することで±20 V 程度にまで上昇した。ただし、印加 電圧 0 V 付近での tanð・電流密度が低下した。その原因として、Mn イオンを添加すること で酸素空孔が形成され、電子のトラップサイトが増えたためと考えられる^[5-8]。



Figure 5-14. Frequency dependence of permittivity and dielectric loss tangent; (a) Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film and (b) nondoped BaTiO₃ thin film.



Figure 5-15. Dielectric constant and dielectric loss tangent; (a) Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film and (b) nondoped BaTiO₃ thin film.



Fugre 5-16. Leakage current density; (a) Mn 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film and (b) nondoped BaTiO₃ thin film.

以上の特性評価結果より、Mn イオンを 0.5 at%添加することで、チタン酸バリウム薄膜の 特性は大幅に向上し、リーク特性の向上のみならず、比誘電率も改善されることが確認さ れた。比誘電率が向上した原因を探るため、チタン酸バリウム層に掛かる残留応力を測定 した。応力評価は、XRD 測定により行った。結晶薄膜に応力が作用すると、結晶格子面間 隔が変化する。試料面法線と格子面法線のなす角度をプサイ角といい、結晶に応力が作用 しているとき、プサイ角を変化させたときに格子面間隔に変化が見られる。結晶薄膜に引 張応力が作用している場合は、プサイ角が大きくなるほど格子面間隔が広くなるため、回 折角 20 は小さくなる。一方、圧縮応力が作用している場合は、20 は大きくなる。実際、 Mn イオン 0.5 at%添加チタン酸バリウム薄膜の(110)ピーク部に合わせ、プサイ角の, 15, 30, 45, 60°と変化させて XRD 測定したところ、Figure 5-17 に示すようにプサイ角が大きくなる ほど格子面間隔は大きくなっており、薄膜には残留応力として引張応力が作用しているこ とが確認された。薄膜に作用する残留応力の値 σ は、等方弾性体における Hook の法則に基 づき、以下に示す式により導くことが出来る。

$$\sigma = \frac{E}{(1+\nu)\sin^2\psi} \times \frac{d_0 - d_n}{d_n}$$

※E; 弾性定数(チタン酸バリウムは 100)、n; ポアソン比(=0.23)^[5-9]

この式を基に算出したところ、Mn イオン 0.5 at%薄膜で約 0.4 GPa の引張応力、Mn イオ ン無添加薄膜で約 0.6GPa の引張応力がそれぞれ加わっていた。Mn イオン有無による比誘 電率の値の差異は、この面内応力差による電歪効果によるものと考えられる。擬似立方晶 チタン酸バリウムの電歪定数 Q_{12} は、 $-3 \times 10^2 m^4/C^2$ であり、残留応力 σ と応力フリーの膜の 比誘電率 ϵ_u 、任意の応力を有する膜の比誘電率 ϵ_f との間には以下のような式が成り立つ^[5-10]。

$$\frac{1}{\varepsilon_f} = \frac{1}{\varepsilon_u} - 4Q_{12}\sigma$$

上式より、残留応力差 0.2 GPa を当てはめると、二つの膜の誘電率差は 100 程度と算出さ

れ、Mn イオン 0.5 at%薄膜と Mn イオン無添加薄膜の比誘電率差 93 (=728 – 635)にほぼ一致 する。したがって、Mn イオン有無による比誘電率の差異は、Mn イオン添加により薄膜に 掛かる応力が変化したためと考えられる。Mn イオン添加により引張応力の値が小さくなっ た理由は、Mn と Ti のイオン半径の差異にあると考えられる。Mn²⁺のイオン半径は 0.081 nm であり、Mn²⁺に置換されたと考えられる Ti⁴⁺のイオン半径は 0.0745 nm である。Ti⁴⁺よりも サイズの大きい Mn²⁺に置き換わったことで、格子体積が膨張してチタン酸バリウム粒子の 粒成長挙動が変化し、薄膜に掛かる残留応力の緩和に寄与したと推測される。



Figure 5-17. BaTiO₃ (110) peak measured by XRD; psi = 0, 15, 30, 45, 60°

5.3.3 Cu 電極上における Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜の構造と誘電特性

5.3.2 では、下部電極として Pt を用い、Mn イオンを 0.5 at%添加したチタン酸バリウム薄膜をナノ粒子堆積法により成膜し熱処理を行うことで、5 nm 程度のチタン酸バリウムナノ クリスタルが 150 nm 程度にまで粒成長し、緻密な柱状構造を有する薄膜が形成されること が確認された。また、Mn イオンを添加することで、リーク特性の大幅な向上、応力緩和に よる比誘電率の向上など、誘電特性が改善されることも明らかになった。

「5.1 はじめに」に述べたとおり、Mn イオン添加の目的は、安価な電極 Cu や Ni の使用 に伴い、熱処理を還元雰囲気で行う必要が生じるため、チタン酸バリウム層に耐還元性を 付与することにあった。実際、5.3.2 に述べたとおり、Mn²⁺は Ti⁴⁺サイトに置換されてアク セプターとして機能しているであろうことが示唆された。そこで、5.3.3 では、Mn イオン 0.5 at%添加チタン酸バリウム薄膜を Cu 電極基板上に形成し、構造・特性への影響を調べる ことを目的とした。

まず、下部電極基板として用いた Cu/Al₂O₃の構造について示す。Cu はスパッタリング法を用いることで、室温下・Ar 雰囲気において成膜した。成膜直後の膜表面は、Figure 5-18 に示すように平坦な状態を保持しており、XRD 測定結果からは Cu(111)に強く配向した状態

であることが確認された(Figure 5-19)。Cu と Al_2O_3 の配向関係を調べるため、pole figure 像 を取得したところ、Figure 5-20 に示すように、Cu は Al_2O_3 に対してエピタキシャル成長し、 電極基板に対して[111]に配向していることがわかった。Cu(111)と $Al_2O_3(001)$ の格子ミスフ ィットは 11 %程度であり、充分にエピタキシャル成長できる格子整合性である。



Figure 5-18. SEM image of Cu/Al₂O₃ surface structure.



Figure 5-19. XRD pattern of Cu/Al₂O₃.



Figure 5-20. pole figures; (a) Al₂O₃ (001) and (b) Cu (111).

次に、上記 Cu/Al₂O₃ 基板を用いて薄膜を形成した。Mn イオン 0.5 at%添加のチタン酸バ リウムナノクリスタルスラリーを、「5.2.2 実験手順」に示す方法にて作製した。これを、 スパッタリングにより形成した Cu/Al₂O₃ 基板上にスピンコート法により塗布し、500 ℃で の乾燥を行い、数回繰り返したのちに真空中にて 800 ℃で 30 分間熱処理を行ったところ、 Figure 5-21 に示すように、5 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルは、Pt 電極基板上のよ うな粒成長挙動を示さず、20 nm 程度の粒成長に留まってしまった。



Figure 5-21. SEM images of thin films surface structure; (a) case of Cu electrode and (b) case of Pt electrode.

そこで、熱処理温度をさらに上げてチタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長を促進させることとした。その前段階の検討として、Cu/Al₂O₃ 基板を 850 ℃,900 ℃,1000 ℃にて 2時間熱処理し、Cu 電極基板の熱耐久性を確かめた。熱処理時の雰囲気は 1.5 % H₂/N₂ ガスとした。熱処理後の基板の XRD 測定結果を Figure 5-22 に示す。850 ℃,900 ℃熱処理後ではCu は(111)ピークのみが検出され、SEM 観察結果からも平坦な膜形態を保持していることが確認された。それに対し、1000 ℃熱処理後には、Cu(111)ピークに加え、Cu₂O も析出しており、膜の表面形態を確認したところ、数 μ m~数+ μ m の析出物が観察された(Figure 5-23)。析出部と平坦部とでそれぞれ EDS 測定を行ったところ、XRD 測定結果に一致するように球

状の析出物が Cu の酸化物であることが示唆された。以上の結果より、Cu/Al₂O₃の状態を保持するためには、1.5 % H₂/N₂ガス雰囲気での熱処理において、上限 900 ℃が有効であると言える。Cu の融点は 1080 ℃であることから、1000 ℃での熱処理では Cu が一部溶融し、周囲のわずかな酸素または Al₂O₃ の酸素を引き抜くことで酸化物を形成し安定化するものと考えられる。



Figure 5-22. XRD patterns of Cu/Al₂O₃ after annealing at 850 $^{\circ}$ C, 900 $^{\circ}$ C, 1000 $^{\circ}$ C.



Figure 5-23. (a) SEM image of Cu/Al₂O₃ after annealing at 1000 °C,
(b) and (c) EDS spectra of SEM images square parts.

Cu/Al₂O₃の耐熱性を考慮し、850 ℃での熱処理により、5 nm チタン酸バリウムナノクリ スタルの粒成長・緻密化を試みた。「5.2.2 実験手順」に示したとおり、1000 rpm, 30 秒間のス ピンコーティングにより 5 nm ナノクリスタルスラリーを塗布し、500 ℃での乾燥を行った のち、スピンコート・乾燥を 5 回繰り返し、1.5 % H₂/N₂ 雰囲気下にて 850 ℃2 時間の熱処理 を行った(この状態を 1 セット成膜後とする)。その結果、800 ℃熱処理時のような粒成長阻 害こそ無く、粒界を隔てるように緻密化していくことは確認されたが、Figure 5-24 に示すよ うに、緻密に粒成長した部分 Figure 5-24(b)と、粒径自体は大きく成長するものの周囲の粒 子を取り込んでしまい下地の Cu が露出してしまった部分 Figure 5-24(b)とが観察され、Pt 電極使用時のような 5 nm 粒子がほぼ均一な大きさで粒成長し緻密な膜を形成することは無 かった。2 セット目まで成膜を進めることで、緻密化・粒成長は 1 セット目と比較して促進 されたが、Pt 電極上のように 200 nm 程度までの粒成長は見られなかった。その原因は、Pt、 Cu のチタン酸バリウムスラリーとの濡れ性の差にあると考えられる(Cu のほうが濡れ性が 悪い)。そこで、チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーの塗布時のスピンコーティング の回転数を、1000 rpm から 1500 rpm にまで上げ、余分な液だまりを飛ばし、熱処理による 均一な粒成長促進を試みた。850 ℃での熱処理後、Figure 5-25(b)に示すように、1000 rpm で のスピンコート時と比較して粒径の均一性が増し、Cu をほぼ覆うほど緻密な膜となってい た。以上の結果より、Cu 電極上での 5 nm チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーの塗布 は、Cu とスラリーとの濡れ性を考慮し、1500 rpm でのスピンコートが望ましいと言える。



Figure 5-24. SEM images of 1 set BaTiO₃ surface structure.



Figure 5-25. SEM images BaTiO₃ thin film surface structure;
(a) before annealing and (b) after annealing at 850 °C.

1500 rpm スピンコート・500 ℃乾燥を5回繰り返し850 ℃での熱処理を行う工程を1セットとし、6 セットまで成膜を続けたところ、チタン酸バリウムナノクリスタルは、大きく粒成長し、最終的に、Pt 電極基板上で見られた 200 nm 程度の緻密な形態とほぼ同様の表面構造を有する薄膜が得られた(Figure 5-26)。ただし、Figure 5-26(a)に示すように、膜表面には

部分的にクラックが見られ、特性評価に影響を与えるものと考えられる。また、スピンコートの回転数を1500 rpm に上げたため、最終的に得られた薄膜の膜厚は、170 – 180 nm に留まり、Pt 電極上で1000 rpm の回転数にて6セット成膜した場合に得られる膜厚 250 – 300 nm に比べると薄い膜となった。断面構造を TEM 観察したところ、Pt 電極基板上で得られたチタン酸バリウム層のように、5 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルが粒成長し、柱状構造を有する緻密な膜を形成していることが確認された(Figure 5-27)。



Figure 5-26. SEM images of 6 set BaTiO₃/Cu/Al₂O₃ surface structure.



Figure 5-27. TEM image of BaTiO₃/Cu/Al₂O₃.

次に、得られた薄膜の結晶型を同定するため、XRD 測定を行った結果を Figure 5-28 に示 す。チタン酸バリウム層は立方晶で検出された。ただし、Figure 5-28(a)を見ても明らかなよ うに、ICDD のチタン酸バリウムパターンのピーク強度比と比較して、本研究で得られたチ タン酸バリウム層は(100)、(200)ピークが強く検出されており、ポールフィギュア像を確認 したところ、チタン酸バリウムは(100)に一軸配向している部分が存在することがわかった。 Pt 電極基板上では、チタン酸バリウムは優先配向に留まっており、(111)Cu 電極上のほうが、 より結晶配向しやすいことが示唆された。高分解能 TEM 像(Figure 5-29)より、Cu 層とチタ ン酸バリウム層の界面付近の結晶状態を観察したところ、XRD 結果と同様に、[100]方向に 配向した柱状粒子が数多く存在することが確認された。また、BaTiO₃/Cu 界面は急峻であり、 チタン酸バリウムナノクリスタルが、Cuの結晶配向状態の影響を受け、[100]方向に粒成長 したことがわかる。



Figure 5-28. (a) XRD pattern of Mn^{2+} 0.5 at% doped BaTiO₃/Cu/Al₂O₃ and (b) pole figure of BaTiO₃ (100).



(100) BaTiO_3 [011] // (111) Cu [011]

Figure 5-29. High-resolution cross-sectional TEM image of Mn²⁺ 0.5 at% doped BaTiO₃/Cu/Al₂O₃.

以上のように、Cu/Al₂O₃を電極基板として使用した場合も、基板への濡れ性や雰囲気の 差異による粒成長温度の違いに多少の変化が見られたものの、Pt/Al₂O₃上と同様にチタン酸 バリウムナノクリスタルは大きく粒成長し、電極の配向状態に合わせて、特定の面から優 先的に柱状構造を取ることが確認された。ここで、Cu 電極上に形成されたチタン酸バリウ ム層内における Mn イオンの存在状態を明らかにする。Pt 電極上では、XPS 測定結果から Mn は主に 2 価のイオンとして存在しているであろうことが示唆された(Figure 5-9)。Cu 電極 上でも、Figure 5-30(a)に示すように主に 2 価での存在が示唆されたが、Mn イオン添加量が 0.5 at%と少ないため、明確なピークとして得られなかった。そこで、さらにチタン酸バリ ウム層内の Mn の価数を調べるため、ESR 測定(日本電子 JES-FR80S)を行った(Figure 5-30(b))。 ESR(電子スピン共鳴)は NMR と同様の原理を有し、不対電子の有無や、不対電子の濃度、 電子のエネルギー状態を測定することが出来る。また、電子軌道内の d 軌道にひとつ以上 の不対電子を持つ遷移金属(Fe³⁺, Cu²⁺, Cr³⁺, Cr⁵⁺, V²⁺, V⁴⁺, Mn²⁺, Mn⁴⁺, Ti³⁺, Co²⁺)なども ESR で検出が可能である^[5.11]。ペロブスカイト格子内(チタン酸バリウム格子内)における Mn の 存在状態を ESR スペクトルにて調べた論文^[5.12]によると、Mn は 2 価で存在する場合、Mn²⁺ の核スピン I=5/2 による超微細構造由来の 6 本のピーク(hfs と呼ぶ)と、禁制遷移による 2 つ のサブピークを有する。得られたチタン酸バリウム薄膜の ESR スペクトルより、6 本のメ インピークと 2 本のサブピークを有することは明らかであり、XPS, ESR いずれの結果から も、Cu 電極基板上においても、Mn はチタン酸バリウム薄膜内に 2 価で存在することが示 された。



Figure 5-30. (a) XPS spectrum and (b) ESR spectrum of Mn^{2+} 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film on Cu/Al₂O₃.

また、ESR スペクトルからは、超微細結合定数 A の測定により、Mn イオンの存在状態を 示すことが可能である。上述したように、分子中の不対電子の存在している近辺に核スピ ン I を持つ原子核が在ると、その微小磁場により、電子スピンのエネルギー準位がさらに 2I+1 本に分離し、これを hfs と呼ぶ。この hfs の間隔を超微細結合定数 A と言い、不対電子 が非局在化して分子中にどのように分布しているかを示す指標になる。すなわち、hfs の分 裂の大きさは、その核の上に存在する不対電子の密度に比例し、間隔が小さいほど、周囲 の Mn イオンが固体内において分散していることを示す。また、hfs 間隔のほかにも、hfs ピークのブロード化の状態により、Mn イオンの存在状態を予想することも可能である。hfs ピークのブロード化は、イオン間の双極子相互作用により起こるため、イオンがクラスタ ーなどを形成して凝集した場合に見られる。これらのことを考慮することで、Mn²⁺の BaTiO₃ 内における存在状態を考察する。まず、得られた ESR スペクトルにおいて超微細結合定数 A を測定した結果、Figure 5-31 に示すように、平均 8.5 mT であることがわかった。一般的 に、6 個の同じ配位子が原点 O の周りに正八面体を形作るように配位する場合を O_h対称場 (正八面体対称場)と言う。 O_h 対称場において、中心金属イオンの ESR スペクトルにおける A 値は、平均的に 8.7 mT 程度である^[5.11]。また、チタン酸バリウム格子内における Mn^{2+} の 分布状態を ESR により調べた研究報告によると、 Mn^{2+} をチタン酸バリウムの Ti サイトに置 換した試料の ESR の A 値は、8.5 – 9.0 mT に分布している^[5.12-15]。今回測定した Mn^{2+} の A 値は約 8.5 mT であり、 O_h 対称場における中心金属イオンの A 値と近く、 Mn^{2+} が Ti⁴⁺サイト に置換し、 O_h 対称場の中心に存在することが示唆される。また、そのピーク形状は、上述 したように 6 本のメインピークに加えて禁制遷移に由来する 2 本のピークも見られること、 ピークが非常にシャープであることなどから、凝集体を形成することなく、チタン酸バリ ウム格子内に均一に分布することが示唆された。以上の結果から、チタン酸バリウム格子 内において、 Mn^{2+} は Ti サイトに置換された状態で存在し、アクセプターとして機能してい ることが示唆された。



Figure 5-31. Hyperfine coupling constant A of Mn²⁺-BaTiO₃ ESR spectrum.

最後に、得られたチタン酸バリウム薄膜上にスパッタリングにて Pt を上部電極として塗 布し、電気特性評価を行った結果を示す。Figure 5-32 に周波数 10 kHz における I-V 特性、 C-V 特性を示す。Cu 電極上においても、比誘電率自体は 611 と比較的良好な値を有するの に対し、リーク特性と誘電損失は低下しており、誘電損失は 4.1 %を有していた。その原因 として、第一に、熱処理時の雰囲気(1.5 %H₂/N₂ 雰囲気)に合わせた Mn イオン添加量の最適 化が充分でないため、チタン酸バリウム層への耐還元性が足りなかったことが考えられる。 また、第二に、電極そのものの性質によると考えられる。すなわち、Pt と Cu の仕事関数の 差異がリーク特性に影響を与えうる。室温における Pt の仕事関数は 5.67 eV、それに対し、 Cu の仕事関数は 4.2 eV 程度である。Pt は仕事関数が Cu に比べて大きいため、BaTiO₃/Pt 界 面に高いバリア層を形成する。それに対し、Cu の仕事関数は小さいため、バリア層が形成 されにくく、リーク特性の悪化を引き起こしたのではないかと考えられる。いずれにして も、チタン酸バリウム層の絶縁性に問題があることは確かであり、Mn イオン添加量を皮切 りに Cu 電極上における組成設計をしなおす必要がある。



Figure 5-32. (a) Leakage current density of Mn^{2+} 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film and (b) dielectric constant of Mn^{2+} 0.5 at% doped BaTiO₃ thin film.

以上の結果より、Cu 電極上においても、チタン酸バリウムナノクリスタルをナノ粒子堆 積法により堆積させて熱処理を行うことで、粒成長が促進され、下地の配向性に合わせて 一部配向した柱状構造を有するチタン酸バリウム薄膜を形成することが可能になった。組 成検討が充分でなくリーク特性そのものは悪いが、比誘電率・チューナビリティは Pt 上と同 程度の値が出ることが確認された。これまでに、Cu 電極上でのチタン酸バリウム薄膜の特 性に関する論文は数報あり、いずれも高い誘電率を有することが報告されているが、今回 のケースのように、Cu 電極上でのチタン酸バリウム粒子の配向性に言及しているものは無 く^[5.16-18]、この薄膜形成法独自の膜構造であることは確かである。本結晶配向技術を使用す ることで、他の手法では得ることの出来ない高い結晶性を有するペロブスカイト誘電体薄 膜が形成されると期待され、今後の検討に期待が持たれる。

5.4 結論

ゾルゲル法を用いることで、Mn イオン添加 5 nm, 10 nm のチタン酸バリウムナノクリス タルが、粒径制御性良く合成できることが確認された。Mn イオンは最大で Ti 源に対して 10 at%までチタン酸バリウム格子内に固溶していることが示唆された。

Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜をナノ粒子堆積法により作製したところ、Mn イオ ンを 1.0 at%以下の添加量とすることで、チタン酸バリウムナノクリスタルは熱処理により 大きく粒成長し、一部結晶配向した柱状構造を有する薄膜を形成した。Mn はチタン酸バリ ウム格子内にて 2 価で存在し、アクセプターとしての機能が示唆され、実際に Mn イオン 0.5, 1.0 at%添加チタン酸バリウム薄膜はリーク特性が大幅に改善されていた。また、Mn イ オンの添加により比誘電率も向上していたが、その理由として、薄膜に掛かる残留応力が緩 和されたためと考えられる。

(111)一軸配向 Cu/Al₂O₃ 電極基板上においても、Mn イオン 0.5 at%チタン酸バリウムナ ノクリスタルは、熱処理により大きく粒成長し、一部一軸配向結晶した柱状構造を有する薄 膜が得られた。Cu 上でも Mn は 2 価でチタン酸バリウム格子内に存在することが示され、 アクセプターとしての機能が示唆された。ただし、Mn イオン添加量の検討が充分でなく、 Cu 電極上でのリーク特性向上には至らず、今後の課題として残った。

参考文献

[5.1] F. Nakasone, K. Kobayashi, T. Suzuki, Y. Mizuno, H. Chazono, and H. Imai, *Jpn. J. Appl. Phys.* 2008, 47, 8518-8524.

[5.2] F. Nakasone, T. Suzuki, K. Kobayashi, K. Kawamura, Y. Mizuno, H. Kishi, H. Chazono, and H. Imai, *Proceedings of Materials Science and Technology* **2008**, 254-261.

[5.3] N. Setter, D. Damjanovic, L. Eng, G. Fox, S. Gevorgian, S. Hong, A. Kingon, H. Kohistedtb, N.

Y. Park, G. B. Stephenson, I. Stolitchnov, A. K. Taganstev, D. V. Taylor, T. Yamada, and S. Streiffer, *J. Appl. Phys.* **2006**, *100*, 051606.

[5.4] C.-J. Peng and H.-Y. Lu, J. Am. Ceram. Soc, 1988, 71, C44-C46.

[5.5] K. Morito, T. Suzuki, and M. Fujimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 2001, 40, 5493-5496.

[5.6] Z. Yuan, Y. Lin, J. Weaver, X. Chen, and C. L. Chen, Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 152901.

- [5.7] X. H. Zhu, D. N. Zheng, W. Peng, J. Li, and Y. F. Chen, Mater. Lett. 2006, 60, 1224-1228.
- [5.8] A. K. Jonscher, J. Phys. D 1999, 32, R57-R70.
- [5.9] W. G. Jiang, X. Q. Feng, G. Yang, Z. X. Yue, and C. W. Nan, *J. Appl. Phys.* 2007, 101, 104117-104121.
- [5.10] K. Morito and T. Suzuki, J. Appl. Phys. 2005, 97, 104107.
- [5.11] 大矢博昭, 山内淳『電子スピン共鳴 素材のミクロキャラクタリゼーション」*講談社*, 1989, 207-228.
- [5.12] A. M. Slipenyuk, M. D. Glinchuk, I. P. Bykov, L. P. Yurchenko, V. A. Mikheev, O. A. Frenkel,
- V. D. Tkachenko, and E. P. Garmash, Condensed Matter Physics, 2003, 6, 237-244.
- [5.13] R. N. Schwartz, B. A. Wechsler, Phys. Rev. B 1993, 48, 7057-7069.
- [5.14] X. Tong, Y. H. Lin, S. Zhang, Y. Wang, C. W. Nan, J. Appl. Phys. 2008, 104, 066108.
- [5.15] H. Ikushima, J. Phys. Soc. Jpn. 1967, 23, 540-545.

[5.16] J. Ihlefeld, B. Laughlin, A. Hunt-Lowery, W. Borland, A. Kingon, and J. P. Maria, *Journal of Electroceramics*, **2005**, *14*, 95-102.

[5.17] P. Gonon and F. El Kamel, J. Appl. Phys. 2007, 101, 073901.

[5.18] C. L. Chen, W. H. Lee, and W. C. Wei, Journal of Electroceramics, 2005, 14, 25-36.

第6章

チタン酸バリウムナノ結晶から作製した誘電体薄膜 のホウ素添加による微細構造制御および特性評価

第6章 チタン酸バリウムナノ結晶から作製した誘電体薄 膜のホウ素添加による微細構造制御および特性評 価

6.1 はじめに

第5章では、下部電極としてCuを用いるために、低酸素分圧下での熱処理に対応可能な、 チタン酸バリウム誘電体層への耐還元性の付与を目的として、Mn イオンを Ti サイトに置換 し、アクセプターとしての効果を確かめた。Mn イオンの添加により、リーク特性は大幅に 向上することが確認され、さらに、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長挙動に影響 を与えて膜に生じる応力を緩和して比誘電率が向上することもわかった。Cu 電極上におい ても、チタン酸バリウムナノクリスタルは大きく粒成長し、Pt 電極上と同程度の比誘電率 を有することが確認された。しかしながら、下部電極基板として用いた Cu 層は、スパッタ リング法により成膜した 250 nm 程度の薄膜であり、1.5% H₂/N₂ 還元ガス雰囲気での熱処理 により酸化は抑制できるものの、熱処理により膜状態を保持できず、容易に変形する場合 が生じることが問題点として残った。Figure 6-1 に、熱処理後の Cu 層の SEM 像と EDS 分 析結果を示す。Figure 6-1(a), (b)に見られるように、熱処理後の Cu 表面はフラットな状態を 保持できず、EDS 分析により、Cu が変形して下地の Al₂O₃ が露出していることが確認され た(Figure 6-1 (c), (d))。そこで、本章では、まず、Cu薄膜の変形を抑制するため、予備実験 として、第5章と同様の手順により薄膜を形成するに当たり、チタン酸バリウムスラリー をCu下部電極基板上に塗布する際のスピンコート回転数とチタン酸バリウムスラリーの濃 度に着目し、検討を行った(「6.1.1 スピンコート回転数・スラリー濃度に着目した Cu 変形 の抑制検討」)。いずれの検討も、Cu下部電極上部に成膜するチタン酸バリウムナノクリス タルスラリーに着目し、Cu 上部に充分な量のチタン酸バリウムスラリーを塗布すれば、Cu への熱耐性を付与できるとの仮説に基づいている。予備実験ののち、チタン酸バリウムス ラリーへの焼結助剤の添加による粒成長の促進と Cu の変形の抑制を試みた。焼結助剤とし てはホウ素を用いた。



Figure 6-1. (a) and (b) SEM images of Cu/Al₂O₃ surface structure after 850 °C annealing, (c) and (d) EDS spectra of square parts of (c) image.

6.1.1 スピンコート回転数・スラリー濃度に着目した Cu 変形の抑制検討

まず、第5章に示したように、チタン酸バリウムスラリーを Cu 電極上に滴下してスピン コーティングにより成膜するが、その際のスピンコート回転数に着目した。スピンコート 回転数を 1000, 1500, 2000 rpm と変化させたが、Cu 層とチタン酸バリウムスラリーの濡れ性 が低く、Pt 電極上での最適回転数 1000 rpm では液溜まりが生じることが確認され、1500 rpm 以上での成膜が必要であることがわかった。ただし、回転数を上げるということは、一度 に塗布できるチタン酸バリウム層の膜厚が減少することにつながるため、Cu 層に付与され る熱が増大する。このため、Cu の変形が起こりやすい条件となり、その他の方法での改善 策が望まれる。

そこで次の検討として、チタン酸バリウムスラリーの濃度を上げて、一度に塗布できる チタン酸バリウム層の厚みを増加させ、熱処理時に Cu に与えられる熱量を減少させること を試みた。その結果、Figure 6-2 に示すように、標準条件であるチタン酸バリウムスラリー 濃度 3 wt%で生じる Cu の変形が、6 wt%, 9 wt%と濃度を上げることにより抑制できること が確認された。しかしながら、Cu 薄膜の変形を抑えるまでに濃度を上げてチタン酸バリウ ム層の厚さを増大させると、これまでのように、下部電極の配向に影響された基板界面か らの粒成長の促進が達成されず、ランダムに粒成長することがわかった。下地の配向の影 響を受けての高結晶化は、本成膜手法の特徴であり、これにより高誘電率が付与されるものと考えているため、チタン酸バリウムスラリーの高濃度化は回避せざるを得ない。





6.1.2 焼結助剤の添加による粒成長の促進と Cu 変形の抑制

6.1.1 に示したように、Cu 電極薄膜の変形を阻止するために、チタン酸バリウムナノクリ スタルスラリー成膜時のスピンコート回転数、スラリー濃度に着目し、検討を進めたが、 得られるチタン酸バリウム薄膜の構造を損なうことなく Cu 変形を回避することは難しいこ とがわかった。そこで、Cu 変形を抑制するための次なる検討として、「熱処理温度の低温化」 を掲げることとした。しかしながら、熱処理温度を低温化することで、Cu の変形を抑制す ることは可能になるが、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長も抑制されてしまい、 緻密な柱状構造体薄膜を得ることが困難になる。そこで、チタン酸バリウムナノクリスタ ルスラリーに添加剤を加えることで、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長を促進さ せ、低温化しても充分に所望の構造体を得ることを目的とした。本章では、チタン酸バリ ウムナノクリスタルの焼結助剤としてホウ素アルコキシドを選んだ。チタン酸バリウムに 対するホウ素の焼結助剤としての効果は過去に研究されており、いずれもチタン酸バリウ ムの粒成長促進、高結晶化による比誘電率の向上に効果を発揮すると報告されている。以 下に数報の論文を紹介する^[62-5]。

<チタン酸バリウムナノ粒子を用いた誘電体薄膜の低温作製^[6.2]>

本研究における成膜方法と同様の方法を用いることで、誘電体薄膜の低温調製を試みて いる。ただし、本研究では5nmのナノクリスタルを用いているのに対し、10nm, 20nmの チタン酸バリウムナノ粒子を用いている点で異なる。どちらもゾルゲル法を用いることで ナノ粒子を合成している。10nm, 20nmのナノ粒子を基板上に塗布して 800 ℃程度での熱 処理を行うと、5nmのナノ粒子を用いる場合と異なり、表面活性が低いため粒成長が進ま ず、基板上での緻密化が難しいことがわかっている。Figure 6-3 に5nm, 10nm, 20nm それ ぞれのチタン酸バリウムスラリーを、同一条件でスピンコーティングにより基板上に塗布 した直後と 800 ℃での熱処理を行った後の SEM 像を示す。(SEM 像は、トレース実験を行 い得られた試料を本研究内において観察したものである。)



Figure 6-3. SEM images; (a), (b) and (c) 5, 10, 20 nm films before anneal, (d), (e) and (f) 5, 10, 20 nm films after 800 °C anneal.

以上の結果を鑑み、焼結密度の向上を求めてホウ素、アルミニウムを焼結助剤として 2 メトキシエタノール中に加え、ここに 10 nm, 20 nm チタン酸バリウムを所定の濃度で添加 してチタン酸バリウムスラリーを得た。これらのスラリーを基板上に塗布し、800 ℃での 熱処理を行った結果、アルミニウムはチタン酸バリウムナノ粒子の焼結性を阻害するのに 対し、ホウ素は促進させることが確認された。また、ホウ素を 0.02 mol/dm³まで添加するこ とで、誘電率の向上が見られ、最大で 100 kHz において 240 まで上昇した。それ以上の添加 量では、上部電極と下部電極の間の絶縁性が不十分となり、特性評価に至らなかった。ア ルミニウム添加では、粒成長の阻害が見られたため、誘電率も大幅に減少した。ただし、 いずれの添加薄膜も、粒子径に対する誘電率をグラフ化すると誘電率は低くなっており、 添加元素が原因で誘電率を低下させている可能性が示唆された。

< Enhanced Dielectric and Crystalline Properties in Ferroelectric Barium Titanate Thin films.^[6,3]>

化学溶液堆積法を用いることでチタン酸バリウム薄膜を形成している。テトライソプロ ポキシチタンを Ti 源、酢酸バリウムを Ba 源とし、2,4 ペンタンジオン(アセチルアセトン) とジエタノールアミンの混合溶媒中に加えた。ここに、トリエチルボロンをホウ素源とし て所定濃度加え、前駆体溶液とした。スピンコーティングにより基板上に前駆体溶液を塗 布し、250 ℃のホットプレート上で7.5 分間乾燥させる工程を5回繰り返したのち、900 ℃ で30 分間熱処理することで薄膜を得た。得られた薄膜のXRD 測定を行ったところ、チタ ン酸バリウムと基板のCuのピークのみから構成されており、ホウ素由来の異相は検出され なかった。このことから、ホウ素はアモルファス状で酸化しているものと考えられる。ホ ウ素0-2.5%までは、添加量の増加とともにチタン酸バリウムの粒子径が大きくなってい ることが確認された。それに対し、3%以上の添加では、明らかに粒子形状が異なっていた。 2.5%までの添加で見られたチタン酸バリウム粒子に加え、500 nm 以上の粒子径を有するも のの割合が、ホウ素の添加割合を増やすごとに増加していた。このことから、この粒子は XRD で検出されなかったアモルファス状のホウ素酸化物であると考えられる。次に、ホウ 素添加量0-2%で得られたチタン酸バリウム薄膜の温度に対する誘電特性を評価した。表 面像で見られたように、2%を最大とするホウ素濃度の増量に従ってチタン酸バリウムの粒 子径の増大が確認され、XRD 測定結果からは、粒子径の増大に従いチタン酸バリウムのピ ークのスプリットが見られ、正方晶性が増すことがわかった。これにより、ホウ素無添加 では 1000 程度だった比誘電率が、ホウ素2%添加により、最大で 3000 以上を示すほどにな り、誘電率の大幅な増加が確認された。

< Dielectric properties of barium titanate ceramics doped by B₂O₃ vapor. ^[6,4]>

あらかじめチタン酸バリウムナノ粒子粉末を用意し、酸化ホウ素とともに熱処理するこ とで気化したホウ素をチタン酸バリウム格子内に拡散させる方法を取っている。チタン酸 バリウム粉末を1mm厚のペレット状に成型し、アルミナ坩堝に入れて1250℃にて2時間 熱処理を行った。その際、アルミナ坩堝の底に0.25 mol%のB2O3粉末を加えることでホウ 素を添加させた。ホウ素添加の効果として第一にキュリー点の増加が挙げられた。ホウ素 無添加時に128℃だったキュリー点が、ホウ素添加により130℃に若干ではあるが上昇し た。第二に、XRDパターンにおいてチタン酸バリウムのピークシフトが挙げられた。ホウ 素がチタン酸バリウム格子内にドープされることで、格子の膨張が見られ、全体的にピー ク位置が低角側にシフトしたことが確認された。ホウ素はイオン半径がTiやBaに比べて小 さいため、格子の膨張が見られたということは、TiサイトやBaサイトに置換されたという よりも、格子内にプラスアルファで入ったものと考えられる。

以上のように、ホウ素を添加することで、チタン酸バリウムの粒成長挙動に明らかに変 化を与え、誘電率やキュリー点などに影響を与えることが各種論文にて示されている^[6.2.4]。

第6章では、上記文献を参考に、ホウ素の添加によるチタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長促進について検討した。最終的には、熱処理温度の低温化を達成させ、Cu下部電極薄膜の変形を抑制できるほどの熱処理温度でもチタン酸バリウムナノクリスタルが粒成長し緻密膜を形成するか否かを確認した。

6.2 実験方法

6.2.1 原料

Table 6-1 に本実験で用いた試薬を示す。

Material	Chemical formula	Purity Manufacturer	
Barium diethoxide	$Ba(OC_2H_5)_2$	> 99 %	Kojundo Chemical Lab.
Titanium tetra-iso-propoxide	Ti(O-i-C ₃ H ₇) ₄	99 %	Kojundo Chemical Lab.
Manganese di-iso-propoxide	$Mn(O-i-C_3H_7)_2$	99 %	Kojundo Chemical Lab.
Boron triethoxide	$B(OC_2H_5)_3$	> 99.9 %	Kojundo Chemical Lab.
Ethanol (dehydrated)	C ₂ H ₅ OH	> 99.5 %	Kanto Chemical
2-Mathoxyethanol	CH ₃ OCH ₂ CH ₂ OH	> 99 %	Kanto Chemical

Table 6-1. List of reagents used in this chapter.

6.2.2 実験手順

第5章と同様に、ゾルゲル法により5nm程度のチタン酸バリウムナノクリスタルを合成 し、ナノ粒子堆積法による薄膜形成に必要なチタン酸バリウムスラリーを作製した。ただ し、ホウ素の添加方法として、Ba源、Ti源などとの同時添加の場合と、チタン酸バリウム ナノクリスタルを合成したのちのスラリー化の際に添加する場合(後添加)との二つの方法 により得られるスラリーの差異を比べた。以下に、それぞれの場合のチタン酸バリウムス ラリーの作製方法を示す。

ホウ素同時添加の場合

バリウムジェトキシドとテトライソプロポキシチタンを等モル量で秤量し、エタノール 25 cm³と2メトキシエタノール6 cm³の混合溶液中に溶解させ、0.5 mol/dm³の濃度の前駆体 溶液を作製した。さらに、トリエトキシホウ素をチタン源に対して所定の濃度で加えた。 また、薄膜作製時には、前駆体溶液にチタン源に対して 0.25 at%の濃度でマンガンジイソプ ロポキシドを混合しリーク特性の向上を図った。得られた前駆体溶液を室温下で 16 時間攪 拌させることで各試薬を完全に溶解させた。ここまでの作業は、各アルコキシドの水分と の反応を避けるため、N₂ 置換されたグローブボックス内にて行った。得られた前駆体溶液 に、25 ℃に保持した状態でエタノールと水の混合溶液を滴下し、加水分解を行ったのち、 50 ℃のオイルバス中でエージングを1日間行った。加水分解により、重合反応が進み前駆 体溶液は完全にゲル化し、50 ℃でのエージングにより、ゲル内から水分が吐き出されてゲ ルの収縮が起こり、結晶化が完了する。以上の工程により、ホウ素添加チタン酸バリウム ナノクリスタルまたはホウ素-Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルを合成した。

得られたゲルを溶媒から取り出し、3 wt%の濃度で2メトキシエタノール中に加え、90分間超音波照射を行うことで、ゲルを解してナノクリスタルが分散した透明溶液を得た。これを、ホウ素同時添加チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーとした。

② ホウ素後添加の場合

ゾルゲル法によるチタン酸バリウムゲルを得る工程までは第5章と同様である。バリウムジェトキシドとテトライソプロポキシチタンを等モル量で秤量し、エタノール25 cm³と2メトキシエタノール6 cm³の混合溶液中に溶解させ、0.5 mol/dm³の濃度の前駆体溶液を作製した。また、薄膜作製時には、前駆体溶液にチタン源に対して0.25 at%の濃度でマンガンジイソプロポキシドを混合しリーク特性の向上を図った。得られた前駆体溶液を室温下で16時間攪拌させることで各試薬を完全に溶解させた。ここまでの作業は、各アルコキシドの水分との反応を避けるため、N₂ 置換されたグローブボックス内にて行った。得られた前駆体溶液に、25℃に保持した状態でエタノールと水の混合溶液を滴下し、加水分解を行ったのち、50℃のオイルバス中でエージングを1日間行った。加水分解により、重合反応が進み前駆体溶液は完全にゲル化し、50℃でのエージングにより、ゲル内から水分が吐き出されてゲルの収縮が起こり、結晶化が完了する。以上の工程により、チタン酸バリウムナノクリスタルまたは Mn イオン添加チタン酸バリウムナノクリスタルを合成した。

あらかじめ、トリエトキシホウ素をチタン源に対して所定濃度分計り取り、2メトキシエ タノールに加えて攪拌し、溶解させた。ホウ素源が溶解された2メトキシエタノールに3wt% の濃度でチタン酸バリウムゲルを加え、90分間超音波照射を行うことで、ゲルを解してナ ノクリスタルが分散した透明溶液を得た。これを、ホウ素後添加チタン酸バリウムナノク リスタルスラリーとした。

次に、チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを用いた薄膜形成手順を示す。

基板には、(0001)一軸配向性のサファイア基板を用いた。また、下部電極に使用する金属 として Pt を選定した。あらかじめサファイア基板上に TiO₂ アモルファス相を 2 nm 程度で スパッタリングにより成膜してバリア層とし、この上に、アルゴン雰囲気中において 250 nm の厚みで Pt をスパッタリングにより成膜し、Pt/TiO₂/Al₂O₃ 下部電極を作製した。

得られた下部電極基板上に各チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーをスピンコーティングにより塗布した。スピンコーティングは 1000 rpm で 30 秒間行った。その後 500 ℃ に加熱したホットプレート上に基板を乗せて溶剤の乾燥を行い、スピンコート・乾燥を 5 回 繰り返した。スピンコート・乾燥工程を 5 回繰り返したのち、大気雰囲気下で 800 ℃10 分 間熱処理を行った。以上の工程を 5~6 回繰り返し、合計 25~30 層のチタン酸バリウム誘電 体薄膜を得た。特性評価の際には、Mn イオン添加チタン酸バリウム誘電体膜上に上部電極 として Pt を 200 nm の厚さでスパッタリング法により成膜した。

6.2.3 評価

得られた粒子、薄膜の評価を以下に示す方法により行った。

1) X 線回折

得られた粉末試料の生成相および結晶性の評価は、粉末 X 線回折装置(XRD, リガク RINT2500)により行った。測定条件は、線源 CuKa、電圧 50 kV、電流 100 mA、ステップ角 0.02°、測定 20 範囲 20 – 90°とした。また、作製した誘電体薄膜の結晶相および結晶配向の 評価は、薄膜 X 線回折装置(MRD, PANalytical X'pert)により行った。測定条件は、線源 CuKa、 電圧 45 kV、電流 40 mA、ステップ角 0.001°、測定 20- ω 範囲 20 – 90°とした。誘電体薄膜の 結晶配向評価は、X 線極点測定により行った。ある結晶の 20- ω ピークに対して、psi と phi をスキャンすることで pole figure を取得した。

2) 形態観察

粒子および薄膜の形態観察は、走査型電子顕微鏡(FE-SEM, 日立 S-4500, ZEISS SUPRA35VP)と透過型電子顕微鏡(FE-TEM, 日本電子 3000F, 日本電子 2100F)を用いて評価 した。観察を伴う組成分析にはエネルギー分散型 X 線分析装置(EDS)を用いた。

3) 粒度分布測定

ナノクリスタルスラリーの粒度分布は、あらかじめ超音波で充分に分散させた後、ナノ トラック粒度分布測定装置(UPA,日機装 UPA-EX150)を用いることにより、動的光散乱法を 測定原理として測定した。

4) 電気特性評価

0.5 mmφの Pt を誘電体薄膜上にスパッタリングにより成膜し、上部電極とした。リーク 電流特性は、40 に基板を温め、R6246pA(Advantest)により各電圧に印加したのち1秒後の 値を読み取った。誘電率評価は、HP4284A LCR(Agilent Technologies)により周波数10 kHz、 振幅 100 mV、印加電圧 0 V として AC シグナルを読み取った。

6.3 実験結果と考察

6.3.1 ホウ素同時添加チタン酸バリウムナノクリスタルのキャラクタリゼーションおよび薄膜形成

ゾルゲル法によりチタン酸バリウムナノクリスタルを合成する際に、原料と同時にホウ 素を添加した場合に得られる生成物の同定を行った。ホウ素は、チタン源に対して 10 mol% 添加した。この添加量は、「6.1.2 焼結助剤の添加による粒成長の促進と Cu 変形の抑制」内 に述べた福岡工業技術センターで報告されているホウ素添加チタン酸バリウム薄膜の検討 において、誘電率の向上が見られた添加量である。ホウ素を添加してもゾルゲル工程中の 溶液の状態変化は無添加時と同様であり、加水分解による縮重合によるゲル化、離液収縮 による液とゲルの分離などを経て、生成物が得られた。得られたゲルをエタノール中に加 えて超音波を照射することで分散させ、TEM 観察用グリッドに滴下して TEM により生成物 の形態観察を行った結果を Figure 6-4 に示す。ホウ素無添加時と同様の 5 nm 程度の粒子が 分散性良く得られており、高分解能像(Figure 6-4(b))からは格子縞が明確に見られる結晶性 の高いナノクリスタルが観察された。また、ゾルゲル法により合成したゲルを乾燥させて 粉末状にし、XRD 測定を行った結果を Figure 6-5 に示す。これより、生成物は立方晶チタ ン酸バリウム単相で得られており、ホウ素を添加することで二次相が形成されることは無 かった。



Figure 6-4. SEM images of boron added BaTiO₃ nanocrystals.



Figure 6-5. XRD pattern of boron added BaTiO₃ nanocrystals.

次に、ホウ素添加チタン酸バリウムナノクリスタル内にホウ素が存在するか否かを同定 するため、電子エネルギー損失分光法(EELS; Gatan co. Itd., GIF Tridiem)により測定を行った (Figure 6-6)。その結果、ナノクリスタル存在箇所においては、カーボンの Ka ピークの左端 にホウ素ピークに由来すると考えられる肩が見られたのに対し、ナノクリスタルが存在し ていない箇所では、カーボンの Ka ピークは左右対称であり、ホウ素の存在は認められなか った。以上の結果より、ホウ素はチタン酸バリウムナノクリスタルの結晶格子内もしくは 結晶表面にイオンやガラス相などとして存在することが示唆された。





以上のように、ホウ素をゾルゲル合成時に同時添加しても、5 nm 程度のチタン酸バリウ ムナノクリスタルが得られることが確認された。このナノクリスタルを 2 メトキシエタノ ールに加えて超音波照射して分散液を作製したところ、UPA による粒度分布測定結果から、 ホウ素の有無に関わらず、5 nm のチタン酸バリウムは単分散の状態を保持していることが わかった。


Figure 6-7. Particle size distribution of BaTiO₃ nanocrystal slurry measured by UPA; (a) non-doped BaTiO₃ 5 nm slurry and (b) boron doped BaTiO₃ 5 nm slurry.

ホウ素同時添加 5 nm チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを、実験手順に示した方 法で Pt/Al₂O₃ 基板上に塗布・乾燥・熱処理を行い、薄膜を形成した結果を以下に示す。

ホウ素の添加有無によって、Pt/Al₂O₃ 基板上での 5 nm 粒子の粒成長挙動が異なっていた。 Figure 6-8 にホウ素添加有無、熱処理温度変化による薄膜表面の SEM 像を示す(1 セット成 膜後)。ホウ素添加無しのチタン酸バリウムスラリーを用いた場合は、Figure 6-8(c)に示すよ うに 800 ℃以上での熱処理によりナノクリスタルの粒成長が進み、それ以下の熱処理では 5 nm 粒子から 10 nm 程度への若干の粒成長はあるものの、Figure 6-8(a)に示すように所望の 下地基板界面からの粒成長は適わなかった。それに対し、ホウ素同時添加チタン酸バリウ ムスラリーを用いた場合は、ホウ素無しで成長しなかった 750 ℃での熱処理により粒成長 が確認された(Figure 6-8(b))。以上の結果より、ホウ素の添加により、50 ℃程度の粒成長温 度の低温化が達成された。



Figure 6-8. SEM images of BaTiO₃ thin film surface; (a) non-doped BaTiO₃ after annealed at 750 °C, (b) boron doped BaTiO₃ after annealed at 750 °C, and (c) non-doped BaTiO₃ after annealed 800 °C.

ホウ素添加有無のスラリーを用いて、成膜・乾燥・800 ℃での熱処理を 1 セットとして繰 り返し、6 セット合計 30 層のチタン酸バリウム層を形成して薄膜を作製した。表面の SEM 像からは、ホウ素の有無によらず 5 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルが大きく粒成長 し、150-200 nm 程度の粒子が緻密に詰まった薄膜が形成されていた(Figure 6-9)。表面像か ら異相の形成は確認されず、薄膜の XRD 測定を行った結果からも、チタン酸バリウム単相 が確認された(Figure 6-10)。チタン酸バリウムの(110)ピークの半値幅を比較すると、ホウ素 添加無しで 0.3637°、ホウ素添加有りで 0.3651°であり、若干格子の膨張が見られた。このこ とから、薄膜形成後には、ホウ素はチタン酸バリウム格子内に存在し、異相の形成などに は寄与しないことが示唆された。



Figure 6-9. SEM images of 6 set formed films surfaces; (a) and (b) boron-doped BaTiO₃ thin film, (c) and (d) non-doped BaTiO₃ thin film.



Figure 6-10. XRD patterns of 6set formed BaTiO₃ thin films.

以上の薄膜上に Pt を上部電極として成膜し、誘電特性評価を行ったところ、ホウ素添加 有りの薄膜では、素子がすべて短絡してしまい、評価に至らなかった。その原因として、 ホウ素添加量が多すぎることが原因と考えられる。今回は、ゾルゲル合成時にホウ素を添 加したが、得られた 5 nm ナノクリスタルの同定から、ホウ素がチタン酸バリウム格子内に 存在することが示唆された。したがって、ホウ素がチタン酸バリウム格子内での不純物と して働き、チタン酸バリウム層の絶縁性の低下を引き起こしたと考えられる。ホウ素の同 時添加により粒成長温度の低温化を達成することは出来たが、チタン酸バリウム層の絶縁 性への影響を考慮すると、ホウ素同時添加における添加量の最適化を行うことよりも、添 加タイミングの変更により、ホウ素がチタン酸バリウムの絶縁性に影響を与えない状況を 作り出すことのほうが先決と考え、ホウ素同時添加の検討は一旦保留とし、次の検討に進 むこととする。

6.3.2 ホウ素-Mn 添加チタン酸バリウム薄膜形成

実験手順に示したように、あらかじめゾルゲル法により 5 nm チタン酸バリウムナノクリ スタルゲルを合成し、2 メトキシエタノールにゲルを加える段階でトリエトキシホウ素を添 加し、ホウ素後添加チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを作製した。得られたスラ リーは、沈殿を生じることも無く、5 nm チタン酸バリウムが単分散に分散した状態を保持 していた。このスラリーを用いて Pt/Al₂O₃ 基板上に成膜し、薄膜を形成した。ホウ素の添加 量は、文献^[6,3-7]を参考に、チタン酸バリウムに対して 0.25 mol%とした。また、薄膜形成の のちのリーク特性を向上させるために、第 5 章で述べた Mn イオン添加チタン酸バリウムナ ノクリスタルを用いた。スピンコート・500 ℃ホットプレート上での乾燥を 5 回繰り返した のち(1 セット成膜後)、700 ℃, 750 ℃, 770 ℃, 790 ℃の各温度で熱処理を行った。その結果、 Figure 6-11 に示すように、ホウ素の添加有無により、5 nm チタン酸バリウムナノクリスタ ルの粒成長挙動に変化が見られた。6.3.1 で示したホウ素同時添加 5 nm チタン酸バリウムナ ノクリスタルの粒成長挙動と同様に、ホウ素を添加したスラリーを用いた薄膜は、750 ℃ 以上での熱処理で粒成長し始めることが確認された。Mn イオンのみを添加した薄膜では、 いずれの温度で熱処理しても、50 nm 程度の粒成長に留まり、基板界面からの粒成長は叶わ なかったが、ホウ素を添加した薄膜においては、770 ℃以上の熱処理で200 nm 以上の粒子 も観察され、基板上で緻密化していることがわかった。

以上の結果より、熱処理温度低下を目指したホウ素添加は、その効果を発揮することが 確認され、今後、Cu下部電極基板を用いて、750 ℃程度での熱処理を行い、Cu 電極薄膜の 変形を受けることなく緻密なチタン酸バリウム薄膜を形成することが可能と考えられる。 本章においては、Cu 電極基板上でのチタン酸バリウム薄膜の形成についてではなく、ホウ 素-Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜の微細構造・特性への影響を調べるため、熱処理温 度はこれまでと同様の 800 ℃とし、電極基板として Pt/Al₂O₃を用いて、第5章で論述した Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜との比較を行うこととした。以下には、ホウ素-Mn イ オン添加チタン酸バリウム薄膜を所定の成膜回数で形成し、各種評価を行った結果を示す。



Figure 6-11. SEM images of; (a), (c), (e), and (g) boron and Mn doped and (b), (d), (f), and (h) Mn doped BaTiO₃ thin films annealed at each temperature of 700 - 790 °C.

ホウ素0.25 mol%添加チタン酸バリウムスラリーをPt/Al₂O₃基板上に塗布して500 ℃での 乾燥を5回繰り返したのち、800 ℃で熱処理を行う工程を1セットとし、6セット、9セッ ト、12セットの3種類のチタン酸バリウム薄膜を形成した。その結果、Figure 6-12 に示す ように、チタン酸バリウムは大きく粒成長し、特に9セット以上の熱処理では、下地基板 の結晶配向の影響を受けたと考えられる三角形の形状を取った300 nm 以上の粒子が多く観 察されており、高い結晶性のチタン酸バリウム薄膜が形成されたものと予想された。6セッ ト薄膜ではところどころ粒界に沿ってクラックが入っていたが、9セット、12セット薄膜 にはクラックがほとんど見られず、300 nm 以上の大粒子の隙間に150-200 nm 程度の比較 的小さな粒子が埋まり緻密膜を形成していることが確認された。最終的に得られた薄膜の 膜厚と充填率を Table 6-2 にまとめた。充填率は、ホウ素無添加時と同様に約90%以上と非 常に高い値を保持していた。ただし、膜厚はホウ素無添加時と異なり、ホウ素無添加す ることで211 nm にまで低下していた。これは、ホウ素添加によりチタン酸バリウムナノク リスタルの粒成長が促進されて緻密化が進み、ホウ素無添加時よりも密に詰まった薄膜が 形成されたためと考えられる。



Figure 6-12. SEM images of boron-Mn added BaTiO₃ thin films surface structure of; (a) 6 set formed, (b) 9 set formed, and (c) 12 set formed films.

Table 0-2. Phill thekness and fifting fate of each fifth.		
Formed set number	Film thickness (nm)	Filling rate (%)
6 set	211	94.6
9 set	338	89.4
12 set	412	97.7

Table 6-2. Film thickness and filling rate of each film.

得られた薄膜の結晶型を同定するため、XRD 測定を行った。Figure 6-13 に 12 セット終了 後の薄膜の XRD 測定結果を示す。この結果より、得られた薄膜は立方晶のチタン酸バリウ ム単相で存在することが確認された。特に、(110)と(111)のピークが強く、ホウ素を添加す ることで、結晶性の増大のみならず、結晶配向性も強くなっていることが示唆される。な お、6 セット、9 セット薄膜もほぼ同様の XRD パターンとして得られた。また、チタン酸 バリウム(111)ピーク位置を、ホウ素添加有無により比較した結果を Figure 6-14 に示す。ホ ウ素の有無・膜厚の変化によらず、ピーク位置はほとんど変わらず、ホウ素がチタン酸バリ ウム結晶格子に対して格子の膨張・縮小などの影響を与えていないことが確認された。



Figure 6-13. XRD pattern of boron-Mn added BaTiO₃ thin film.



Figure 6-14. BaTiO₃ (111) peaks measured by XRD.

次に、結晶配向を調べるため、XRD 測定により極点図形を取得したところ、Figure 6-15 に示すように、いずれの薄膜も基板に対して垂直方向の配向のみならず、面内配向も揃っ ていることが確認された。ホウ素無添加薄膜では、Mn イオンの添加有無に関わらず、Pt 基 板に対して垂直方向に(110)と(111)に優先配向していたものの、面内の配向については、規 則性を持たず、ランダムな配向を示したのに対し、ホウ素を添加することで、基板上での 粒成長が促進され、面内の配向が揃ったものと考えられる。



Figure 6-15. Pole-figures of boron-Mn added BaTiO₃ (110) peak; (a) 6set, (b) 9 set, and (c) 12 set.

ここまでの結果より、ホウ素添加チタン酸バリウム薄膜が高い配向性を有することが確認された。以下には、薄膜の断面微細構造を TEM 構造解析した結果を示す。まず、低倍に て薄膜の全体像を撮影したところ(Figure 6-16(a))、チタン酸バリウム層はホウ素無添加時と 同様に、1 層 1 粒子状に柱状構造を取った緻密な膜を形成していることが確認された。チタ ン酸バリウム層部分を拡大すると、Figure 6-16(b)に示すように、基板に対して水平方向に欠 陥(ナノツイン)が入っていることがわかる。このような欠陥は、ホウ素無添加薄膜では観察 されたことが無かった。欠陥は、結晶性の高い薄膜などによく見受けられることから、XRD 測定結果と同様に、ホウ素添加薄膜でいかに結晶性の高い薄膜が得られたかがわかる。ま た、BaTiO₃/Pt 界面付近の高分解能 TEM 像より、Pt 層とチタン酸バリウム層の結晶方位を 調べたところ、XRD 測定結果と同様に、Pt の配向の影響を受け、[111]方向に配向している 様子が確認された(Figure 6-17)。



Figure 6-16. Cross-sectional TEM image of boron-Mn added BaTiO₃ thin film.



Figure 6-17. High resolution TEM image of the interface between BaTiO₃ and the Pt layers.

ホウ素の存在状態を調べるため、STEM-EELS 元素マップにより、ホウ素の分布を同定した(Figure 6-18)。Figure 6-18(b)に示すように、確かにチタン酸バリウム層からホウ素のロス ピークが検出された。また、元素マップ(Figure 6-18(c))からは、薄膜下部ほど膜厚が増加す るため、プラズモンピークが強く、ホウ素のロスピークが弱くなってしまっているが、お およそホウ素が均一に分布していることがわかった。このことから、ホウ素は偏析するこ となく、チタン酸バリウム層に均一に分布しているものと考えられる。ただし、ホウ素の 吸収端位置を見ると、純粋なものでは188 eV にロスピークを有するが、今回の薄膜では181 eV にロスピークが検出された。同時に測定を行ったチタンのロスピークのピークシフトに 比べてシフトが大きいため、測定時の誤差とは言い切れない。一般的に EELS におけるピー クシフトの要因として、以下の2 つが考えられる。

- 酸化数が増加すると化合物の金属イオンから価電子が取り去られ、核の遮蔽を減少させる。遮蔽が弱くなると原子核の有効核電荷が増加し、内殻準位は収縮する。したがって、 内殻準位の束縛エネルギーが増加し、吸収端のエネルギーも増加する。
- 内殻電子励起によって内殻準位に正孔が作られると、価電子は正孔を遮蔽するために核のほうに引っ張られる。したがって、フェルミレベルが低エネルギー側にシフトし、吸収端のエネルギーが減少する。

以上の理由から、原子の価数変化により内殻電子のエネルギー準位が変化するためにロス ピークの化学シフトが起こることがわかる。ホウ素は、価電子を3個持ち、他の原子と共 有結合することで化合物を形成する。このとき、ホウ素は最外殻に6個しか電子を持たず、 閉殻構造を取ることができない。この空の部分に酸素や窒素などの非共有電子対が配位結 合することでホウ素は閉殻し安定化する。本研究により作製したホウ素添加チタン酸バリ ウム誘電体薄膜においても、ホウ素はチタン酸バリウム結晶中の酸素と弱い結合力で配位 しており、閉殻構造を取っているのではないかと予想される。ホウ素が酸素などと配位結 合することにより、内殻電子が原子核に引き寄せられる力は弱くなり、内殻準位と伝導帯 の底のエネルギー差が小さくなる。その結果、EELSの内殻電子励起スペクトルの立ち上が りエネルギーは低エネルギー側にシフトする。Figure 6-18(b)に見られたホウ素の吸収端位置 の低エネルギー側へのシフトも、以上の理由で生じたのではないかと考えられる。以上の 考察より、ホウ素は偏析することなくチタン酸バリウム結晶に配位し、熱処理によるチタ ン酸バリウムナノクリスタルの結晶成長を促進させたと考えられる。



Figure 6-18. (a) STEM image of the BaTiO₃ thin film, (b) EELS spectrum of the square in (a), (c) elemental map of the boron K and (d) elemental map of the titanium L.

次に、得られたホウ素-Mnイオン添加チタン酸バリウム誘電体薄膜の電気特性を評価した 結果を示す。6セット薄膜では、素子すべてで短絡してしまい、誘電特性を測るに至らなか った。粒界からのリークパスが原因と考えられる。Figure 6-19に比誘電率の周波数依存性、 Figure 6-20に10 kHzにおけるC-V特性を示す。10 kHzにおける比誘電率・誘電損失は、9セッ ト薄膜で£1107、tanδ3.4%であったのに対し、12 set薄膜で£1100、tanδ 2.7%であった。比誘 電率は膜厚の変化によらずほぼ同様であったが、誘電損失は膜厚増加に伴い減少した。そ の原因としては、粒界リークが膜厚増加により抑制されたためと考えられる。Figure 6-21に 示したI-V特性からも、膜厚増加によりリーク特性が向上されたことが確認され、12セット 薄膜では耐電圧が±30Vと非常に良好な値を示すことがわかった。ホウ素無添加(Mnイオン添 加)薄膜では耐電圧は±20V程度だったため、ホウ素添加によりさらに向上したことになる。 また、比誘電率に関しても、Mnイオン添加チタン酸バリウム薄膜ではε728であり、ホウ素 添加により300近くも向上することが確認された。



Figure 6-19. Frequency dependence of permittivity and dielectric loss tangent; (a) boron-Mn doped 9 set BaTiO₃ thin film and (b) boron-Mn doped 12 set BaTiO₃ thin film.



Figure 6-20. Dielectric constant and dielectric loss tangent; (a) boron-Mn doped 9 set BaTiO₃ thin film and (b) boron-Mn doped 12 set BaTiO₃ thin film.



Figure 6-21. Leakage current density; (a) boron-Mn doped 9 set BaTiO₃ thin film and (b) boron-Mn doped 12 set BaTiO₃ thin film.

ホウ素添加により誘電率が向上した原因として二点が考えられる。ひとつは、ホウ素添 加によりチタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長が促進され、熱処理後に得られるチタ ン酸バリウムのグレインサイズが400 nm以上と非常に大きくなり結晶性が増大したこと、 また、Figure 6-22に示したように、Pt基板界面からの粒成長が促進され、非常に高い配向性 を有する薄膜が得られたことなどが挙げられる。もうひとつの原因として考えられること は、チタン酸バリウム薄膜に生じる応力の緩和である。Figure 6-22に、12セット薄膜に対し てXRD測定を行った際、チタン酸バリウム(110)ピーク部に合わせ、プサイ角0,35°と変化さ せた場合の結果を示す。プサイ角が大きくなるほど格子面間隔は小さくなっており、薄膜 には残留応力として圧縮応力が掛かっていた。第5章で述べたように、Mnイオン添加チタン 酸バリウム薄膜では引張応力が掛かっていたのに対し、ホウ素を添加した薄膜では圧縮応 力に変化しており、比誘電率が増加した原因として、面内応力差による電歪効果によるも のと考えられる。なお、電歪効果については第5章に詳細を述べた。ホウ素無添加では引張 応力が掛かっていた薄膜だったにも関わらず、ホウ素添加により圧縮応力に変わった原因 として、ホウ素の液相としての効果が考えられる。つまり、ホウ素添加により低い温度で の熱処理によりチタン酸バリウムの粒成長が起こることを述べたが、熱処理後の降温時も 同様に比較的低い温度までチタン酸バリウム相に流動性が残ると推測される。これにより、 下地基板の熱膨張による影響を受けにくくなり、チタン酸バリウム層に掛かる残留応力が 変化したものと考えられる。



Figure 6-22. BaTiO₃ (110) peak measured by XRD; psi=0, 35°.

6.4 結論

Cu 薄膜を下部電極として使用すると、熱処理により変形が生じる。チタン酸バリウムス ラリーの成膜方法に着目し、スピンコート回転数やスラリー濃度を変化させることで熱処理 後の Cu 変形抑制を試みたが、基板からの粒成長と Cu 変形抑制を両立させて達成すること は困難であった。そこで、Cu 変形抑制のため、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長 温度を低下させることを目的に、焼結助剤としてチタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長 加方法として、第一に、ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノクリスタル合成時に同時添 加を行ったところ、無添加時と同様に 5 nm 程度の粒子が単分散性を有した状態で得られ、 ホウ素の偏析なども見られなかった。薄膜形成後に熱処理を行ったところ、ホウ素添加薄膜 では、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長温度は、50 ℃程度低温化できることが確 認された。ホウ素添加方法として、5 nm チタン酸バリウムナノクリスタル合成後にスラリ ー中に添加した場合も同様に、薄膜形成後の熱処理による粒成長温度は 50 ℃程度低温化で きることがわかった。また、粒成長が促進されたことで、基板界面からの粒成長が促進され、 面内配向を有する高結晶性の薄膜が得られることが確認された。結晶性の増大と、チタン酸 バリウム粒子の流動性の上昇による応力緩和により、薄膜の比誘電率は ɛ1100 程度と、無添 加時と比較して 300 程度向上することが確認された。

今後の展開として、ホウ素添加チタン酸バリウムナノクリスタルスラリーを Cu 電極基板 上に塗布して低温での熱処理を行い、Cu 変形の抑制とチタン酸バリウムナノクリスタルの 粒成長を両立させ、Cu 電極基板上で安定した薄膜形成を行うことが挙げられる。

参考文献

- [6.1] 柳田博明『微粒子工学大系<第1巻>基本技術』 フジ・テクノシステム, 2001, 135-138.
- [6.2] 有村雅司,牧野晃久,藤吉国孝,山下洋子,福岡工業技術センター成果報告書,2003.
- [6.3] J. F. Ihlefeld, W. J. Borland, and J. P. Maria, Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1199-1203.
- [6.4] J. Q. Qi, W. P. Chen, Y. Wang, H. L. W. Chan, and L. T. Li, J. Appl. Phys. 2004, 96, 6937-6940.
- [6.5] S. I. Jang and H. M. Jang, *Thin Solid Films* 1998, 330, 89-95.
- [6.6] I. C. Ho, J. Am. Ceram. Soc. 1994, 77, 829-832.
- [6.7] J. Q. Qi, Y. Wang, W. P. Chen, and H. L. W. Chen, Jpn. J. Appl. Phys. 2003, 42, L1516-L1518.

第7章

結言

第7章 結言

7.1 本研究で得られた成果

以上のように、6章にわたり、湿式合成法によるチタン酸ナノ結晶の合成と応用について 検討を行った。本研究で得られた成果を以下にまとめる。

第1章では、研究背景として、溶液からの結晶成長法によるナノ結晶の形成メカニズムに ついて概説し、結晶の形態が決定されるまでのプロセスをまとめた。結晶成長から形態決 定に至るまで、溶液の過飽和度が重要なパラメータとなり、過飽和度を制御することによ り結晶形態までをも制御できる。この事実を基に、高分子ゲルを拡散律速場として使用す ることの意義を説明し、結晶成長の場としての可能性を考察した。さらに、対象とする材 料に、二酸化チタン、チタン酸ナノシート、チタン酸バリウムナノ結晶を掲げ、これらの 物性と、材料としての可能性、液相合成法による合成例をまとめた。液相合成法には、水 溶液からの結晶成長法のほかにも、ゾルゲル法や水熱法、ソルボサーマル法など様々な手 法が存在する。中でも、ゾルゲル法は結晶形成メカニズムが確立されており、特に高濃度 ゾルゲル法によりシングルナノスケールの高結晶粒子が得られるなど、その結晶成長メカ ニズムに学ぶことが多い。このため、高濃度ゾルゲル法により合成したチタン酸バリウム ナノ結晶を用い、誘電体薄膜への応用について検討したこれまでの研究結果を概説して、 本研究の意義を述べた。

第2章では、高分子ゲルマトリクスを反応場としたチタン酸ナノ結晶の合成について 論じた。寒天ゲルを反応場として用いることで、マクロからミクロに渡り、多様な形態を 有するチタン酸の合成に成功した。いずれも、5-10 nm のナノシートから構成されており、 ナノシートの集合体が球状や板状、針状などの二次形態を有していた。各種構造解析の結 果、ナノシートは、TiO₆ 八面体が2次元方向に成長した単層シートが、数層重なることで 形成されており、シート層間には原料由来のアンモニウムイオンの存在が示唆され、チタ ン酸アンモニウムと称される新規チタン酸ナノシートの合成に成功した。層状チタン酸塩 の層間剥離によるチタン酸ナノシートの作製に関する研究は、これまで報告されていたが、 本研究結果のように、イオン・分子からのボトムアップアプローチにより得られたチタン 酸ナノシートは極めて新規性の高い物質と言える。また、得られたチタン酸ナノシート層 間には、アンモニウムイオンとのイオン交換により各種カチオン性有機色素の導入が可能 だった。特に、メチレンブルーやトルイジンブルーなどの色素分子は、ナノシート層間で H 会合体という特殊な会合状態を取ることが確認された。多量の色素導入後にも、層間隔の 変化が見られなかったことから、シート層間が TiO₆ユニットによって一部連結しており、 多孔質構造が保持されているものと考えられた。さらに、350 ℃と比較的低温な熱処理で、 ナノシート形態を保持したままチタン酸からアナターゼ型二酸化チタンへの結晶転移が可 能だった。どちらも、結晶の基本構造が TiO₆八面体ユニットの連結により構成されている ため、チタン酸ナノシートの層間のアンモニウムイオンが熱により抜けることで層間隔が 狭まり、結晶型が変わったものと考えられる。また、層間のイオン交換により、ナノシー ト形態を保持した状態でのチタン酸バリウムへの構造転移が可能であることが確認された。

第 3 章では、第 2 章で見出した寒天ゲルマトリクスを反応場としたチタン酸ナノシート の合成に関する研究をさらに進め、アナターゼ型二酸化チタンと層状チタン酸の選択的合 成、さらに層状チタン酸の結晶形態制御について論じた。 アルカリ溶液の pH とカウンター カチオンの種類によって、層状チタン酸の結晶構造や形態に影響を与えることを見出した。 まず、チタン酸を得るためには、反応後の pH が 9 以上になるように高 pH のアルカリを、 さらに、チタン酸層間にカウンターイオンとして組み込まれるカチオンを多量に共存させ る必要があった。さらに、チタン酸が形成される条件においては、カウンターカチオンの 種類により、層状チタン酸の形態が異なった。アンモニア水溶液をアルカリとして用いた 場合、チタン酸層間にはアンモニウムイオンが存在し、5-10 nm のナノシート形態を取る ことが確認された。また、水酸化ナトリウムを用いた場合、チタン酸層間にはナトリウム イオンが存在し、直径 20 nm 程度の針状形態を取った。層間に存在するカウンターカチオ ンの種類により、シートに掛かる圧力が変化し、シート状で安定するもの・丸まって針状に なり安定化するものに分かれたものと考えられる。また、チタン前駆体含有寒天ゲル内の pHの上昇が充分でない場合、ゲル内にはアナターゼ型二酸化チタンが形成された。しかし、 寒天ゲルという、拡散の制限された反応場での生成により、特定の結晶面の成長が促され 針状形態を有する二酸化チタンが得られるなど、特異的な構造体が形成された。

第4章では、高濃度ゾルゲル法におけるチタン酸バリウムナノクリスタル合成について これまでの研究をまとめ、また、そこから考えられる合成メカニズムの妥当性を実験によ り検証した。その結果、高濃度ゾルゲル法におけるチタン酸バリウム合成時には、あらか じめ形成された TiO₆ 八面体構造中にバリウムが拡散することにより結晶化することが確認 された。実際に、チタンアルコキシドを加水分解させた後に系内にバリウム源を加えても チタン酸バリウムが形成されること、チタン源として小粒径の二酸化チタンを用いてもチ タン酸バリウムが形成されることなどからも、妥当なメカニズムと考えられる。また、バ リウム源の変更を試みたところ、水酸化バリウム八水和物を用いることで、バリウムアル コキシドと同程度の小粒径粒子が得られることが確認された。ただし、溶媒内での解離が 難しい酢酸バリウムを用いた場合にはチタン酸バリウムが得られなかったことから、バリ ウム源の選択も重要であることが示唆された。以上のように、チタン源、バリウム源とし てアルコキシド以外の安価な物質を用いた場合でも、種類の選択により、シングルナノレ ベルの小粒径チタン酸バリウムが形成されることが確認された。しかしながら、いずれの 場合にも、分散性が課題として残っており、高濃度ゾルゲル法で得られるチタン酸バリウ ムスラリーと同程度のものを得るには至らなかった。

また、第2章から第4章までの研究結果から、いずれの結晶成長においても、TiO 骨格に カチオンが関与することにより各結晶が形成されていることがわかった。第2.3 章では水溶 液からの結晶成長法を基に、第4章ではゾルゲル法を基に、層状チタン酸や二酸化チタン、 チタン酸バリウムナノ結晶の作製について検討しており、合成方法には差異があるものの、 いずれの結晶もアニオニックな TiO 骨格を形成したのちに、限られた合成条件範囲内にお いて Na⁺や NH₄⁺、Ba²⁺が TiO 骨格内に侵入することで各結晶が得られた。限られた合成条 件範囲とは、第2.3 章では、寒天ゲルを反応場として用いることによりゲル内の pH 制御が 可能になったことを指し、この pH 制御によって、水酸化物の形成を抑制してチタン酸を得 ることが可能になり、チタン酸構造内に Na⁺が入り込むことでナノチューブ形態が、NH4⁺ が入り込むことでナノシート形態となった。おそらく、Na⁺や NH4⁺に代わりプロトン H⁺を 作用させた場合には、チタン酸構造中和されることにより水酸化物、条件によっては二酸 化チタンが形成されるものと予想される。また、第4章では、ゾルゲル法での合成時に原 料濃度を高濃度化することで、高い過飽和状態を作り出したことを指し、この状態で加水 分解・縮重合が行われることで、TiO クラスターの形成とその中への Ba²⁺の侵入によるチタ ン酸バリウム結晶化が、シングルナノメートルスケールで行われることになった。以上の ように、本研究において様々な合成方法を用いることでチタン酸結晶の合成に関して検証 を進めた結果、いずれの結晶についても、アニオニックな TiO 骨格へのカチオンの関与が 示され、溶媒や反応場・原料などに違いがあっても、核形成・結晶成長の骨格は変わらない ということがわかった。

第5章では、チタン酸ナノシートのデバイス応用を視野に、適用先として最も可能性が 高いと考えられる誘電体薄膜に着目し、検討した結果を論じた。これまでの研究により、 高濃度ゾルゲル法から得られる5nm程度の高分散性チタン酸バリウムナノクリスタルスラ リーを用い、電極基板上で塗布・熱処理を繰り返すことで、一定の膜厚を有する誘電体薄膜 が形成された。この薄膜は、下部電極基板に対して結晶学的に配向する方位を向いたもの が隣接の粒子を取り囲みながら優先的に成長し、部分的に配向した柱状構造を有する緻密 膜となった。また、この薄膜は、10kHzにおける比誘電率は635、誘電損失は0.7%と、良 好な特性を有することが確認された。以上の結果を受け、本研究では、この誘電体膜の実 用化を図るため、下部電極基板のPtからCuへの変更を試みるべく、誘電体層に耐還元性 を付与することを目的とし、Mnイオンを添加したチタン酸バリウムナノクリスタルの作製 と、誘電体薄膜の形成を行った。その結果、ゾルゲル法を用いることで、Mnイオン添加5nm, 10 nm のチタン酸バリウムナノクリスタルが、粒径制御性良く合成できることが確認された。 Mn イオンは最大で Ti 源に対して 10 at%までチタン酸バリウム格子内に固溶していること が示唆された。また、Mn イオン添加チタン酸バリウム薄膜をナノ粒子堆積法により作製し たところ、Mn イオンを 1.0 at%以下の添加量とすることで、チタン酸バリウムナノクリスタ ルは熱処理により大きく粒成長し、一部結晶配向した柱状構造を有する薄膜を形成した。 Mn イオンはチタン酸バリウム格子内にて 2 価で存在し、アクセプターとしての機能が示唆 され、実際に Mn イオン 0.5, 1.0 at%添加チタン酸バリウム薄膜はリーク特性が大幅に改善さ れていた。また、Mn イオンの添加により比誘電率も向上していたが、その理由として、薄 膜に掛かる残留応力が緩和されたためと考えられる。また、(111)一軸配向 Cu/Al₂O₃ 電極基 板上においても、Mn イオン 0.5 at%チタン酸バリウムナノクリスタルは、熱処理により大 きく粒成長し、一部一軸配向結晶した柱状構造を有する薄膜が得られた。Cu 上でも Mn は 2 価でチタン酸バリウム格子内に存在することが示され、アクセプターとしての機能が示唆 された。ただし、Mn イオン添加量の検討が充分でなく、Cu 電極上でのリーク特性向上に は至らず、今後の課題として残った。

第6章では、第5章で得られた誘電体薄膜をさらに材料設計することで、高い電気特性を 有するチタン酸バリウム誘電体薄膜の作製に成功した事項について論じた。下部電極基板と して Cu を用いる際、Cu の熱耐性の低さのため、熱処理により薄膜状態を保持できず、容 易に変形してしまう場合が生じることが問題点として残る。そこで、Cu 薄膜の変形を抑制 するため、まず、チタン酸バリウムスラリーの成膜方法に着目し、スピンコート回転数やス ラリー濃度を変化させることで熱処理後の Cu 変形抑制を試みたが、基板からの粒成長と Cu変形抑制を両立させて達成することは困難だった。次に、Cu変形抑制のため、チタン酸 バリウムナノクリスタルの粒成長温度を低下させることを目的に、焼結助剤としてチタン酸 バリウムにホウ素を添加した。添加方法として、第一に、ゾルゲル法によるチタン酸バリウ ムナノクリスタル合成時に同時添加を行ったところ、無添加時と同様に5nm 程度の粒子が 単分散性を有した状態で得られ、ホウ素の偏析なども見られなかった。薄膜形成後に熱処理 を行ったところ、ホウ素添加薄膜では、チタン酸バリウムナノクリスタルの粒成長温度は、 50 程度低温化できることが確認された。ホウ素添加方法として、5 nm チタン酸バリウム ナノクリスタル合成後にスラリー中に添加した場合も同様に、薄膜形成後の熱処理による粒 成長温度は 50 ℃程度低温化できることがわかった。また、粒成長が促進されたことで、基 板界面からの粒成長が促進され、ホウ素無添加では優先配向に留まっていた配向性が、ホウ 素添加により面内配向を有する高結晶性の薄膜が得られることが確認された。結晶性の増大 と、チタン酸バリウム粒子の流動性の上昇による応力緩和により、薄膜の比誘電率は El100 程度と、無添加時と比較して 300 程度向上することが確認された。

7.2 今後の課題と展望

以上のように、チタン酸ナノ結晶の合成と応用について、6章に渡って論じた。いずれの 項目も、最終目的である実用化には至っていないが、今後、本研究で得られた知見を基に、 実用化の足がかりが出来れば幸いである。以下に、各章で得られた成果に対する課題と今 後の展望を示す。

まず、第2章、第3章で得られたチタン酸・二酸化チタンの高分子ゲルをマトリクスとした 合成に関しては、付加価値の非常に高い構造体の形成に成功したと言えるが、いずれも実 験室レベルでの合成である。高分子ゲル内での合成、高分子ゲルの溶かし出しなど、手間 と時間の掛かる本方法は、実用化には難しい。しかしながら、本研究で得られたエッセン スを用いれば、寒天ゲル内で得られた環境と同様の合成条件を作り出すことが可能となり、 チタン酸ナノシートの溶液内でのボトムアップ合成が達成されるものと期待している。ま た、チタン酸バリウムナノシートの合成に関しては、未達の状態である。第5,6章で論じた チタン酸バリウム誘電体薄膜の形成に際して、チタン酸バリウムナノシートはシード層と して必ずや高いポテンシャルを発揮することになると考えている。一日も早い実現が待た れる。

次に、第4章で得られた高濃度ゾルゲル法によるチタン酸バリウムナノ結晶の合成に関し ては、これまでに報告されているチタン酸バリウムの合成メカニズムをサポートする形に なった。より安価な材料で同程度のナノ結晶を合成するために、いくつかの検証を行った。 その結果、バリウム源、チタン源を変更しても、高濃度ゾルゲル法と同レベルの小粒径チ タン酸バリウムナノ結晶が得られることが明らかになった。今後は、分散性の改善を目指 し、分散剤の添加などの検討を行う必要がある。

また、第2章から第4章までの研究を通して、様々なチタン酸ナノ結晶の合成を試みたが、 いずれもTiO骨格へのカチオンの関与が示され、この基本を押さえることにより、様々なチ タン酸結晶のナノスケールでの合成・形態制御が可能になるのではないかと期待される。

最後に、第5章、第6章では、高濃度ゾルゲル法で得られたチタン酸バリウムナノ結晶を 用いて誘電体薄膜を形成した。電極基板の低コスト化を目指し、誘電体層の材料設計を行 ったが、いずれも予想通りに添加物が機能し、Cu電極基板の使用が現実味を帯びてきた。 また、副次効果として、誘電体層の高結晶化による電気特性の向上も見られ、今後ますま す本方法により形成した誘電体薄膜に期待が高まる。現状では、PVD法やCVD法、CSD法 により形成される誘電体薄膜で得られる特性には及ばない状況であるが、これらの方法で は、成膜や結晶化の際に行う熱処理に雰囲気制御を必要とするため、酸化防止のために還 元雰囲気での熱処理を必要とするCu電極の使用は困難である。これに対し、本研究により、 ナノ粒子堆積法を用いることによるCu電極基板上での薄膜形成の可能性を示すことができ、 今後必要となる薄膜作製技術の低コスト化に関しては、他の薄膜作製法に一歩リードして いると言える。今後さらに材料設計を進めることにより、高い特性を有する薄膜が形成さ れるものと考えられ、薄膜作製技術のひとつとして確立されることになると期待している。 上述した課題点を各項目に対して実践していくことで、実用性の高いチタン酸ナノ結晶 の合成に関する技術構築が進み、さらに、ナノ粒子堆積法で得られた誘電体薄膜の実用化 が達成されるものと考えられる。

本研究に関連する論文

【本論文に関連する原著論文】

- (1) <u>Takezawa, Y.</u> and Imai, H., "Bottom-up synthesis of titanate nanosheets with hierarchical structures and a high specific surface area", Small, Vol.2, pp. 390-393, (2006).
- (2) <u>Takezawa, Y.</u> and Imai, H., "Structural control on crystal growth of titanate in aqueous system: Selective production of nanostructures of layered titanate and anatase-type titania", J. Cryst. Growth, Vol.308, pp. 117-121, (2007).
- (3) <u>Takezawa, Y.</u>, Kobayashi, K., Nakasone, F., Suzuki, T., Mizuno, Y. and Imai, H., "Mn-doped BaTiO₃ thin film sintered using nanocrystals and its dielectric properties", Jpn. J. Appl. Phys., Vol.48, pp. 111408, (2009).
- (4) <u>Takezawa, Y.</u>, Ryu, M., Iwazaki, Y., Suzuki, T., Mizuno, Y. and Imai, H., "Effect of a boron additive on the microstructure and dielectric properties of BaTiO₃ thin films formed by nanocrystal deposition", Key Engineering Materials, Vol.22, pp. 277-280, (2013).
- (5) Imai, H., Ohgi, H., <u>Takezawa, Y.</u> and Yahiro, J., "Control of nanoscale morphology of oxide crystals using aqueous solution sytems", Key Engineering Materials, Vol.301, pp. 211-214, (2006).

【その他の論文】

 Imai, H., Tochimoto, N., Nishino, Y., <u>Takezawa, Y.</u> and Oaki, Y., "Oriented nanocrytal mosaic in monodispersed CaCO₃ microspheres with functional organic molecules", Crystal Growth and Design, Vol.12, pp. 876-882, (2012).

謝辞

本研究を進めるにあたり、私自身の至らなさのため、非常に長い年月を掛けてしまいま した。その間、いつも変わらず見守り、的確なご指導・ご指摘を下さった今井宏明教授に深 く感謝致します。ありがとうございました。また、本研究をまとめるにあたり、ご多忙中 にもかかわらず副査を引き受けてくださり、貴重なご意見を下さいました応用化学科の磯 部徹彦教授、藤原忍教授、緒明佑哉助教、化学科の栄長泰明教授に深く感謝致します。

本研究を進める機会を作ってくださった太陽誘電株式会社の茶園広一執行役員、水野洋 一部長、鈴木利昌課長に厚くお礼申し上げます。特に、誘電体薄膜に関する専門知識の乏 しかった私に、たくさんの知識を与えてくださった鈴木利昌課長に深く感謝しております。

また、実験を進めるにあたり、数々のご協力ご助言をくださいました太陽誘電株式会社 の岩崎誉志紀さん、川村知栄さん、谷口文さん、小林圭介さん、龍穣さんに厚くお礼申し 上げます。皆さんのご協力により、実験や解析が効率的に進められ、本研究を進展させる ことができました。

最後になりますが、育児中にも関わらず、このような機会を与えてくれた夫、夫の両親、 母親、姉に深く感謝致します。祐太、美佳、母ちゃん頑張ったよ!

> 平成 25 年 7 月 30 日 竹澤 洋子